

ตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุส่องความถี่ โดยใช้เรโซนเตอร์ร่วงແກວ
ร่วมกับອินເຕອർດິຈິດອລຄາປ້າຊີເຕອ້າ



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีการศึกษา 2561

**A DUAL-BAND METASURFACE USING RING
RESONATOR WITH INTERDIGITAL CAPACITORS**



**A Thesis submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Degree of master of Engineering in Telecommunication Engineering
Suranaree University of Technology**

Academic Year 2018

ตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุส่องความถี่ โดยใช้เรโซเนเตอร์วงแหวนร่วมกับ
อินเตอร์ดิจิตอลมาป่าซิเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกผลิน)

ประธานกรรมการ

(รศ. ดร.ปิยากรรณ์ มีสวัสดิ์)

กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

(รศ. ดร.มนต์พิพัฒ์ อาทารสกุล)

กรรมการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(ศ. ดร.สันติ แม่นศิริ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสาขาวิชา

(รศ. ร.อ. ดร.กนต์ชร ชำนิประสาสน์)

คณบดีสำนักวิชาชีวกรรมศาสตร์

กัณฐิกา รักด่านกลาง : ตัวสะท้อนผิวอวิสุดดูสองความถี่ โดยใช้เรโซโนเตอร์วงแหวนร่วมกับอินเตอร์ดิจิตอลคาปัซิเตอร์ (A DUAL-BAND METASURFACE USING RING RESONATOR WITH INTERDIGITAL CAPACITORS) อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์, 87 หน้า.

ในปัจจุบันการใช้งานระบบการสื่อสารไร้สายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการใช้งานของผู้ใช้บริการที่สูงขึ้น ทำให้ต้องการซ่องสัญญาณและอัตราขยายของสายอากาศที่เพิ่มขึ้น เพื่อรับรองการใช้งาน ซึ่งปัจจุบันมักจะพับกับปัญหาของการซ่อนทันกันของสัญญาณหรือรัศมีของ การแพร่กระจายสัญญาณที่ไปได้ไม่ไกลมากนัก ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการได้รับการใช้งานจากสายอากาศอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ เช่น คุณภาพของสัญญาณไม่ดี อัตราการดาวน์โหลด-อัปโหลด มีคุณภาพต่ำ การแก้ปัญหาดังกล่าวจึงนิยมออกแบบสายอากาศให้ทำงานได้หลายความถี่ และนำตัวสะท้อน (Reflector) มาใช้งานร่วมกับสายอากาศเพื่อให้มีอัตราขยายที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวสะท้อนมักมีขนาดใหญ่และสามารถรองรับได้เพียงความถี่เดียว ดังนั้นในวิทยานิพนธ์นี้จึงทำการออกแบบตัวสะท้อนผิวอวิสุดดูที่มีขนาดเล็กเพื่อรองรับการใช้งานสองความถี่สำหรับระบบ LTE (1.8GHz) และ WLAN (5.5GHz) โดยใช้เรโซโนเตอร์วงแหวนร่วมกับอินเตอร์ดิจิตอลคาปัซิเตอร์ เพื่อเพิ่มอัตราขยายของสายอากาศ ซึ่งผิวอวิสุดดูที่ออกแบบจะมีคุณสมบัติของค่าสภาระของไฟฟ้าเป็นลบ (Negative permittivity) โดยตัวสะท้อนผิวอวิสุดดูมีขนาดเล็กและให้อัตราขยายที่สูง ในงานวิจัยนี้ให้ความสนใจโครงสร้างพื้นฐานของผิวอวิสุดดูแบบเรโซโนเตอร์ วงแหวนที่มีการออกแบบให้เป็นอินพิดเคนซ์แบบขั้น เพื่อให้ควบคุมความถี่ทั้งสองได้ง่าย และได้นำเทคนิคօนเตอร์ดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อปรับลดขนาดของชิ้นงานให้เล็กลง ในวิทยานิพนธ์นี้จะจำลองสายอากาศโดยใช้โปรแกรม CST Microwave Studio 2016 เพื่อวิเคราะห์ผล ในส่วนของการวัดทดสอบจะสร้างสายอากาศได้โดยตัวตั้งแบบร่วมกับตัวสะท้อนผิวอวิสุดดู และเปรียบเทียบผลที่ได้จากการจำลองแบบและการวัดทดสอบ ซึ่งวิทยานิพนธ์นี้มุ่งหวังให้ตัวสะท้อนผิวอวิสุดดูสองความถี่ที่มีขนาดเล็ก และเมื่อประยุกต์ใช้งานกับสายอากาศ จะสามารถเพิ่มอัตราขยายของสายอากาศให้สูงขึ้นได้ 8.04 dB และ 9.14 dB ที่ความถี่ 1.8GHz และ 5.5GHz ตามลำดับ

KANTHIKA RAKDANKLANG : A DUAL-BAND METASURFACE
USING RING RESONATOR WITH INTERDIGITAL CAPACITORS.
THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. PIYAPORN MESAWAD, PH.D.,
87 PP.

METASURFACE REFLECTOR/METASURFACE STRUCTURE/
RING RESONATOR/ INTERDIGITAL CAPACITORS

Nowadays, the usability of wireless communication systems has increased significantly. The use of services has grown exponentially, resulting in the need for additional channel and antenna gain in order to support it. At present, there is often a problem of overlapping signals or low radius of signal propagation. This causes low-quality services resulting from the antenna performance, such as poor signal quality and low download/upload rates. To solve this problem, it is preferable to design an antenna that works on multiple frequencies and use a reflector to work with the antenna for higher gain. However, such a reflector is usually large and not support multiple frequencies. Therefore, this thesis was designed to present a small metasurface reflector to support dual frequencies for the LTE (1.8GHz) and WLAN (5.5GHz) systems by using the ring resonator structure together with the interdigital capacitors. A dual-band metasurface reflector was used to increase the gain of the antenna. The designed metasurface will demonstrate negative permittivity. The metasurface reflector is small and has high gain. In this research, the basic structure of the metasurface reflector was studied and focused on the ring resonator, which uses a step impedance structure for easy control of both frequencies. Subsequently, the interdigital capacitors technique was applied to reduce the size. In this thesis, the antenna was simulated by using CST

Microwave Studio 2016. For the measurement, a dipole antenna prototype was combined with the metasurface reflector for comparison of the simulated and measured results. The purpose of this thesis is to decrease the size of a dual-band metasurface reflector. When applied with an antenna, it will be able to increase the antenna's gain of 8.04 dB and 9.14 dB at 1.8 GHz and 5.5 GHz, respectively.

School of Telecommunication Engineering

Student's Signature नितेश

Academic Year 2018

Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ทั้งด้านวิชาการ และด้านดำเนินงานวิจัยจากบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ได้แก่องค์กรศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด รวมทั้งช่วยตรวจสอบและแก้ไข วิทยานิพนธ์เล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร ชุมทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เคยช่วยเหลือให้คำปรึกษา ช่วยซึ่งแนะนำแนวทางในการดำเนินงานวิจัย ช่วยแนะนำในด้านการค้นคว้าหาเทคนิคต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานวิจัยได้ถูกต้อง

รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุทารสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์พิพิญก้า อุทารสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวดี หัตถกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ทองทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืออากาศเอก ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐีวิทย์ ภูษณา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้ความรู้ทางวิชาการ และให้โอกาสในการศึกษา

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้าน ต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ดร.มงคล มีลุน กรรมสitol สวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักร ไทย ที่ให้ความอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือ ขอขอบคุณนายรชต แนวคันรัมย์และนายปณิธาน รุ่นเจริญ ที่ช่วยแนะนำในด้านการค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดา รวมถึงญาติพี่น้องของผู้วิจัย ทุกท่านที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ให้ความรักความอบอุ่น และให้การสนับสนุนทางการศึกษาอย่างดียิ่ง มาโดยตลอด อีกทั้งขอขอบคุณนายอุฤกษ์ ไชยวุฒิและนายทิวนันท์ อุญสุข รวมถึงเพื่อน พี่ ในสาขาวิชาโทรคมนาคมที่ช่วยให้คำแนะนำสำหรับเทคนิค การใช้โปรแกรมในการจำลองการทำงานและคอยเป็นกำลังใจให้เสมอมา สำหรับคุณงานความดีอันใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอขอบ ให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้วิจัยจนสำเร็จการศึกษาไปด้วยดี

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ(ภาษาไทย)	ก
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)	ข
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญ	จ
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูป	ญ
บทที่	
1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
1.3 สมมติฐานของการวิจัย	3
1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น	4
1.5 ขอบเขตของการวิจัย	4
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
1.7 นวัตกรรมของงานวิจัยนี้	4
1.8 การจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์	5
2 ปริทศน์วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 กล่าวนำ	6
2.2 ปริทศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
2.2.1 ตัวสะท้อน	7
2.2.2 ผิวอภิวัสดุ	8
2.2.2.1 แท่งโลหะประดิษฐ์	8
2.2.2.2 เรโซโนเตอร์วงแหวน	11
2.2.3 โครงสร้างที่รองรับการใช้งานได้หลายความต้องการ	14

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.3 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง	16
2.3.1 คุณสมบัติพิวอภิวัสดุ	16
2.3.2 เรโซนเนเตอร์ร่วงແหวาน	17
2.3.3 เรโซนเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้น	18
2.3.4 โหลดความจุแบบอินเตอร์ดิจิตอล	20
2.3.5 ทฤษฎีของสายอากาศ	21
2.3.5.1 การสัญเสียงจากการยื่อนกลับ	21
2.3.5.2 แบบรูปการแพ็พลังงาน	23
2.4 สรุป	24
3 การออกแบบ	25
3.1 บทนำ	25
3.2 การจำลองแบบสายอากาศ ได้โดย	25
3.3 การออกแบบตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ โดยพิจารณาฐานนิตรชลล์	31
3.3.1 การออกแบบโดยใช้เรโซนเนเตอร์ร่วงແหวาน	31
3.3.2 ศึกษาการออกแบบตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ โดยใช้เรโซนเนเตอร์ร่วงແหวาน 2 วงແหวาน	35
3.3.3 ศึกษาการออกแบบตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ โดยใช้เรโซนเนเตอร์ร่วงແหวานร่วมกับเทคนิคเรโซนเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้น	37
3.3.4 ศึกษาการออกแบบตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ โดยใช้เรโซนเนเตอร์ร่วงແหวานร่วมกับเทคนิคเรโซนเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้น และเทคนิค อินเตอร์ดิจิตอลค่าปาเซเตอร์	39
3.3.5 สรุปการศึกษาการออกแบบตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ	40
3.4 การวิเคราะห์สมการทางคณิตศาสตร์	40
3.5 การออกแบบตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ	42
3.6 การปรับพารามิเตอร์ของตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ	44

สารบัญ (ต่อ)

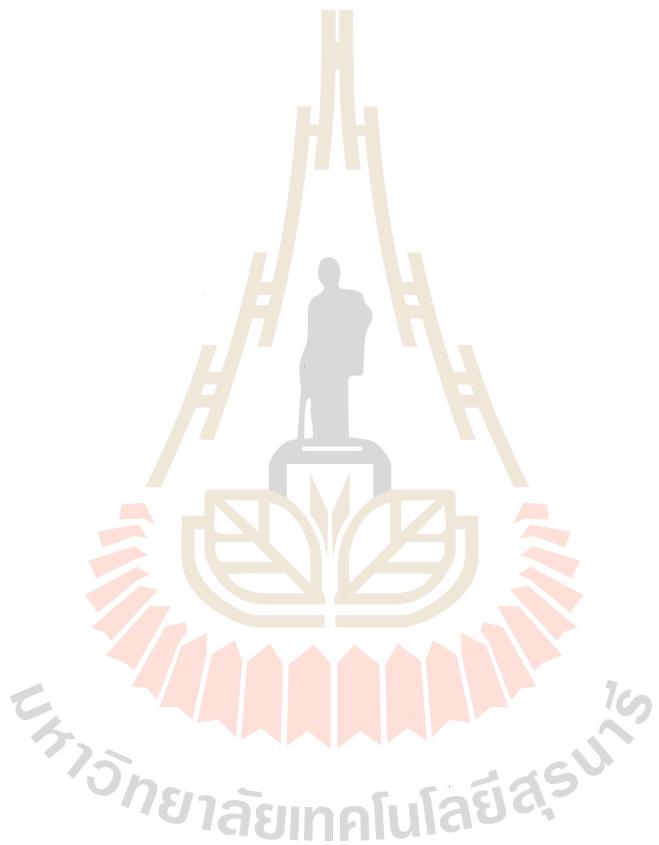
หน้า

3.6.1	การจำลองตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ์ที่นแบบด้วย การปรับขนาดความกว้าง.....	44
3.6.2	การจำลองตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ์ที่นแบบด้วย การปรับเพิ่มจำนวนฟันของอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าชิเตอร์.....	45
3.6.3	การจำลองตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ์ที่นแบบด้วยการปรับขนาดความกว้าง ของฟันในอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าชิเตอร์.....	46
3.6.4	การจำลองตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ์ที่นแบบด้วยการปรับขนาดความสูง ของฟันในของฟันในอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าชิเตอร์.....	48
3.6.5	การจำลองตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ์ที่นแบบด้วยการปรับขนาดของแกน ที่รองรับฟันของ อินเตอร์ดิจิตอลคาป่าชิเตอร์.....	49
3.6.6	การจำลองตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ์ที่นแบบด้วยการปรับระยะห่างของ ช่องว่างระหว่างที่รองรับฟันของ อินเตอร์ดิจิตอลคาป่าชิเตอร์.....	51
3.6.7	การจำลองตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ์ที่นแบบด้วยการปรับระยะห่าง ระหว่างวัสดุทองแดงกับแผ่นพิมพ์วงจร.....	52
3.7	การจำลองแบบตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ์แบบสามมิติ.....	59
3.8	สรุป.....	68
4	การสร้างและการวัดทดสอบ.....	69
4.1	การสร้างตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ.....	69
4.2	ผลการวัดทดสอบสัมประสิทธิ์การสะท้อน.....	70
4.2.1	สายอากาศไดโอด.....	70
4.2.2	ตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ.....	72
4.3	ผลการวัดแบบรูปการແພັ້ນລັງຈານ.....	74
4.4	ผลการวัดทดสอบອัตราขยาย.....	79
4.5	สรุป.....	80
5	สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	82
5.5	สรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ์.....	82

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา	82
รายการอ้างอิง	84
ประวัติผู้เขียน	87



สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 พารามิเตอร์จากการจำลองแบบสายอากาศได้โพลที่ความถี่ 1.8 GHz และ 5.5 GHz.....	26
3.2 ค่าอัตราขยายจากผลการจำลองสายอากาศได้โพล.....	31
3.3 รายละเอียดของแผ่นพิมพ์วงจรและความถี่ที่ต้องการ.....	43
3.4 ค่าพารามิเตอร์ของตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ.....	43
4.1 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้สร้างตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ.....	70
4.2 สรุปผลคุณสมบัติของสายอากาศได้โพล.....	80



สารบัญรูป

รูปที่

หน้า

2.1	แบบรูปองค์การจัดวางติดตั้งตัวสะท้อนพาราโบลิก	7
2.2	รูปสายอากาศตัวสะท้อนพาราโบลิกที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้งานจริง	7
2.3	โครงสร้างพื้นฐานของแท่งโลหะประดิษฐ์	9
2.4	การเข้าซับสเตรตเป็นรูปตัวไอ	10
2.5	การนำแท่งโลหะมาวางเรียงกันคล้ายริ้ว	10
2.6	การประยุกต์ใช้แท่งโลหะประดิษฐ์วางเอียงที่ 45 องศา	10
2.7	การทำหนดค่าของสายอากาศที่ใช้ CP ICMS	11
2.8	การนำโหลดความจุแบบอินเตอร์ดิจิตอลมาปรับใช้กับสายอากาศ	11
2.9	โครงสร้างเรโซเนเตอร์ร่วงเหวนและแท่งโลหะประดิษฐ์	12
2.10	โครงสร้างเรโซเนเตอร์ร่วงเหวนที่ถูกวางซ้อนกัน 4 วงศ์	13
2.11	โครงสร้างหนึ่งของอภิวัสดุที่ก่อให้เกิดสนามไฟฟ้าโดยตรง	13
2.12	การนำโครงสร้างเรโซเนเตอร์ร่วงเหวน มาประยุกต์ใช้งานเพื่อรับรับการใช้งาน 2 ความถี่	14
2.13	โครงสร้างเรโซเนเตอร์ร่วงเหวน รองรับการใช้งานที่ความถี่ต่ำและความถี่สูง	15
2.14	แสดงคุณสมบัติของผิวอภิวัสดุ	16
2.15	เรโซเนเตอร์ร่วงเหวน	
ก.	แบบลูปเบิด	17
ข.	แบบลูปปิด	17
2.16	โครงสร้างเรโซเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้นเมื่ออัตราส่วนระหว่างอิมพีเดนซ์ $K < 1$	18
2.17	โครงสร้างเรโซเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้นเมื่ออัตราส่วนระหว่างอิมพีเดนซ์ $K > 1$	18
2.18	ค่าการเลื่อนและการลดthonของความถี่เรโซแนนซ์ที่เกิดจากเรโซเนเตอร์ อิมพีเดนซ์แบบขั้น ค่าอัตราส่วนระหว่างอิมพีเดนซ์ $K < 1$	19
2.19	ค่าการเลื่อนและการลดthonของความถี่เรโซแนนซ์ที่เกิดจากเรโซเนเตอร์ อิมพีเดนซ์แบบขั้น ค่าอัตราส่วนระหว่างอิมพีเดนซ์ $K > 1$	20
2.20	โครงสร้างเรโซเนเตอร์อินเตอร์ดิจิตอลภาคปั๊ซิเตอร์	21

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.1 โครงสร้างแบบจำลองสายอากาศได้โพล	26
3.2 แบบจำลองสายอากาศได้โพลที่ความถี่ 1.8 GHz	
ก. ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ	27
ข. แบบรูปการแผ่พลังงานแบบ 3 มิติ	27
ค. แบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามแม่เหล็ก	28
ง. แบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามไฟฟ้า	28
3.3 แบบจำลองสายอากาศได้โพลที่ความถี่ 5.5 GHz	
ก. ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ	29
ข. แบบรูปการแผ่พลังงานแบบ 3 มิติ	30
ค. แบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามแม่เหล็ก	30
ง. แบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามไฟฟ้า	31
3.4 โครงสร้างเรโซเนเตอร์วงแหวนพื้นฐาน 1 วงแหวน	34
3.5 ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนและค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน ของเรโซเนเตอร์วงแหวนแบบสี่เหลี่ยม 1 วงแหวน	34
3.6 ค่าสภาพยอมไฟฟ้าและค่าซึมซาบแม่เหล็กของเรโซเนเตอร์วงแหวน แบบสี่เหลี่ยม 1 วงแหวน	35
3.7 โครงสร้างเรโซเนเตอร์วงแหวนแบบสี่เหลี่ยม 2 วงแหวน	36
3.8 ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนและค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน ของเรโซเนเตอร์วงแหวนแบบสี่เหลี่ยม 2 วงแหวน	36
3.9 ค่าสภาพยอมไฟฟ้าและค่าซึมซาบแม่เหล็กของเรโซเนเตอร์วงแหวน แบบสี่เหลี่ยม 2 วงแหวน	37
3.10 โครงสร้างของเรโซเนเตอร์วงแหวนร่วมกับเรโซเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้น ก. โครงสร้างของเรโซเนเตอร์วงแหวน	38
ข. โครงสร้างของเรโซเนเตอร์วงแหวนร่วมกับเรโซเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้น	38
3.11 ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านของเรโซเนเตอร์วงแหวนร่วมกับ เรโซเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้น	38

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.12 โครงสร้างการใช้เรโซเนเตอร์ร่วงเหวนร่วมกับเรโซเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้น และอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเตอร์	39
3.13 ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านที่ได้จากการปรับเพิ่มจำนวนฟันของ อินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเตอร์	39
3.14 รูปแบบโครงสร้างของตัวสะท้อนผิวอิเล็กทรอนิกส์ ก. โครงสร้างพื้นฐานเรโซเนเตอร์ร่วงเหวน	40
ข. โครงสร้างพื้นฐานเรโซเนเตอร์ร่วงเหวนร่วมกับเทคนิค ^{เรโซเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้น}	40
ค. โครงสร้างพื้นฐานเรโซเนเตอร์ร่วงเหวนร่วมกับเทคนิค ^{เรโซเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้นและเทคนิคอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเตอร์}	40
3.15 วงจรสมมูล	41
3.16 โครงสร้างชิ้นงานของตัวสะท้อนผิวอิเล็กทรอนิกส์	43
3.17 การจำลองตัวสะท้อนผิวอิเล็กทรอนิกส์แบบด้วยการปรับขนาดความกว้าง	44
3.18 ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านที่ได้จากการปรับขนาดความกว้าง	45
3.19 การจำลองตัวสะท้อนผิวอิเล็กทรอนิกส์แบบด้วยการปรับเพิ่มจำนวนฟันของ อินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเตอร์	46
3.20 ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านที่ได้จากการปรับเพิ่มจำนวนฟันของ อินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเตอร์	46
3.21 การจำลองตัวสะท้อนผิวอิเล็กทรอนิกส์แบบด้วยการปรับขนาดความกว้างของ ฟันในอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเตอร์	47
3.22 ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านที่ได้จากการปรับขนาดความกว้างของฟันใน อินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเตอร์	47
3.23 การจำลองตัวสะท้อนผิวอิเล็กทรอนิกส์แบบด้วยการปรับขนาดความสูงของฟันใน อินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเตอร์	48
3.24 ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านที่ได้จากการปรับขนาดความสูงของฟันใน อินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเตอร์	49

สารบัญรูป (ต่อ)

3.25	การจำลองตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุด้านแบบด้วยการปรับขนาดของแกนที่รองรับพื้นของ อินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเตอร์	50
3.26	ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านที่ได้จากการปรับขนาดของแกนที่รองรับพื้นของ อินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเตอร์	50
3.27	การจำลองตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุด้านแบบด้วยการปรับระยะห่างของช่องว่างระหว่างพื้น ของอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเตอร์	51
3.28	ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านที่ได้จากการปรับระยะห่างของช่องว่างระหว่างพื้นของ ของอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเตอร์	52
3.29	การจำลองตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุด้านแบบด้วยการปรับระยะห่างระหว่างวัสดุทองแดง กับแผ่นพิมพ์วงจร	53
3.30	ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านที่ได้จากการปรับระยะห่างระหว่างวัสดุทองแดงกับ แผ่นพิมพ์วงจร	53
3.31	ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับของแบบจำลองตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ และค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านของแบบจำลองตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ	54
3.32	ค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้าและค่าซึมซาบแม่เหล็กของ ของแบบจำลองตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ	54
3.33	แบบรูปสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ ก. สนามไฟฟ้าที่ความถี่ 1.8 GHz	55
	ข. สนามไฟฟ้าที่ความถี่ 5.5 GHz	56
	ค. สนามแม่เหล็กที่ความถี่ 1.8 GHz	56
	ง. สนามแม่เหล็กที่ความถี่ 5.5 GHz	57
3.34	กระแสเชิงผิวของตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ ก. กระแสเชิงผิวที่ความถี่ 1.8 GHz	58
	ข. กระแสเชิงผิวที่ความถี่ 5.5 GHz	58
3.35	แบบจำลองตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุแล้วลำดับจำนวน 7×7 อิลิเมนต์	59

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.36 ผลจากการจำลองตัวสะท้อนผิวอกริวัสดุแคร์ดับจำนวน 7×7 อิลิเมนต์ กับสายอากาศได้โดยความถี่ 1.8 GHz ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป CST ก. ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ	60
ข. แบบรูปการแพ้พลังงานแบบ 3 มิติ	60
ค. แบบรูปการแพ้พลังงานในระนาบสนามไฟฟ้า	61
ง. แบบรูปการแพ้พลังงานในระนาบสนามแม่เหล็ก	61
3.37 ผลจากการจำลองตัวสะท้อนผิวอกริวัสดุแคร์ดับจำนวน 7×7 อิลิเมนต์ กับสายอากาศได้โดยความถี่ 5.5 GHz ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป CST ก. ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ	62
ข. แบบรูปการแพ้พลังงานแบบ 3 มิติ	63
ค. แบบรูปการแพ้พลังงานในระนาบสนามไฟฟ้า	63
ง. แบบรูปการแพ้พลังงานในระนาบสนามแม่เหล็ก	64
3.38 การแพ้พลังงานสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ก. สนามไฟฟ้าที่ความถี่ 1.8 GHz	65
ข. สนามไฟฟ้าที่ความถี่ 5.5 GHz	65
ค. สนามแม่เหล็กที่ความถี่ 1.8 GHz	66
ง. สนามแม่เหล็กที่ความถี่ 5.5 GHz	66
3.39 กระแสเชิงผิวของตัวสะท้อนผิวอกริวัสดุแคร์ดับจำนวน 7×7 อิลิเมนต์ ก. กระแสเชิงผิวที่ความถี่ 1.8 GHz	67
ข. กระแสเชิงผิวที่ความถี่ 5.5 GHz	67
4.1 ตัวสะท้อนผิวอกริวัสดุ	69
4.2 กราฟเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับระหว่างผลการจำลองของสายอากาศ ได้โดยและผลวัดทดสอบของสายอากาศได้โดยที่ความถี่ 1.8 GHz	71
4.3 กราฟเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับระหว่างผลการจำลองของสายอากาศ ได้โดยและผลวัดทดสอบของสายอากาศได้โดยที่ความถี่ 5.5 GHz	72

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.4 กราฟเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนระหว่างผลการจำลองของตัวสะท้อนผิว อภิวัสดุ ผลวัดทดสอบของตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุและผลวัดทดสอบของสายอากาศ ไดโอดที่ความถี่ 1.8 GHz.....	73
4.5 กราฟเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนระหว่างผลการจำลองของตัวสะท้อนผิว อภิวัสดุ ผลวัดทดสอบของตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุและผลวัดทดสอบของสายอากาศ ไดโอดที่ความถี่ 5.5 GHz.....	74
4.6 วิธีการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามไฟฟ้าของตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ ก. แสดงวิธีการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามไฟฟ้า..... ข. การติดตั้งจริงสำหรับการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามไฟฟ้า.....	75 76
4.7 วิธีการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามแม่เหล็กของตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ ก. แสดงวิธีการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามแม่เหล็ก..... ข. การติดตั้งจริงสำหรับการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามแม่เหล็ก.....	76 77
4.8 แบบรูปการแผ่พลังงานของตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุที่ความถี่ 1.8 GHz ก. แบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามไฟฟ้า..... ข. แบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามแม่เหล็ก.....	77 78
4.9 แบบรูปการแผ่พลังงานของตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุที่ความถี่ 5.5 GHz ก. แบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามไฟฟ้า..... ข. แบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามแม่เหล็ก.....	78 79

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันการใช้งานระบบการสื่อสารไร้สายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งระบบ LTE (Long Term Evolution) ที่ใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่และ WLAN (Wireless LAN) ที่สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ในระบบดิจิตอล โน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ต์ตาม จะเห็นได้ว่ามีผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องการอัตราขยายของสายอากาศที่เพิ่มขึ้นเพื่อรับการใช้งาน เนื่องจากรัศมีของการแพร่กระจายสัญญาณของสายอากาศที่ไปได้ไม่ไกลมากนัก จึงทำให้ผู้ใช้บริการได้รับการใช้งานจากสายอากาศอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการที่จะทำให้สัญญาณสามารถแพร่กระจายได้ไกลขึ้นหรือมีอัตราขยายที่เพิ่มขึ้น สามารถทำได้โดยการเพิ่มกำลังของเครื่องส่งหรือการเพิ่มอัตราขยายให้กับสายอากาศ ซึ่งการใช้ตัวสะท้อนเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจในการช่วยเพิ่มอัตราขยายให้แก่สายอากาศ ในปัจจุบันสายอากาศตัวสะท้อนที่ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายนั้น ได้แก่ สายอากาศพาราโบลิก และ สายอากาศแคลดับ โดยสายอากาศพาราโบลิกส่วนใหญ่จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีส่วนโถงและรวมสัญญาณไปที่จุดโฟกัส ในส่วนของสายอากาศแคลดับนั้นจะเป็นที่จะต้องคำนึงถึงระยะห่าง (d) ของแต่ละอิลิเมนต์ เนื่องจากระยะห่างของสายอากาศแต่ละอิลิเมนต์นั้นจะมีผลต่อการเผยแพร่องค์ประกอบของสายอากาศ ด้วย ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำแผ่นตัวสะท้อนมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสายอากาศ แต่เนื่องจากว่าการที่จะทำให้สายอากาศมีอัตราขยายที่สูง แผ่นตัวสะท้อนนั้นจะมีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่ และสายอากาศโดยทั่วไปที่มีคุณสมบัติเป็นตัวสะท้อนนั้นส่วนใหญ่สามารถทำงานได้ที่ 1 ความถี่ จึงเลือกใช้ความสำคัญของวัสดุที่มีขนาดเล็ก สามารถเพิ่มอัตราขยายให้กับสายอากาศ และทำงานได้มากกว่า 1 ความถี่ ซึ่งหนึ่งในวัสดุที่นักวิจัยให้ความสนใจในปัจจุบันนี้คืออิควิวัสดุหรือวัสดุเมรา (metamaterial) ซึ่งอิควิวัสดุเป็นวัสดุที่ไม่สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสามารถเข้าถึงคุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้มากกว่าวัสดุทั่วไป เนื่องจากวัสดุทั่วไปจะมีคุณสมบัติส่วนใหญ่ที่มีค่าสภาพยอนไฟฟ้าและค่าซึมซาบแม่เหล็กเป็นบวก แต่อิควิวัสดุนั้นสามารถทำให้เกิดคุณสมบัติที่หลากหลายขึ้นได้ โดยคุณสมบัติเหล่านี้ยังสามารถควบคุมได้จากการปรับลักษณะของโครงสร้างของอิควิวัสดุ แต่เนื่องจากลักษณะของโครงสร้างอิควิวัสดุนั้นเป็นสามมิติ มีความซับซ้อนของโครงสร้าง ทำให้ยากต่อการออกแบบ จึงมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิควิวัสดุนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้นทั้งเรื่องของอัตราขยายของสายอากาศของทั้งสองระบบข้างต้นที่ได้กล่าวมาทั้ง

ขนาดของสายอากาศตัวสะท้อนที่มีขนาดใหญ่ ระยะในการติดตั้ง ที่ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งสายอากาศตัวสะท้อนค่อนข้างมาก รวมถึงสายอากาศตัวสะท้อนทั่วไปที่สามารถรองรับการใช้งานได้ ความถี่ จึงได้มีความสนใจในตัวสะท้อนที่เป็นอภิวัสดุ แต่เนื่องจากตัวสะท้อนอภิวัสดุที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ มีลักษณะโครงสร้างที่ซับซ้อนเป็นสามมิติ จึงได้มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสะท้อนอภิวัสดุซึ่งพบว่าจากตัวสะท้อนอภิวัสดุยังมีวัสดุอื่น ๆ ที่นำสนิใจอยู่อีกด้วย ตัวสะท้อนพื้นผิวเมฆาหรือตัวสะท้อนพิวอภิวัสดุ (metasurface reflector) ซึ่งตัวสะท้อนพิวอภิวัสดุนั้นเป็นหนึ่งในชนิดของอภิวัสดุแต่โครงสร้างจะมีลักษณะเป็นสองมิติ ง่ายต่อการออกแบบ และสามารถควบคุมคลื่นที่มาตกกระทบที่หน้าผิวของอภิวัสดุได้ โดยงานวิจัยนี้เห็นถึงความสำคัญของการออกแบบขนาดของตัวสะท้อนให้มีขนาดเล็ก และรองรับการใช้งานได้มากกว่าหนึ่งความถี่ โดยตัวสะท้อน พิวอภิวัสดุนั้นจะต้องมีการควบคุมคุณสมบัติโดยการที่ทำให้ค่าสภาระยอนไฟฟ้ามีค่าเป็นลบ เพื่อให้พื้นผิวอภิวัสดุมีคุณสมบัติเป็นตัวสะท้อนคลื่น

จากบริษัทค้นคว้าและนวัตกรรมที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาคุณสมบัติของพื้นผิวอภิวัสดุ (metasurface) ซึ่งคุณสมบัติหลักของพื้นผิวอภิวัสดุนี้ แบ่งออกเป็นดังนี้คือ ENG (Epsilon Negative Medium), MNG (Mu Negative Medium) และ NZI (Near-zero refraction Index) โดยนักวิจัยส่วนใหญ่จะใช้แท่งโลหะประดิษฐ์ (wire) หรือเรโซโนเตอร์วงแหวน (ring resonator) เพื่อควบคุมคุณสมบัติต่าง ๆ ของพื้นผิวอภิวัสดุตามที่ต้องการ โดยโครงสร้างแท่งโลหะประดิษฐ์ส่วนใหญ่จะทำให้พฤติกรรมของสนามไฟฟ้าเปลี่ยน ซึ่งสามารถควบคุมให้ค่าสภาระยอนไฟฟ้ามีค่าเป็นลบได้ และโครงสร้างเรโซโนเตอร์วงแหวนส่วนใหญ่จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุนวนรอบ ซึ่งสามารถควบคุมค่าซึ่งชาบแม่เหล็กได้ โดยมีนักวิจัยได้นำทั้งแท่งโลหะประดิษฐ์และเรโซโนเตอร์วงแหวนไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น การนำแท่งโลหะประดิษฐ์วางเรียงต่อ ๆ กัน โดยมีการวางแผนห่างที่เท่ากัน การตัดแปลงเป็นตัวอักษรต่าง ๆ การนำแท่งโลหะประดิษฐ์มาไขว้กัน หรือแม้แต่การนำมาหักงอ ขาดกันเป็นเส้นลวด เช่น อินเตอร์ดิจิตอลคาปัซิเตอร์ (interdigital capacitor) เพื่อให้ชี้นงานมีขนาดเล็กลงและยังมีผลต่อค่าสภาระยอนไฟฟ้าอีกด้วย เป็นต้น ในส่วนของโครงสร้างเรโซโนเตอร์วงแหวน ได้มีนักวิจัยนำโครงสร้างของเรโซโนเตอร์วงแหวนมาประยุกต์ใช้งานอย่างหลากหลายด้าน เช่น นำมาขดเป็นวงแหวน หรือนำวงแหวนมาวางซ้อนกันเป็นสองวง เพื่อให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุนวนรอบ หรือแม้แต่การทำเรโซโนเตอร์วงแหวนให้เป็น อิมพีเดนซ์แบบขั้นเพื่อสร้างและควบคุมความถี่าร์มอนิกส์ โดยงานวิจัยนี้ได้สนับสนุนกับตัวสะท้อนพิวอภิวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติของค่าสภาระยอนไฟฟ้าเป็นลบ จากงานวิจัยที่ผ่านมานักวิจัยจะใช้โครงสร้างของแท่งโลหะประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมค่าสภาระยอนไฟฟ้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามคุณสมบัติที่ต้องการ ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้สนับสนุนกับลักษณะโครงสร้างของแท่งโลหะประดิษฐ์เป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าแท่งโลหะประดิษฐ์นี้ได้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยที่หลากหลายด้าน เช่น

ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สายอากาศ ซึ่งบางงานวิจัยได้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในด้านของการสะท้อนคลื่นหรือถูกนำไปใช้เพื่อลดขนาดของชิ้นงานให้มีขนาดที่กระชับขึ้นหรือเล็กลง หรือแม้กระทั่งการเพิ่มอัตราขยายให้แก่สายอากาศ

ปัจจุบันสายอากาศแต่ละตัวนั้นรองรับการใช้งานได้มากกว่าหนึ่งความถี่ และเพื่อตอบสนองการใช้งานร่วมกับสายอากาศ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ทำการออกแบบตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ ซึ่งรองรับการใช้งานได้มากกว่าหนึ่งความถี่ มีลักษณะโครงสร้างเป็นสองมิติ ง่ายต่อการออกแบบ โดยมีคุณสมบัติเป็นตัวสะท้อนคลื่น ซึ่งเกิดจากค่าสภาพยอมไฟฟ้ามีค่าเป็นลบ โดยประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐานเรโซแนเตอร์วงแหวนดึงเดินร่วมกับแท่งโลหะประดิษฐ์ โดยจะนำแท่งโลหะประดิษฐ์มาดัดแปลงตามรูปแบบเป็นอนิเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเตอร์เพื่อให้ชิ้นงานมีขนาดที่เล็กลงและสามารถควบคุมความถี่ที่ต้องการได้ ในส่วนของเรโซแนเตอร์วงแหวนนี้ได้มีการทำเป็นเรโซแนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้นเพื่อควบคุมความถี่ชาร์มอนิกส์ และรองรับการใช้งานได้สองความถี่สำหรับระบบ LTE และ WLAN เพื่อตอบสนองการใช้งานร่วมกับสายอากาศในปัจจุบัน ซึ่งในงานวิจัยนี้จะนำตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับสายอากาศได้โดยเพิ่มอัตราขยายให้กับสายอากาศ โดยทางตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุไว้ที่ด้านหลังของสายอากาศได้โดย ข้อดีของงานนี้คือตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุที่ได้มีขนาดเล็กโดยได้นำเทคนิคของอนิเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเตอร์มาประยุกต์ใช้กับโครงสร้างและควบคุมความถี่จากโครงสร้างของเรโซแนเตอร์วงแหวน โดยออกแบบเป็นเรโซแนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้น (step-impedance resonator) อัตราขยายของสายอากาศค่อนข้างสูง รองรับการใช้งานได้สองความถี่ รูปแบบการแพร์กระจายคลื่นมีลักษณะเป็นการแพร์กระจายคลื่นแบบทิศทางเดียว และชิ้นงานมีขนาดเล็กลง

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิธีออกแบบเชิงทฤษฎีของตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ ที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้งานในระบบ LTE และ WLAN

1.2.2 เพื่อออกแบบตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุสำหรับเพิ่มอัตราขยายให้กับสายอากาศ

1.2.3 สร้างสายอากาศต้นแบบ และวัดทดสอบ

1.3 สมมติฐานของการวิจัย

1.3.1 เมื่อนำโครงสร้างพื้นฐานเรโซแนเตอร์วงแหวนมาออกแบบเป็นอนิพีเดนซ์แบบขั้น จะสามารถใช้ประโยชน์จากความถี่ชาร์มอนิกส์ได้

1.3.2 การนำอนิเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเตอร์มาประยุกต์ใช้ในโครงสร้าง จำนวนและขนาดของพื้นในอนิเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเตอร์สามารถทำให้ชิ้นงานมีขนาดเล็กลง

1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น

- 1.4.1 สร้างตัวสะท้อนผิวอวัสดุที่มีค่าสภาพยومไฟฟ้าเป็นลบและค่าซึ่งซาบเมร์เล็คที่มีค่าเป็นบวก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในการสะท้อนคลื่น
- 1.4.2 ใช้โปรแกรม CST Microwave Studio 2016 ในการจำลองแบบ

1.5 ขอบเขตของการวิจัย

- 1.5.1 ออกแบบโครงสร้างตัวสะท้อนผิวอวัสดุ เพื่อรับรู้การใช้งานตามวัตถุประสงค์
- 1.5.2 จำลองตัวสะท้อนผิวอวัสดุด้วยโปรแกรม CST Microwave Studio 2016 เพื่อรับรู้การใช้งานในระบบ LTE และ WLAN
- 1.5.3 สร้างสายอากาศต้นแบบและวัดทดสอบเปรียบเทียบผลที่ได้จากการจำลองแบบ

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.6.1 ได้ตัวสะท้อนผิวอวัสดุที่ทำงานในระบบ LTE และ WLAN โดยชิ้นงานนี้ขนาดเล็ก กระชับ เหมาะสมแก่การนำไปใช้เป็นตัวสะท้อนคลื่น มีอัตราขยายในทิศทางด้านหน้าที่สูง
- 1.6.2 สามารถเพิ่มอัตราขยายให้กับสายอากาศได้

1.7 นวัตกรรมของงานวิจัยนี้

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการออกแบบตัวสะท้อนผิวอวัสดุที่รองรับการใช้งานได้ทั้งระบบ LTE และ WLAN สำหรับการใช้งานร่วมกับสายอากาศได้โดยรวมและเพื่อปรับปรุงอัตราขยายของสายอากาศได้โดยรวม กระบวนการทำงานสำหรับการออกแบบตัวสะท้อนผิวอวัสดุที่รองรับการใช้งานสองความถี่ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ตัวสะท้อนผิวอวัสดุที่ทำการออกแบบมีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการความถี่ใช้งานที่ระบบ LTE (1.8GHz) และ WLAN (5.5GHz) เพื่อให้ได้ความถี่ที่รองรับการใช้งานในปัจจุบัน มีแบบรูปการແเพล็งงานแบบชี้ทิศทาง และให้อัตราขยายสูงเมื่อใช้งานร่วมกับสายอากาศ กระบวนการในส่วนที่สอง คือ การนำตัวสะท้อนผิวอวัสดุมาใช้งานร่วมกับสายอากาศได้โดยทำหน้าที่รับคลื่นจากสายอากาศได้โดยรวม และทำการสะท้อนคลื่นออกบริเวณผิวด้านหน้าของตัวสะท้อนผิวอวัสดุ และกระบวนการสุดท้าย คือ การประเมินผลประสิทธิภาพของการสะท้อน ซึ่งการสะท้อนที่ได้ให้อัตราขยายที่สูง รองรับการใช้งานได้ทั้งระบบ LTE และ WLAN จากการวัดทดสอบ

1.8 การจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์

เนื้อหาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล สำหรับตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ ประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด 5 บทด้วยกัน

บทที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมุติฐานของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นวัตกรรมของงานวิจัยนี้ และการจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงปริศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวสะท้อนโดยทั่วไป และตามด้วยการกล่าวถึงผิวอภิวัสดุ ซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างและรูปแบบในการประยุกต์ใช้ เร โโซเนเตอร์ร่วงเหวน และเท่งโลหะประดิษฐ์ ซึ่งทั้งสองโครงสร้างสามารถควบคุมคุณสมบัติของผิวอภิวัสดุได้ดี และง่ายต่อการออกแบบนำมาประยุกต์ใช้งาน รวมไปถึงโครงสร้างที่มีผลต่อการใช้งานหลายความถี่ สำหรับในส่วนของทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการนำมาประยุกต์ใช้งาน เพื่อให้เกิดตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุที่รองรับการใช้งาน ได้สองความถี่ และมีขนาดเล็ก ประกอบด้วย ทฤษฎีผิวอภิวัสดุ เร โโซเนเตอร์ร่วงเหวน เร โโซเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้น อินเตอร์ดิจิตอลค่าปาซิเตอร์และทฤษฎีของสายอากาศ

บทที่ 3 กล่าวถึงการออกแบบสายอากาศได้โพล การออกแบบตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปซีเอลที การจำลองแบบตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุโดยออกแบบเป็นอะเรย์เพื่อรับรับการใช้งานร่วมกับสายอากาศและเพื่อรับรับการแพร่กระจายคลื่นจากสายอากาศ โดยพิจารณา รูปแบบของการสะท้อนคลื่นจากผิวของตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุและประสิทธิภาพของตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุในการเพิ่มอัตราขยายให้แก่สายอากาศ โดยพิจารณาจากการสะท้อนคลื่นจากค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อน และการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน

บทที่ 4 กล่าวถึงผลการทดลอง การสร้างสายอากาศได้โพล การวัดค่า S_{11} การวัดแบบรูป การแผ่พลังงานและอัตราขยาย การสร้างแบบจำลองตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ การทดลอง วัดค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อน การวัดแบบรูปการแผ่พลังงานและอัตราขยายเมื่อทดสอบกับสายอากาศได้โพล

บทที่ 5 กล่าวถึงสรุปผลการวิจัย รวมถึงการออกแบบสายอากาศได้โพลและตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ ปัญหาที่เกิดขึ้นข้อเสนอแนะอีกทั้งแนวทางในการแก้ปัญหา และการพัฒนาต่อไปในอนาคต

บทที่ 2

ปริทัศน์วรรณกรรมและทฤษฎีเกี่ยวข้อง

2.1 กล่าวนำ

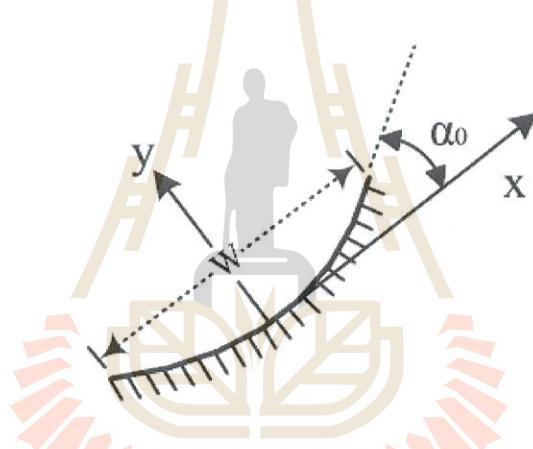
ปัจจุบันการสื่อสารทางโทรคมนาคมนั้นมีอัตราการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพของสายอากาศจึงสำคัญต่อระบบการสื่อสาร โทรคมนาคมและเพื่อรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสายอากาศนั้นนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบันนิยมนำตัวสะท้อน (reflector) มาใช้งานร่วมกับสายอากาศเพื่อเพิ่มอัตราขยายให้กับสายอากาศ แต่จะเห็นว่าตัวสะท้อนส่วนใหญ่รองรับการใช้งานได้ 1 ความถี่ ในงานวิจัยนี้จึงสนใจตัวสะท้อนที่รองรับการใช้งานได้มากกว่า 1 ความถี่ ขนาดเล็ก เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับสายอากาศ และให้อัตราขยายที่สูง โดยในบทนี้จะกล่าวถึงตัวสะท้อนโดยทั่วไปที่นิยมนำมาใช้งาน และหลังจากนั้นจะกล่าวถึงตัวสะท้อนที่เริ่มนิยมให้ความสนใจนั่นคือตัวสะท้อนผิวอวัสดุ เนื่องจากผิวอวัสดุมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน ขนาดเล็กและง่ายต่อการนำไปใช้งาน ถัดมาจะกล่าวถึงโครงสร้างพื้นฐานที่นิยมนำมาใช้ในการควบคุมคุณสมบัติของผิวอวัสดุ ได้แก่ แท่งโลหะประดิษฐ์ (wire) และเรโซเนเตอร์วงแหวน (ring resonator) ซึ่งงานวิจัยนี้ต้องการออกแบบตัวสะท้อนผิวอวัสดุที่สามารถทำงานได้ 2 ความถี่ จึงได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ความถี่และสำหรับทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไปตามลำดับ

2.2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

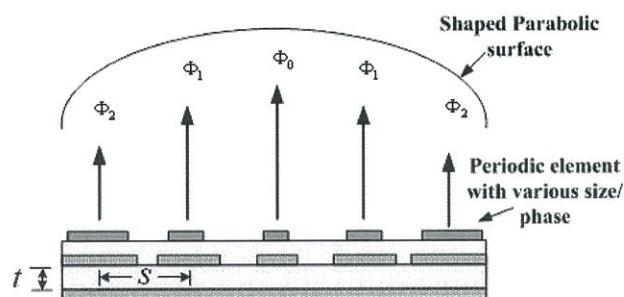
ในปัจจุบันจะเห็นว่าการสื่อสารไร้สายในระบบ LTE และ WLAN มีผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราขยายของสายอากาศจึงต้องเพิ่มสูงขึ้น เพื่อรับการใช้งานของผู้ใช้บริการที่สูงขึ้น ซึ่งในการนำไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับสายอากาศ วัสดุควรมีขนาดที่เล็กเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าตัวสะท้อนผิวอวัสดุนั้นมีลักษณะ โครงสร้างเป็นสองมิติ โครงสร้างไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการออกแบบ เป็นอวัสดุที่สามารถนำมาใช้ทำเป็นตัวสะท้อนได้โดยจะออกแบบให้สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งสองระบบที่ LTE และ WLAN จากการประยุกต์ใช้เรโซเนเตอร์วงแหวนร่วมกับแท่งโลหะประดิษฐ์

2.2.1 ตัวสะท้อน (Reflector)

สายอากาศตัวสะท้อน มีหลากหลายประเภทโดยจะใช้งานต่างกันตามความต้องการ ซึ่งสายอากาศตัวสะท้อนโดยทั่วไปที่นิยมนำมาใช้งานในการสะท้อนคลื่น คือตัวสะท้อนพาราโบลิก (Parabolic reflectors) ซึ่งตัวสะท้อนพาราโบลิกจะต้องคำนึงถึงขนาดความโค้งของงานเส้นผ่านศูนย์กลาง องศาในการจัดวางติดตั้งตัวสะท้อนพาราโบลิก (S. Momeni, A. Menbari, A. A. Alemdarjabi and P. Mohammadi, 2019) ดังแสดงในรูปที่ 2.1 ซึ่งจะเห็นว่าการออกแบบและติดตั้งมีความซับซ้อน โดยทั่วไปสายอากาศตัวสะท้อนนั้นสามารถรองรับการใช้งานได้ 1 ความถี่ ในรูปที่ 2.2 รูปสายอากาศ ตัวสะท้อนแคลดับ แสดงสายอากาศตัวสะท้อนแคลดับที่หลากหลายขนาด โดยสายอากาศตัวสะท้อนถูกติดตั้งเรียงกันเป็นแคลดับ ซึ่งสายอากาศตัวสะท้อนแต่ละตัวจะถูกวางเป็นระยะห่างที่แตกต่างกันออกไป เป็นต้น



รูปที่ 2.1 แบบรูปองค์การจัดวางติดตั้งตัวสะท้อนพาราโบลิก
(S. Momeni, A. Menbari, A. A. Alemdarjabi and P. Mohammadi, 2019)



รูปที่ 2.2 รูปตัวสะท้อนแคลดับ
(Piyaporn Krachodnok and Rangsan Wongsan, 2007)

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าสายอากาศตัวสะท้อนมีความยากต่อการออกแบบและการติดตั้งงานวิจัยนี้จึงสนใจเกี่ยวกับผิวอวิวัสดุซึ่งมีโครงสร้างเป็น 2 มิติ ไม่ซับซ้อน ขนาดเล็ก รองรับการใช้งานได้หลายความถี่และง่ายต่อการนำมาใช้งานร่วมกับสายอากาศ

2.2.2 ผิวอวิวัสดุ (Metasurface)

ในปัจจุบันผิวอวิวัสดุเริ่มมีการนำมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ในด้านการสะท้อนหรือการส่งผ่านคลื่น เป็นต้น เนื่องจากโครงสร้างของผิวอวิวัสดุนั้นมีลักษณะโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน เป็น 2 มิติ ง่ายต่อการออกแบบ ซึ่งคุณสมบัติของผิวอวิวัสดุนั้น ได้แก่ การที่วัสดุมีค่าสภาคายอมทางไฟฟ้าหรือค่าความซึมซาบแม่เหล็กเป็นลบหรือเข้าใกล้ศูนย์ หรือมีค่าดัชนีหักเหเป็นลบ ซึ่งโครงสร้างที่นักวิจัยส่วนใหญ่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมคุณสมบัติของอวิวัสดุนั้นก็คือ แท่งโลหะประดิษฐ์หรือเรโซเนเตอร์ร่วงเหวน

2.2.2.1 แท่งโลหะประดิษฐ์

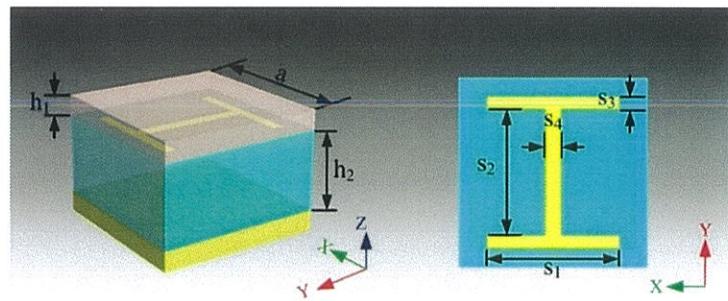
แท่งโลหะประดิษฐ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่นักวิจัยนิยมนำมาออกแบบ และประยุกต์ใช้ในด้านการสะท้อนคลื่น ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สายอากาศและอื่น ๆ เป็นต้น (D. H. Kwon, 2018) ในรูปที่ 2.3 คือการนำโครงสร้างพื้นฐานของแท่งโลหะประดิษฐ์โดยตรง มาใช้ โดยการปรับลดความยาวของโครงสร้างแท่งโลหะประดิษฐ์ที่อยู่บนชั้นสเตรต นำมาใช้ในด้านการสะท้อนคลื่นที่พื้นผิว (L. Shen, Y. Pang, L. Yan, Q. Li and S. Qu, 2018) ในรูปที่ 2.4 เช่น ชั้นสเตรตเป็นรูปตัวไอ (I) ใช้งานในลักษณะเป็นตัวลดการสะท้อนคลื่น ซึ่งทั้ง ๆ ที่ลักษณะโครงสร้างคล้ายเป็นแท่งโลหะประดิษฐ์ แต่เปลี่ยนหลักการออกแบบกีสามารถทำให้ผลลัพธ์มีลักษณะแตกต่างกันออกไปและยังมีหลักการนำแท่งโลหะประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้งานกับสายอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สายอากาศ เช่น การนำแท่งโลหะมาวางเรียงกันคล้ายริ้ว (X. Li, J. Yang, Z. Chen, P. Ren and M. Huang, 2018) ดังแสดงในรูปที่ 2.5 เพื่อเพิ่มอัตราขยายให้แก่สายอากาศ และยังมีการประยุกต์โดยการนำแท่งโลหะประดิษฐ์มาวางเรียงกัน แต่ลักษณะการวางจะวางเอียงที่ 45 องศาเพื่อใช้ในด้านการเปลี่ยนการโพลาไรซ์และการสะท้อนของคลื่น (M. Long, W. Jiang, and S. Gong, 2017) ดังแสดงในรูปที่ 2.6 ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เป็นตัวสะท้อน คลื่นที่แนบความถี่กว้าง มีการวางโครงสร้างในลักษณะเอียงที่ 45 องศา ให้มีการสะท้อนกลับที่ไม่ดี หรือผิดเพี้ยนไปจากเดิม ใช้ในการลดภาพหน้าตัดสัญญาณ雷达ห์ (RCS) ซึ่งการนำแท่งโลหะมาประยุกต์ใช้ตามที่กล่าวมาข้างต้นจะมีข้อเสียคือ ขนาดของชิ้นงานค่อนข้างใหญ่ จึงได้มีนักวิจัยนำแท่งโลหะไปทำเป็นหยัก ๆ ดัดจี้นดัดลงไปมาเพื่อลดขนาดชิ้นงาน (I. C. Metasurfaces, T. Yue, S. Member, Z. H. Jiang, and D. H. Werner, 2016) ดังรูปที่ 2.7 เพื่อปรับลดขนาดชิ้นงานให้เล็กลง โดยได้นำหลักการของอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์มาปรับใช้ ข้อดีของรูปที่ 2.8 (T. Yue, Z. H. Jiang, and D. H. Werner, 2014) คือ ขนาดของชิ้นงานเล็กลง แต่อัตราขยายค่อนข้างต่ำ

นอกจากนี้ก็ยังมีโครงสร้างอื่น ๆ อีกที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการสะท้อนคลื่นหรือการเพิ่มอัตราขยายให้แก่สายอากาศ

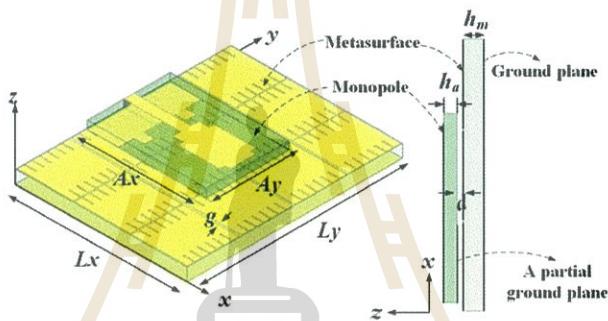
จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับแท่งโลหะประดิษฐ์นั้น จะพบว่าแท่งโลหะประดิษฐ์ถูกนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างหลากหลาย จากโครงสร้างพื้นฐานแท่งโลหะประดิษฐ์สามารถเป็นได้ทั้งตัวสะท้อนคลื่นและลดการสะท้อนคลื่นจากการถูกเชาซับสเตรตปรับเป็นตัวอักษร ไอ (I) หรือการนำแท่งโลหะประดิษฐ์มาวางเรียงไก่กันเพื่อการสะท้อนคลื่น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขนาดที่ได้ค่อนข้างใหญ่ จึงมีนักวิจัยที่นำเทคนิคของอินเตอร์ดิจิตอลมาปะติดต่อร่วมมาปรับใช้ในงาน แต่อัตราขยายค่อนข้างต่ำ และยังมีโครงสร้างอื่น ๆ อีกที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นตัวสะท้อนคลื่นในผิวอวิสสูตร ซึ่งการสะท้อนของ ผิวอวิสสูตรเกิดจากคุณสมบัติของค่าสภาพอนทางไฟฟ้าเป็นลบที่สามารถควบคุมได้จากสนามไฟฟ้า ซึ่งแท่งโลหะประดิษฐ์นั้นนอกจากจะเป็นโครงสร้างที่ง่ายต่อการออกแบบ ยังสามารถใช้เป็นวัสดุที่ช่วยในการควบคุมค่าสนามไฟฟ้าได้อีกด้วย โครงสร้างสามารถออกแบบได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งนอกเหนือจากโครงสร้างแท่งโลหะประดิษฐ์ก็ยังมีโครงสร้างเรโซเนเตอร์วงแหวนที่สามารถออกแบบได้ง่ายและมีผลต่อคุณสมบัติผิวอวิสสูตรซึ่ง โครงสร้างเรโซเนเตอร์วงแหวนนี้จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป



รูปที่ 2.3 โครงสร้างพื้นฐานของแท่งโลหะประดิษฐ์ (D. H. Kwon, 2018)

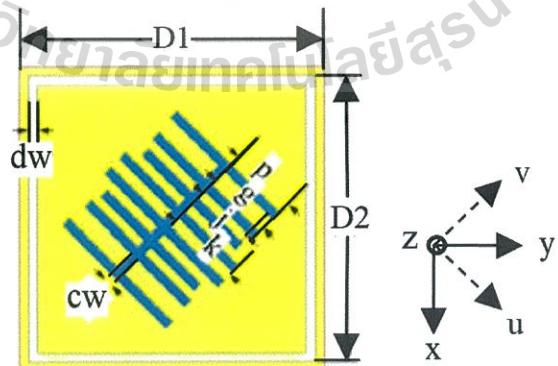


รูปที่ 2.4 การเช่าซื้อบล็อกเป็นรูปตัวไอ (I) (L. Shen, Y. Pang, L. Yan, Q. Li and S. Qu, 2018)



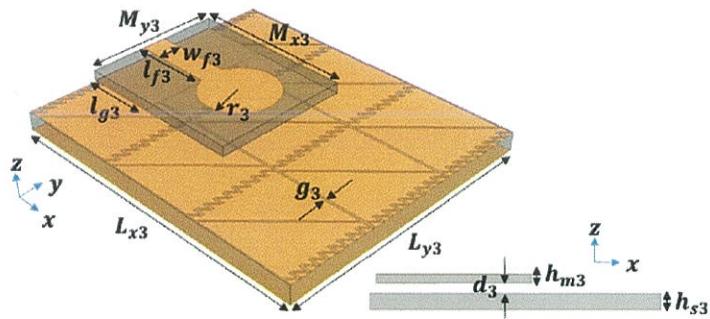
รูปที่ 2.5 การนำแท่งโลหะมาวางเรียงกันคล้ายริบบ์

(X. Li, J. Yang, Z. Chen, P. Ren and M. Huang, 2018)



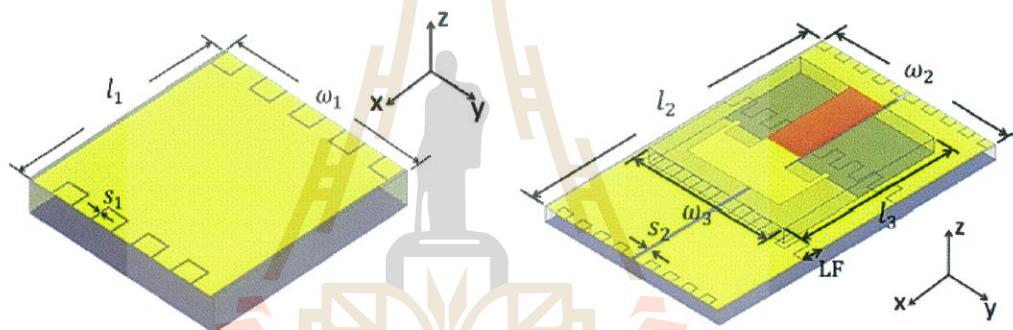
รูปที่ 2.6 การประยุกต์ใช้แท่งโลหะประดิษฐ์วางเอียงที่ 45 องศา

(M. Long, W. Jiang, and S. Gong, 2017)



รูปที่ 2.7 การกำหนดค่าของสายอากาศที่ใช้ CP ICMS

(I. C. Metasurfaces, T. Yue, S. Member, Z. H. Jiang, and D. H. Werner, 2016)



รูปที่ 2.8 การนำโอลด์ความจุแบบอินเตอร์ดิจิตอลมาปรับใช้กับสายอากาศ

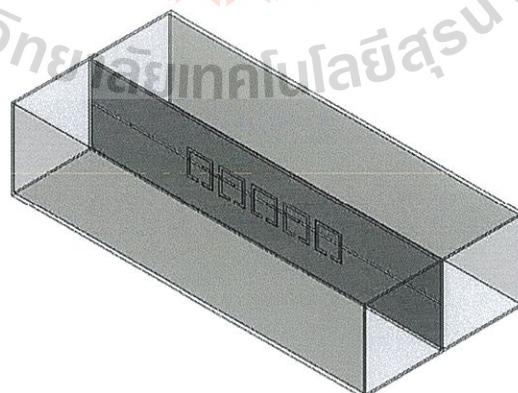
(T. Yue, Z. H. Jiang, and D. H. Werner, 2014)

2.2.2.2 เเรโซเนเตอร์ร่วงແຫວນ

นักวิจัยส่วนใหญ่ยังนำโครงสร้างมาประยุกต์ใช้ในการส่งผ่านคลื่น ซึ่งเรารู้ว่าความสามารถควบคุมค่าซึ่มชาบแม่เหล็กได้ดี ก็ต่อเมื่อการที่สามารถแม่เหล็กหมุนวนรอบคลื่นของเรโซเนเตอร์ร่วงແຫວນ ทั้งนี้ทั้งนั้นยังขึ้นอยู่กับการป้อนทิศทางของคลื่นให้กับโครงสร้าง ซึ่งบางโครงสร้างของเรโซเนเตอร์ร่วงແຫວนก็สามารถนำໄไปประยุกต์ใช้ในการสะท้อนคลื่นหรือควบคุมค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้าจากสนามไฟฟ้าภายในโครงสร้างได้ เช่นกัน ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการประยุกต์ใช้งานโครงสร้างของเรโซเนเตอร์ร่วงແຫວน (T. Decoopman, O. Vanbésien and D. Lippens, 2004) ในรูปที่ 2.9 เเรโซเนเตอร์ร่วงແຫວนถูกนำมาไปใช้ในด้านการส่งผ่าน โดยโครงสร้างจะประกอบไปด้วยเรโซเนเตอร์ร่วงແຫວนและแท่งโลหะประดิษฐ์ ซึ่งในงานวิจัยนี้

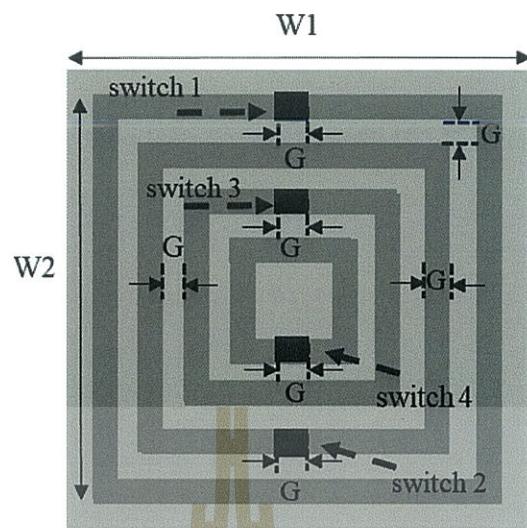
เร โโซเนเตอร์วงแหวนจะทำหน้าที่ควบคุมค่าซึ่มชาบแม่เหล็กและแท่งโลหะประดิษฐ์จะทำหน้าที่ควบคุมค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้าจะกำหนดให้สานามแม่เหล็กพุ่งเข้าในทิศทางตั้งจากด้านหน้าของเร โซเนเตอร์วงแหวน ผลลัพธ์คือคุณภาพการส่งผ่านสูง ประสิทธิภาพของการส่งผ่านคลื่นสูงจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งของวัสดุประดิษฐ์พลังแม่เหล็ก ใช้งานที่ย่านความถี่ X (X-band) (C. Jung, J. Kim, and J. Choi, 2013) ในรูปที่ 2.10 นำเสนอค่าซึ่มชาบแม่เหล็ก ที่เกิดจากการควบคุมโดยเร โซเนเตอร์วงแหวนและค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้าที่เกิดจากช่องว่างของเร โซเนเตอร์วงแหวนที่แยกออก จะเห็นว่าโครงสร้างเร โซเนเตอร์วงแหวนถูกวางซ้อนกัน 4 วงแหวน โดยจะมีช่องว่างในแต่ละวงแหวนที่ต่างกันออกไป เกิดการสะท้อนและการส่งผ่านได้สีความถี่ โดยค่าซึ่มชาบแม่เหล็กจะถูกควบคุมจากโครงสร้างของเร โซเนเตอร์วงแหวนทั้งสี่วงแหวน และค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้าจะถูกควบคุมได้จากช่องว่างที่แยกออกของเร โซเนเตอร์วงแหวน และในส่วนของ (H. Shi et al., 2015) รูปที่ 2.11 เป็นโครงสร้างหนึ่งของกิวัสดุที่ก่อให้เกิดสนามไฟฟ้าโดยตรง (electric field coupled resonators:ELCRs) จากช่องว่างของคู่โลหะตรงกลางวงแหวนซึ่งมีลักษณะคล้ายการนำหลักการของแท่งโลหะประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดสนามไฟฟ้าบริเวณผิว ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานเป็นตัวสะท้อนคลื่น

จากการวิจัยของเร โซเนเตอร์วงแหวนที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าโครงสร้างเร โซเนเตอร์วงแหวนนิยมนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งผ่านคลื่น โดยการควบคุมค่าซึ่มชาบแม่เหล็กและยังสามารถควบคุมค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้าได้ ซึ่งส่งผลทำให้โครงสร้างมีคุณสมบัติเป็นตัวสะท้อนคลื่น นอกจากนี้ยังพบว่าแท่งโลหะประดิษฐ์ยังสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับเร โซเนเตอร์วงแหวนซึ่งส่งผลต่อค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้าเช่นกัน



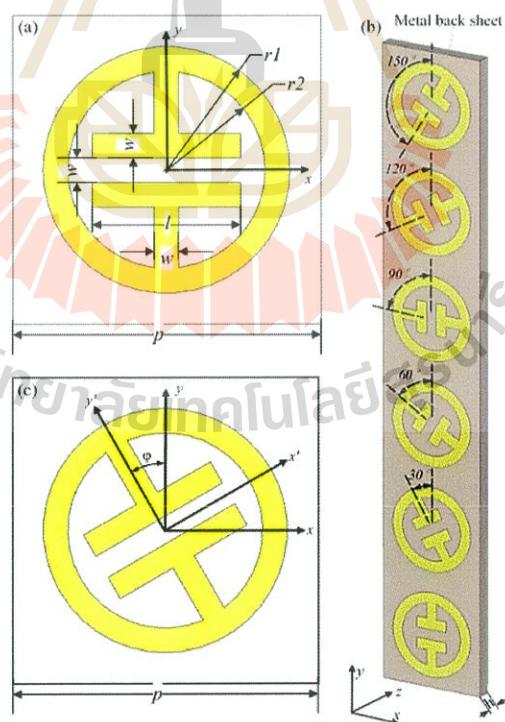
รูปที่ 2.9 โครงสร้างเร โซเนเตอร์วงแหวนและแท่งโลหะประดิษฐ์

(T. Decoopman, O. Vanbésien and D. Lippens, 2004)



รูปที่ 2.10 โครงสร้างเรซอนаторร่วงเหวนที่ถูกวงชุดอนกัน 4 วง

(C. Jung, J. Kim, and J. Choi, 2013)



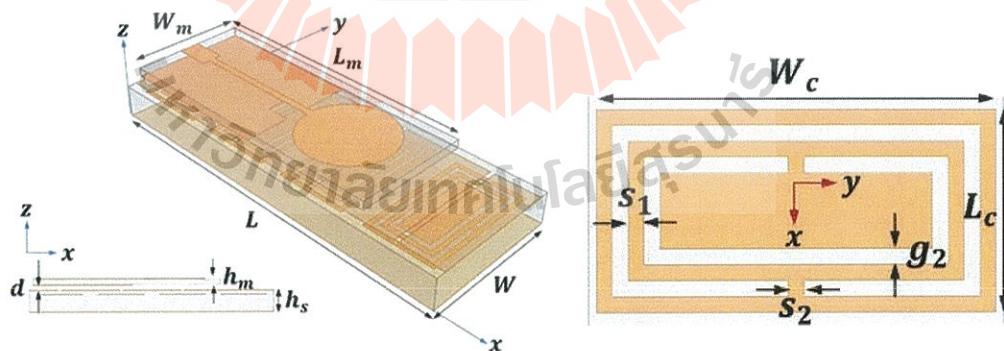
รูปที่ 2.11 โครงสร้างหนึ่งของอภิวัสดุที่ก่อให้เกิดสนามไฟฟ้าโดยตรง

(electric field coupled resonators:ELCRs) (H. Shi et al., 2015)

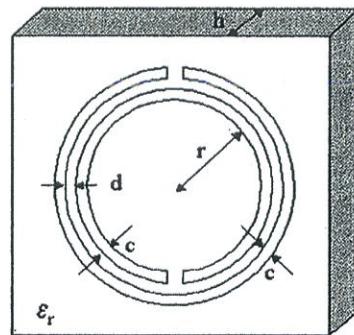
2.2.3 โครงสร้างที่รองรับการใช้งานได้หลายความถี่ (Multifrequency)

ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมนั้นสามารถใช้งานได้หลายความถี่ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องออกแบบชิ้นงานให้รองรับความถี่ใช้งานได้มากกว่า 1 ความถี่ เพื่อทางเลือกในการประยุกต์ใช้งาน ซึ่งการทำงานหลายความถี่ใช้งานโดยทั่วไปโครงสร้างที่นิยมออกแบบจะเป็นการประยุกต์ใช้โครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน เช่น เรโซเนเตอร์ร่วงเหวน (R. Metasurface, A. H. Panaretos and D. H. Werner) ในรูปที่ 2.12 การนำโครงสร้างเรโซเนเตอร์ร่วงเหวน มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับสายอากาศไมโน่โพล โดยโครงสร้างประกอบด้วยวงเหวน 2 วงเหวน ซึ่งรองรับการใช้งานได้สองความถี่ที่ 1.9 GHz และ 2.5 GHz ตามลำดับ และในรูปที่ 2.13 แสดงโครงสร้างของเรโซเนเตอร์ร่วงเหวนซึ่งประกอบไปด้วยวงเหวน 2 วงเหวน (F. Falcone, F. Martín, J. Bonache, R. Marqués, T. Lopetegi, and M. Sorolla, 2004) เช่นกัน รองรับการใช้งาน 2 ความถี่ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้เรโซเนเตอร์ร่วงเหวนขนาดเล็กควบคุมความถี่สูงและวงเหวนขนาดใหญ่ควบคุมความถี่ต่ำ

ข้อสังเกตคืองานวิจัยที่รองรับการใช้งานความถี่ที่มากกว่าหนึ่งความถี่ ส่วนใหญ่จะมีจำนวนของเรโซเนเตอร์ร่วงเหวนตามความถี่ที่รองรับการใช้งานเพื่อช่วยควบคุมค่าซึ่งชาบແມ່เหล็กหรือค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้าตามความถี่ที่ออกแบบใช้งาน ข้อเสียคือขนาดโครงสร้างของเรโซเนเตอร์ร่วงเหวนค่อนข้างใหญ่ เมื่อนำมาประยุกต์ใช้งานที่ความถี่ต่ำ และจำนวนของเรโซเนเตอร์ร่วงเหวนจะเพิ่มขึ้นตามความถี่ใช้งาน



รูปที่ 2.12 การนำโครงสร้างเรโซเนเตอร์ร่วงเหวน มาประยุกต์ใช้งานเพื่อรองรับการใช้งาน 2 ความถี่ (R. Metasurface, A. H. Panaretos and D. H. Werner, 2017)



รูปที่ 2.13 โครงสร้างเรซูโนเตอร์วงแหวน รองรับการใช้งานที่ความถี่ต่ำและความถี่สูง
(F. Falcone, F. Martín, J. Bonache, R. Marqués, T. Lopetegi, and M. Sorolla, 2004)

การออกแบบตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุสองความถี่ ที่รองรับการใช้งานในระบบ LTE (1.8 GHz) และ WLAN (5.5 GHz) ซึ่งทำงานร่วมกับสายอากาศได้โดย ให้อัตราขยายของสายอากาศที่ค่อนข้างสูง โดยโครงสร้างตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุนี้ประกอบไปด้วย เรซูโนเตอร์วงแหวนและอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าชีเตอร์ซึ่งการออกแบบเรซูโนเตอร์วงแหวนในงานวิจัยนี้สามารถควบคุมสนามไฟฟ้าได้จากโครงสร้างของตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุจากการวางแผนโครงสร้างในทิศทางที่ข่านกับสนามไฟฟ้า และเพื่อรองรับการใช้งานสองความถี่ การสร้างความถี่ที่สองในวิทยานิพนธ์นี้จะไม่เพิ่มเรซูโนเตอร์วงแหวนที่สองมาช่วยในการควบคุมความถี่ชาร์มอนิกส์ เมื่อกับที่นิยมใช้ในงานวิจัยที่ได้กล่าวมา แต่จะควบคุมด้วยเทคนิคการใช้เรซูโนเตอร์อินพีเดนซ์แบบขั้นแทน โดยจะเพิ่มโครงสร้างของอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าชีเตอร์เข้ามาใช้เพื่อทำให้ชิ้นงานมีขนาดเล็กลง และเป็นที่ทราบกันดีว่าโครงสร้างของอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าชีเตอร์นั้นพื้นฐานมาจากแท่งโลหะประดิษฐ์ ซึ่งสามารถควบคุมค่าสนามไฟฟ้าได้ดี ซึ่งทั้งโครงสร้างเรซูโนเตอร์วงแหวน และโครงสร้างของอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าชีเตอร์ในงานวิจัยนี้ทั้งสองโครงสร้างจะถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมค่าสนามไฟฟ้า ซึ่งค่าสนามไฟฟ้ามีผลต่อค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้า ถ้าหากค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้ามีค่าเป็นลบ จะทำให้คุณสมบัติของโครงสร้างผิวอวิวัสดุ มีลักษณะเป็นตัวสะท้อนคลื่นที่บริเวณผิว ซึ่งทั้งสองโครงสร้างนี้จึงเหมาะสมแก่การนำมาประยุกต์ใช้งานเป็นตัวสะท้อนคลื่นในงานวิจัยนี้ และนอกจากจะสามารถควบคุมค่าสนามไฟฟ้าได้ดี ยังให้อัตราขยายของสายอากาศสูง รองรับการใช้งานได้สองความถี่ที่เกิดจากเรซูโนเตอร์อินพีเดนซ์แบบขั้น มีขนาดเล็กลงจากการเพิ่มอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าชีเตอร์ ซึ่งรายละเอียดทุกภูมิของผิวอวิวัสดุเรซูโนเตอร์วงแหวน

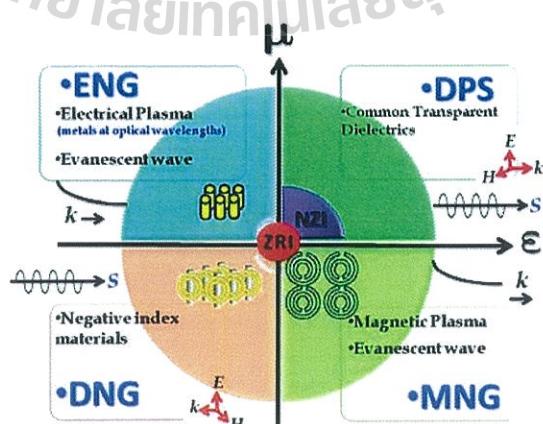
เร โ ช น เ ต อ ร ร อ ม พี ด ค น ช แบบ ข ั น ร ว ง ถ ิ ง ท ե ค น ิ ค ของ อ น เ ต อ ร ร ด ิ จ ิ ต ล า ก า ป ა ช ი თ ე რ ร ท ุ ย ถ ိ แบบ ร ู ป กา ร แ ฟ ่ ล ั ง จ า น แ ล ะ ສ ა ხ ა კ ა დ ი პ ლ จ า გ ა რ ე ნ ი ნ ჰ ვ ა ხ ი ძ ი პ

2.3 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากอุปกรณ์สื่อสารสามารถรองรับการใช้งานได้หลายความถี่ เราจึงได้ออกแบบตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุที่รองรับการใช้งานได้มากกว่าหนึ่งความถี่ โดยในงานวิจัยนี้ตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุที่ออกแบบจะมีลักษณะที่เล็ก ใช้งานง่าย ให้อัตราขยายที่สูงกว่าแผ่นตัวสะท้อนปกติ หมายความว่าแก่การนำไปใช้งานร่วมกับสายอากาศมากกว่าแผ่นตัวสะท้อนทั่วไป โดยจากการปรับใช้เทคนิคและทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีและหลักการที่นำมาใช้ในการออกแบบ ได้แก่ ผิวอวิวัสดุ เรโซโนเตอร์ร่วงแหวน ทฤษฎีเรโซโนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้น โหลดความจุแบบอินเตอร์-ดิจิตอลหรืออินเตอร์ดิจิตอลคาปaziเตอร์และทฤษฎีของสายอากาศ ดังต่อไปนี้

2.3.1 คณสมบัติพิเศษ

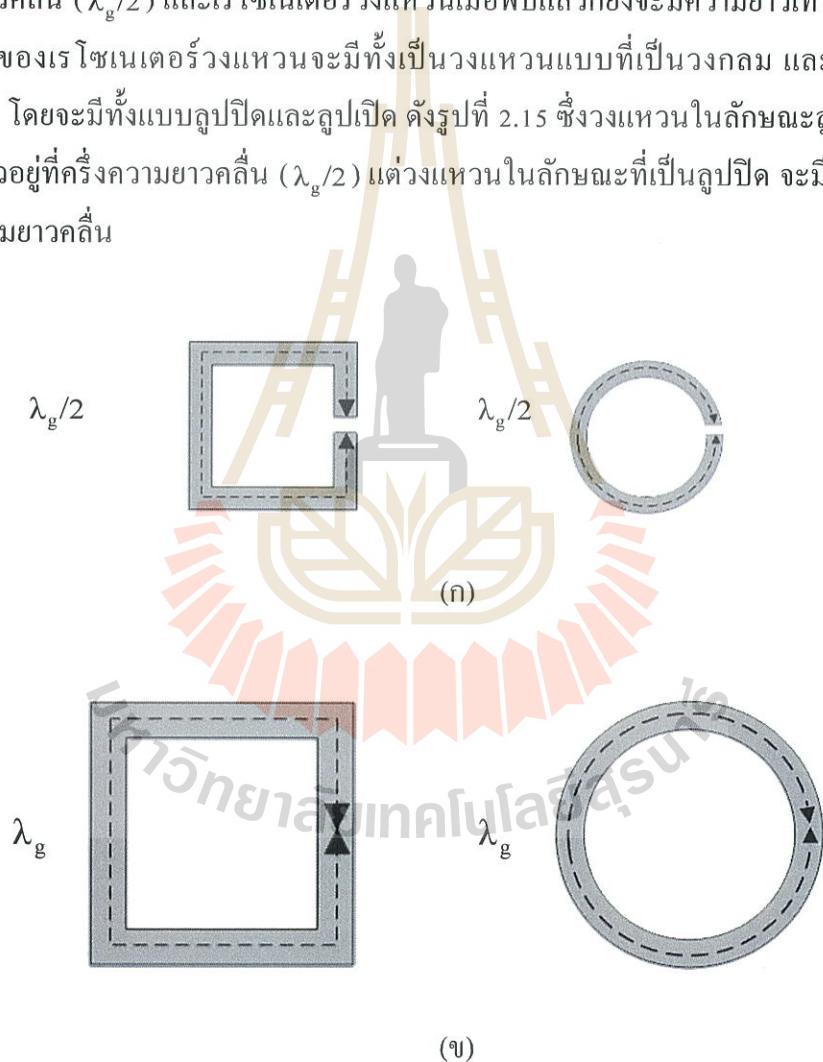
ผิวอวัยวะสดุ เป็นหนึ่งในอวัยวะสดุ แต่โครงสร้างของผิวอวัยวะสดุนั้นจะมีลักษณะเป็นสองมิติ เป็นวัสดุเทียม มีลักษณะโครงสร้างที่ไม่ต ähnlich ขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับความยาวคลื่น โดยผิวอวัยวะสดุจะมีคุณสมบัติหลักดังแสดงในรูปที่ 2.14 คุณสมบัติหลักของผิวอวัยวะสดุแบ่งได้ดังนี้ 1. เมื่อค่าของสภาพย้อมเป็นลบและค่าซึ่งชานเป็นบวกจะเรียกว่า ENG (Epsilon Negative Medium) 2. เมื่อค่าซึ่งชานเป็นลบและค่าของสภาพย้อมเป็นบวกจะเรียกว่า MNG (Mu Negative Medium) และนอกจากนี้ยังมีอีกคุณสมบัติที่ไม่ปกติของผิวอวัยวะสดุที่ได้รับความสนใจอย่างมากอีกอย่างคือวัสดุที่มีดัชนีหักเหนิ่มค่าเป็นศูนย์หรือใกล้เคียงศูนย์ (Zero Refractive Index: ZRI or Near Zero Refractive Index: NZI) ซึ่งแต่ละคุณสมบัติของผิวอวัยวะสดุก็จะให้ผลที่แตกต่างกันออกไป



รูปที่ 2.14 แสดงคุณสมบัติของผิวอกริวัสดุ (S. Chaimool and P. Akkaraekthalin, 2011)

2.3.2 เรโซโนเตอร์ร่วงแหวน

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของเรโซโนเตอร์อุ่นความมากๆ ซึ่งพบว่าจะช่วยให้ล้านนี้มีลักษณะรูปร่างพื้นฐานอยู่ 5 รูปแบบหลัก (สมบูรณ์ ชีริวิศิษฐ์พงศ์, 2556) ดังนี้ เรโซโนเตอร์เส้นตรง (Straight -line Resonator) เรโซโนเตอร์อินเตอร์ดิจิตอล (Interdigital Resonator) เรโซโนเตอร์รูปปีนปักผน (Hairpin Resonator) เรโซโนเตอร์ร่วงแหวน (Ring Resonator) เรโซโนเตอร์อัมพ์เดนซ์แบบขั้น (Stepped - Impedance Resonator) ซึ่งเรโซโนเตอร์ร่วงแหวน เกิดจาก การพับ หรือหักงอมาจากการเรโซโนเตอร์เส้นตรง ซึ่งเรโซโนเตอร์เส้นตรงนี้จะมีความยาวคือครึ่ง ความยาวคลื่น ($\lambda_g/2$) และเรโซโนเตอร์ร่วงแหวนเมื่อพับแล้วก็ยังจะมีความยาวเท่าเดิมเช่นกัน โดย แบบรูปของเรโซโนเตอร์ร่วงแหวนจะมีทั้งเป็นวงแหวนแบบที่เป็นวงกลม และวงแหวนที่เป็น สี่เหลี่ยม โดยจะมีทั้งแบบลูปปิดและลูปเปิด ดังรูปที่ 2.15 ซึ่งวงแหวนในลักษณะลูปปิดจะมีขนาด ความยาวอยู่ที่ครึ่งความยาวคลื่น ($\lambda_g/2$) แต่วงแหวนในลักษณะที่เป็นลูปปิด จะมีความยาวเท่ากับ หนึ่งความยาวคลื่น



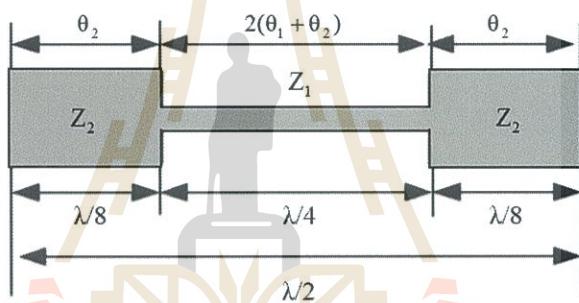
รูปที่ 2.15 เรโซโนเตอร์ร่วงแหวน (สมบูรณ์ ชีริวิศิษฐ์พงศ์, 2556)

(ก) แบบลูปปิด (Open loop)

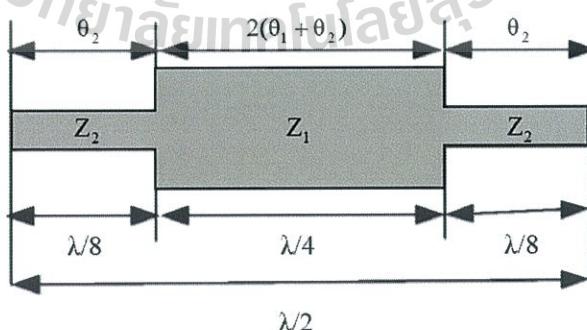
(ข) แบบลูปปิด (Close loop)

2.3.3 เรโซเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้น

เรโซเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้น คือ โครงสร้างเรโซเนเตอร์ที่มีค่าอิมพีเดนซ์คุณลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะแตกต่างกันสองส่วนหรืออาจจะแตกต่างกันหลาย ๆ ส่วน (พงศธร ชมทอง, 2554) โดยเรโซเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้นจะสามารถพิจารณาคุณสมบัติได้ดังนี้ ถ้าค่าของอิมพีเดนซ์ต่างๆจะทำให้ขนาดของสายนำสัญญาณมีความกว้างและในทางกลับกัน ถ้าค่าของอิมพีเดนซ์นั้นมีค่าสูงจะทำให้ขนาดของสายนำสัญญาณแคบ ซึ่งจากรูปที่ 2.16 และ รูปที่ 2.17 โครงสร้างเรโซเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้นจะมี Z_1 และ Z_2 เป็นอิมพีเดนซ์แตกต่างกัน ทำให้เราพิจารณาโครงสร้างเรโซเนเตอร์แบบขั้นจากอัตราส่วนระหว่างอิมพีเดนซ์ได้คือโครงสร้างเรโซเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้นที่มีอัตราส่วนระหว่างอิมพีเดนซ์น้อยกว่าหนึ่งและอัตราส่วนระหว่างอิมพีเดนซ์แบบขั้นมากกว่าหนึ่ง



รูปที่ 2.16 โครงสร้างเรโซเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้นเมื่ออัตราส่วนระหว่างอิมพีเดนซ์ $K < 1$
(พงศธร ชมทอง, 2554)



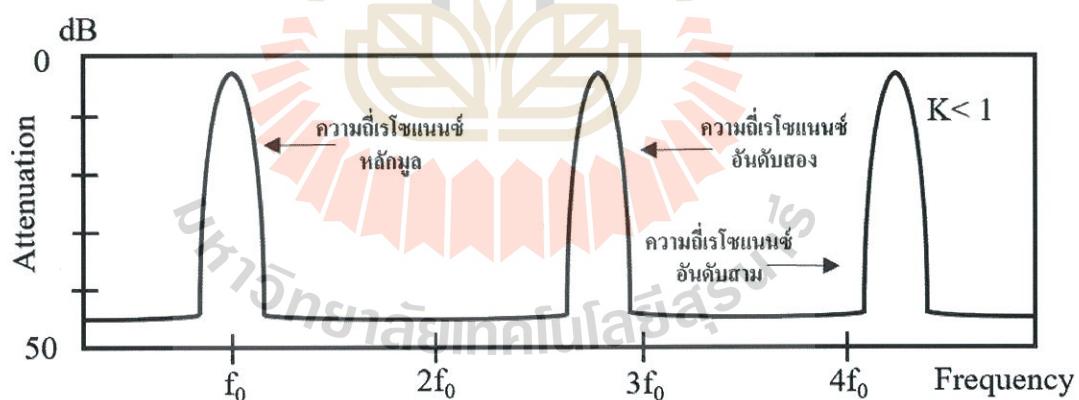
รูปที่ 2.17 โครงสร้างเรโซเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้นเมื่ออัตราส่วนระหว่างอิมพีเดนซ์ $K > 1$
(พงศธร ชมทอง, 2554)

โดยจากรูปที่ 2.16 และ รูปที่ 2.17 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของเรโซโนเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้นที่มีค่าของอิมพีเดนซ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้สามารถพิจารณาอัตราส่วนระหว่างอิมพีเดนซ์ K เพื่อทำการควบคุมความถี่เรโซแนนซ์หรือความถี่ชาร์มอนิกส์ ซึ่งถ้าต้องการให้ความถี่ชาร์มอนิกส์ เลื่อนออกห่างจากความถี่มูลฐานหรือให้ความถี่ชาร์มอนิกส์เพิ่มขึ้น จะต้องออกแบบโครงสร้างเรโซโนเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้นใหม่มีอัตราส่วนระหว่างอิมพีเดนซ์ $K < 1$ แต่ถ้าหากต้องการให้ความถี่ชาร์มอนิกส์เลื่อนเข้าใกล้ความถี่ เเรโซแนนซ์หลักมูลหรือความถี่มูลฐานหรือให้ความถี่ชาร์มอนิกส์มีค่าลดลงจะต้องออกแบบโครงสร้างเรโซโนเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้นใหม่มีอัตราส่วนระหว่างอิมพีเดนซ์ $K > 1$ โดยอัตราส่วนระหว่างอิมพีเดนซ์หาได้จากสมการ 3.1

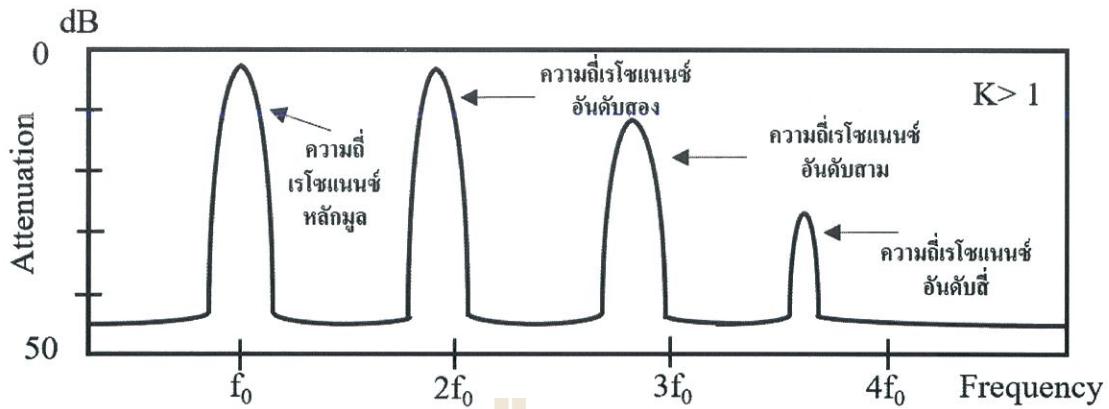
$$K = \frac{Z_2}{Z_1} \quad (2.1)$$

โดยที่

$$K = \tan\theta_1 \tan\theta_2 \quad (2.2)$$



รูปที่ 2.18 ค่าการเลื่อนและการลดทอนของความถี่เรโซแนนซ์ที่เกิดจากเรโซโนเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้น ค่าอัตราส่วนระหว่างอิมพีเดนซ์ $K < 1$ (พงศธร ชุมทอง, 2554)



รูปที่ 2.19 ค่าการเลื่อนและการลดthonของความถี่เรโซแนนซ์ที่เกิดจากเรโซเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้น ค่าอัตราส่วนระหว่างอิมพีเดนซ์ $K > 1$ (พงศธร ชนาทอง, 2554)

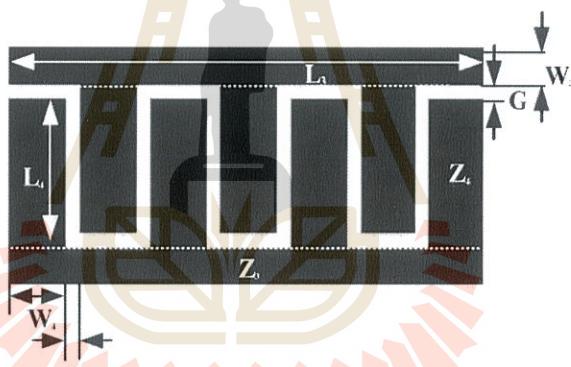
จากภาพที่ 2.18 จะเห็นได้ว่าเมื่ออัตราส่วนระหว่างอิมพีเดนซ์ $K < 1$ ที่ความถี่มูลฐานจะยังคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยความถี่ harmonic ก็จะไม่เกิดเป็นจำนวนเท่าของค่าความถี่มูลฐาน ซึ่งตามปกติแล้วนั้นถ้าหากอัตราส่วนระหว่างอิมพีเดนซ์เท่ากับหนึ่ง ($K=1$) ความถี่ harmonic ก็จะต้องมีค่าเป็นจำนวนเท่าของค่าความถี่มูลฐาน โดยในรูปที่ 2.18 นี้แสดงให้เห็นว่าการที่อัตราส่วนระหว่างอิมพีเดนซ์ไม่เท่ากันนั้นจะทำให้ความถี่ harmonic เลื่อนออกไปไกลจากความถี่มูลฐาน จากรูปที่ 2.19 จะเห็นได้ว่าเมื่ออัตราส่วนระหว่างอิมพีเดนซ์ $K > 1$ ที่ความถี่มูลฐานจะยังคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ที่ความถี่ harmonic สั้นจะเลื่อนเข้าใกล้ความถี่มูลฐานและจะเกิดการลดthonของสัญญาณที่ความถี่ harmonic ที่ความถี่มูลฐานที่ค่ามากที่สุด

2.3.4 โหลดความจุแบบอินเตอร์ดิจิตอล (Interdigital Capacitor)

ปัจจุบัน โหลดความจุแบบอินเตอร์ดิจิตอลหรืออินเตอร์ดิจิตอลค่าปานิชิเตอร์ได้ถูกเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย (Lee, Oh and Myung, 2006) (Chomtong, Akkaraekthalin and Vivek, 2013) (Li et al., 2007) จะเห็นได้ว่าการเพิ่มอินเตอร์ดิจิตอลค่าปานิชิเตอร์เข้าไปในโครงสร้างงาน จะทำให้ชิ้นงานมีขนาดเล็กลงและได้ความถี่ที่ตรงตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งได้มีงานวิจัยที่ได้เปรียบเทียบขนาดก่อนและหลังใส่อินเตอร์ดิจิตอลค่าปานิชิเตอร์เข้าไปแล้วสามารถทำให้ขนาดของชิ้นงานลดลง (Fengliu Xu, et al., 2010) จากการเพิ่มค่าของตัวเก็บประจุ เปรียบเสมือนว่าเราได้เพิ่มค่าของตัวเก็บประจุเข้าไปในวงจร ซึ่งเมื่อ capacitance load $\neq 0$ จะแสดงให้เห็นว่าความถี่จะลดลงจากค่าของตัวเก็บประจุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการที่เพิ่มอินเตอร์ดิจิตอลค่าปานิชิเตอร์เข้าไปก็เหมือนเพิ่มค่าของตัวเก็บประจุให้ความถี่เรโซแนนซ์ลดลง ตามสมการที่ 3.3

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (2.3)$$

จะเห็นว่าการที่เพิ่มอินเตอร์ดิจิตอลเข้าไปไม่เพียงแต่ควบคุมความถี่ได้ แต่ยังสามารถทำให้ชิ้นงานมีขนาดเล็กลงอีกด้วย ซึ่งทั้งจำนวนของตัวเก็บประจุ ความกว้างของฟัน รวมทั้งความยาวของอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊บไซเตอร์ ส่วนแต่ละผลต่อความถี่และขนาดของชิ้นงาน (Quanqi Zhang, Yuanxin Li, Zhixi Liang, Hong-Zhou Tan and Yunliang Long, 2014) (Lung-Hwa Hsieh and Kai Chang, 2002) และพบว่าปรากฏการณ์ของคลื่นช้า (slow wave effect) ที่อยู่ในอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊บไซเตอร์ก็ให้ผลในการทำงานเดียวกันกับอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊บไซเตอร์ ดังนั้นอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊บไซเตอร์สามารถลดขนาดของชิ้นงานลงได้ สำหรับโครงสร้างเรโซแนเตอร์อินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊บไซเตอร์ จะแสดงดังในรูป 2.20



รูปที่ 2.20 โครงสร้างเรโซแนเตอร์อินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊บไซเตอร์

2.3.5 ทฤษฎีของสายอากาศ

ในการออกแบบสายอากาศเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะต้องคำนึงถึงพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น ค่าของการสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับ (return loss) และแบบรูปการแผ่พลังงาน (radiation pattern) เป็นต้น

2.3.5.1 การสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับ

การสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับเป็นการแสดงถึงค่าการสูญเสียเมื่อป้อนพลังงานให้กับสายอากาศและยังสามารถแสดงถึง ช่วงแบนค์วิดท์ของสายอากาศที่สามารถทำงานได้ โดยมีค่าเท่ากับหรือต่ำกว่า -10 dB รวมทั้งแสดงถึงคุณลักษณะของอัตราส่วน คลื่นนิ่ง (Standing

Wave Radio, SWR) โดยค่า SWR และค่าการสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ (Voltage reflection coefficient)

$$\Gamma = \frac{V_r}{V_i} \quad (2.4)$$

เมื่อ Γ คือ สัมประสิทธิ์แรงดันสะท้อนกลับ

V_r คือ แรงดันสะท้อนกลับ

V_i คือ แรงดันตอกกระแทบ

จากสมการที่ (2.5) ถ้าสัมประสิทธิ์แรงดันสะท้อนกลับมีค่าเป็นบวกแสดงว่าแรงดันสะท้อนกลับมีเฟสตรงกัน (in phase) แต่ถ้าเครื่องหมายเป็นลบแสดงว่าแรงดันสะท้อนกลับมีเฟสตรงกันข้าม (out of phase) การหาค่าเปอร์เซ็นต์ของคลื่นแรงดันสะท้อนกลับหาได้ดังนี้

$$\% \text{ แรงดันสะท้อนกลับ} = \Gamma \times 100 \quad (2.5)$$

กำลังงานหาได้จากแรงดันยกกำลังสองหารด้วยออมพีเดนซ์คุณลักษณะ Z_C

$$P = \frac{V^2}{Z_C} \quad (2.6)$$

จะนั่นสัมประสิทธิ์กำลังงานสะท้อนกลับ (Power reflection coefficient)

มีค่าเท่ากับกำลังสองของค่าสัมประสิทธิ์แรงดันสะท้อนกลับ

$$\Gamma^2 = \frac{P_r}{P_i} \quad (2.7)$$

เมื่อ Γ คือ สัมประสิทธิ์แรงดันสะท้อนกลับ

P_r คือ กำลังงานสะท้อนกลับ

P_i คือ กำลังงานตอกกระแทบ

เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้โดย

$$\% \text{ แรงดันสะท้อนกลับ} = \Gamma^2 \times 100 \quad (2.8)$$

นอกจากนี้สัมประสิทธิ์แรงดันสะท้อนกลับยังสามารถหาได้จากอัตราส่วนของผลต่างและผลรวมระหว่างโหลดกับอิมพีเดนซ์คุณลักษณะของสายนำสัญญาณ

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C} \quad (2.9)$$

โดยที่ Z_C และ Z_L เป็นอิมพีเดนซ์ของสายส่งและอิมพีเดนซ์ของโหลด เนื่องจาก อิมพีเดนซ์คุณลักษณะของสายส่งเท่ากับ 50 โอห์ม อิมพีเดนซ์โหลด ก็คือสายอากาศที่เราทำการ ออกแบบ ถ้าสามารถออกแบบให้เท่ากับ 50 โอห์มก็จะไม่เกิดการสะท้อนกลับ แต่ถ้า ไม่เท่ากับ 50 โอห์ม ก็จะเกิดการสะท้อนกลับจากโหลดไปยังแหล่งกำเนิด ทำให้เกิดคลื่นนิ่ง (SWR) ในสายส่ง โดยการวัดค่า SWR เป็นอัตราส่วนระหว่างของแอมเพลจูดสูงสุดของคลื่นนิ่งกับ แอมเพลจูดต่ำสุดของคลื่นนิ่ง โดยค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ของอัตราส่วนคลื่นนิ่ง คือมีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 2.0 สามารถคำนวณได้จากสมการ (2.10)

$$SWR = \frac{v_{\max}}{v_{\min}} = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|} \quad (2.10)$$

ตัดไปเป็นการทดสอบสมการสูญเสียข้อนี้เมื่อจากการย้อนกลับของสายอากาศ โดยมี ความสัมพันธ์เหมือนกับค่าของอัตราส่วนคลื่นนิ่ง โดยสามารถคำนวณได้จากสมการที่ (2.10)

$$\text{Return Loss} = 10 \log |S_{11}|^2 = -20 \log (|\Gamma|) \quad (2.11)$$

เนื่องจากการแมตซ์อิมพีเดนซ์ของสายอากาศที่ดี ค่าของการสูญเสียข้อนกลับต้อง น้อยกว่า 10 dB เมื่อคำนวณข้อนกลับแล้วค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนต้องน้อยกว่า 0.3162 ส่งผลให้ ค่าอัตราส่วนคลื่นนิ่ง น้อยกว่า 2 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรก (ภาวิชี ศุวรรณทา, 2559)

2.3.5.2 แบบรูปการแผ่พลังงาน

แบบรูปการแผ่พลังงาน (Radiation Pattern) คือ รูปภาพที่ใช้แสดง คุณสมบัติของการแพร่กระจายคลื่น โดยแบบรูปการแผ่พลังงานของสายอากาศสามารถแบ่ง ออกเป็นดังนี้

แบบรูปไอโซโทรอปิก (Isotropic Pattern) จะเป็นแบบรูปการแผ่พลังงานของสายอากาศที่มีการแผ่พลังงานออกไปในทุกทิศทุกทางเท่ากันทั้งหมดเสมือนมีลักษณะเป็นรูปทรงกลม ซึ่งในความเป็นจริงนั้นไม่มีสายอากาศใดเลยที่มีแบบรูปการแผ่พลังงานในลักษณะเช่นนี้ทั้งในทฤษฎีและปฏิบัติ จึงถือว่าเป็นแบบรูปที่มีลักษณะที่เป็นอุดมคติมากกว่า บางครั้งเรียกว่า ตัวแผ่พลังงานแบบไอโซโทรอปิก (Isotropic Pattern) อย่างไรก็ตามมักจะถูกนำมาใช้ในการกำหนดพารามิเตอร์ตัวอื่น ๆ ของสายอากาศ

สายอากาศแบบมีทิศทาง (Directional Antenna) คือ สายอากาศที่มีคุณสมบัติในการแผ่พลังงานหรือรับกำลังเข้ามาในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าทิศทางอื่น โดยคำศัพท์ที่มักจะใช้กับสายอากาศที่มีสภาพเจาะจงทิศทาง (Directivity) มากกว่าของสายอากาศได้โดยครึ่งคลื่น (Half-Wavelength Dipole)

สายอากาศแบบรอบทิศทางในระนาบเดียว (Omnidirectional Antenna) คือ สายอากาศที่มีคุณสมบัติในการแผ่พลังงานออกไปรอบตัวในระนาบใดระนาบที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ส่วนระนาบอื่นที่ตั้งฉากกันจะมีการแผ่พลังงานแบบมีทิศทางเดียว ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคุณสมบัติของสายอากาศชนิดที่ทำงานเส้นลวด (รังสรรค์ วงศ์สรรค์, 2555)

2.4 สรุป

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุใช้งานร่วมกับสายอากาศได้โดยซึ่งมีแบบรูปเป็นสายอากาศแบบรอบทิศทางในระนาบเดียวของรับส่งการใช้งานในระบบ LTE และ WLAN โดยเริ่มแรกได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวสะท้อนที่อนทั่วไปซึ่งตัวสะท้อนโดยทั่วไปส่วนใหญ่ทำงานได้ 1 ความถี่ การออกแบบโครงสร้างและติดตั้งมีความซับซ้อน ต่อมาจึงได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผิวอวิวัสดุ เนื่องจากผิวอวิวัสดุมีลักษณะโครงสร้างที่ง่ายต่อการออกแบบ นำไปประยุกต์ใช้งานง่าย มีขนาดเล็ก ซึ่งลักษณะโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อคุณสมบัติของตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ คือเรโซเนเตอร์วงแหวนและแท่งโลหะประดิษฐ์ซึ่งทั้งสองมีผลต่อค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้าและค่าซึมซาบแม่เหล็ก โดยได้ทำการศึกษาลักษณะโครงสร้างที่มีผลต่อความถี่ เพื่อให้สามารถรองรับความถี่ใช้งานได้มากกว่า 1 ความถี่ สำหรับทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องนั้น หัวข้อที่กล่าวถึงได้แก่ ผิวอวิวัสดุเรโซเนเตอร์ วงแหวน เรโซเนเตอร์อมพีแคนเซ็ปแบบขั้น โหลดความจุแบบอินเตอร์ดิจิตอลหรืออินเตอร์ดิจิตอลคาปaziเตอร์ รวมถึงทฤษฎีสายอากาศ เพื่อนำไปปรับใช้ในงานวิจัยนี้ในบทถัดไป

บทที่ 3

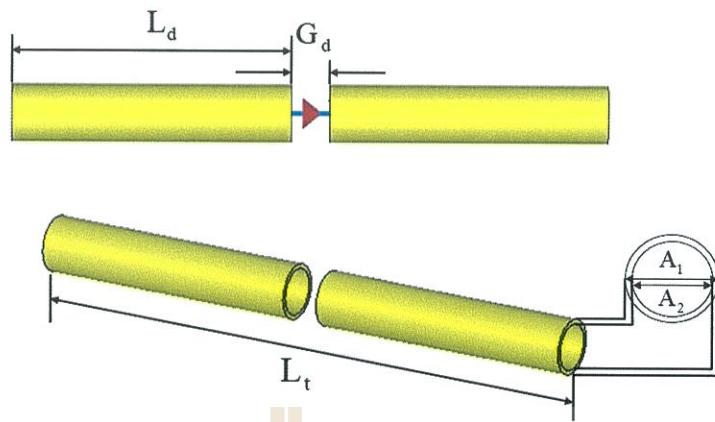
การออกแบบ

3.1 บทนำ

บทนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์และการออกแบบตัวสะท้อนผิวอวัสดุ โดยเป็นการออกแบบเรโทรโซนเตอร์ร่วงแหวนแบบขั้นร่วมกับอินเตอร์ดิจิตอลค่าป่าซิเตอร์ ในการออกแบบเรโทรโซนเตอร์ร่วงแหวนแบบขั้น เป็นการสร้างและควบคุมความถี่ชาร์มอนิกส์ ซึ่งจากปริทศน์วรรณกรรมที่ได้ยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้นั้นจะเห็นได้ว่าโครงสร้างของเรโทรโซนเตอร์ร่วงแหวนซึ่งนักวิจัยส่วนใหญ่ นิยมนิยมนำไปประยุกต์ใช้นั้น จะใช้เรโทรโซนเตอร์ร่วงแหวนเพื่อควบคุมค่าซึ่งมาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้าและใช้เทคนิคแบบขั้น เพื่อควบคุมความถี่ชาร์มอนิกส์ ซึ่งการที่เพิ่มอินเตอร์ดิจิตอลค่าป่าซิเตอร์เข้ามายังสามารถทำให้ขนาดของชิ้นงานมีขนาดที่เล็กลงอีกด้วย ในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบชิ้นงานที่ความถี่ใช้งานเริ่มตั้งแต่ 1.12-2.02 GHz และ 3.45-5.95 GHz สำหรับการประยุกต์ใช้ที่ระบบ LTE และ WLAN ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการออกแบบเพื่อให้มีการทำงานร่วมกับสายอากาศได้โดยจะให้อัตราขยายของสายอากาศที่เพิ่มขึ้น โดยได้ทำการจำลองตัวสะท้อนผิวอวัสดุร่วมกับสายอากาศได้โดยจะมีแบบรูปการແພັດສິນງາມ (directive radiation) หรือคลื่นມีการແພັດຈະກາຍແບບชີທິສາທາງໄປທາງດ້ານหน້າ เมื่อทำงานร่วมกับสายอากาศได้โดยจะให้อัตราขยายของสายอากาศที่เพิ่มขึ้น โดยได้ทำการจำลองตัวสะท้อนผิวอวัสดุร่วมกับสายอากาศได้โดยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป CST เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของตัวสะท้อนผิวอวัสดุที่ใช้งานร่วมกับสายอากาศได้โดย ก่อนที่จะสร้างตัวสะท้อนผิวอวัสดุและสายอากาศได้โดยแบบต้นแบบ ในบทต่อไป

3.2 การจำลองแบบสายอากาศได้โดย

เนื่องจากงานวิจัยนี้ทำการออกแบบตัวสะท้อนผิวอวัสดุที่ทำงานร่วมกับสายอากาศได้โดย จึงต้องทำการจำลองสร้างแบบสายอากาศได้โดยขึ้นมาด้วย โดยสายอากาศได้โดยที่ทำการจำลองแบบนั้นจะมี 2 แบบ คือ สายอากาศได้โดยที่สามารถใช้งานได้ที่ความถี่ 1.8 GHz และสายอากาศได้โดยที่สามารถใช้งานได้ที่ความถี่ 5.5 GHz ซึ่งจะแสดงโครงสร้างของสายอากาศได้โดยในรูปที่ 3.1 และพารามิเตอร์ของสายอากาศได้โดยตามตารางที่ 3.1

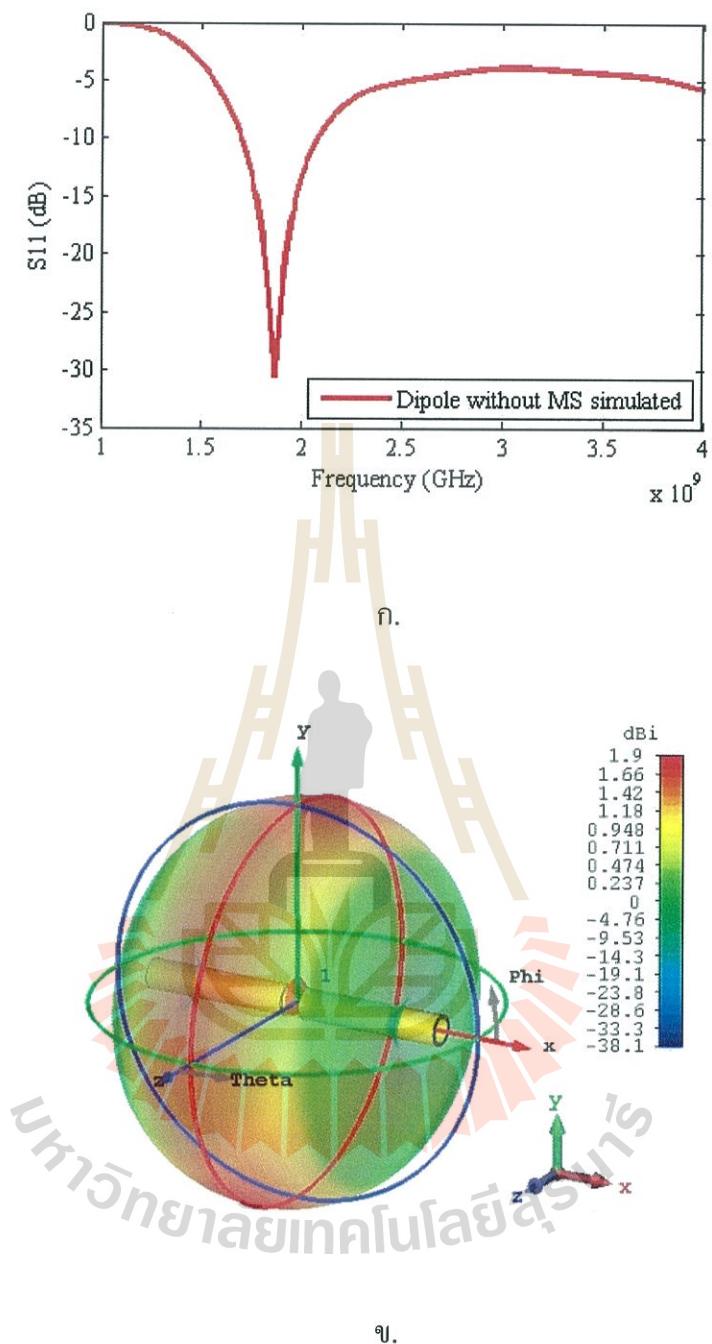


รูปที่ 3.1 โครงสร้างแบบจำลองสายอากาศไนโตรเจน

ตารางที่ 3.1 พารามิเตอร์จากการจำลองแบบสายอากาศไนโตรเจนที่ความถี่ 1.8 GHz และ 5.5 GHz

พารามิเตอร์	ความถี่ 1.8 GHz		ความถี่ 5.5 GHz	
	ขนาด (มิลลิเมตร)	ขนาด (λ)	ขนาด (มิลลิเมตร)	ขนาด (λ)
L_d	29.00	0.17λ	26.50	0.4858λ
L_t	62.00	0.37λ	57.00	1.0450λ
G_d	4.00	0.024λ	4.00	0.0733λ
A_1	6.00	0.036λ	6.00	0.1100λ
A_2	5.00	0.029λ	5.00	0.0917λ

จากรูปที่ 3.2 แบบจำลองสายอากาศไนโตรเจนที่ความถี่ 1.8 GHz โดยรูปที่ 3.2 ก. จะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับที่ต่ำกว่า -10 dB จะครอบคลุมช่วงความถี่ตั้งแต่ 1.68 GHz ถึง 2.08 GHz ซึ่งความถี่ที่เราต้องการใช้งานคือ 1.8 GHz รูปที่ 3.2 ข. จะแสดงแบบรูปการแผ่นลังงานแบบ 3 มิติ และรูปที่ 3.2 ค. แบบรูปการแผ่นลังงานในระนาบสนานแม่เหล็ก สำหรับแบบรูปการแผ่นลังงานในระนาบสนานไฟฟ้าจะแสดงในรูปที่ 3.2 ง.



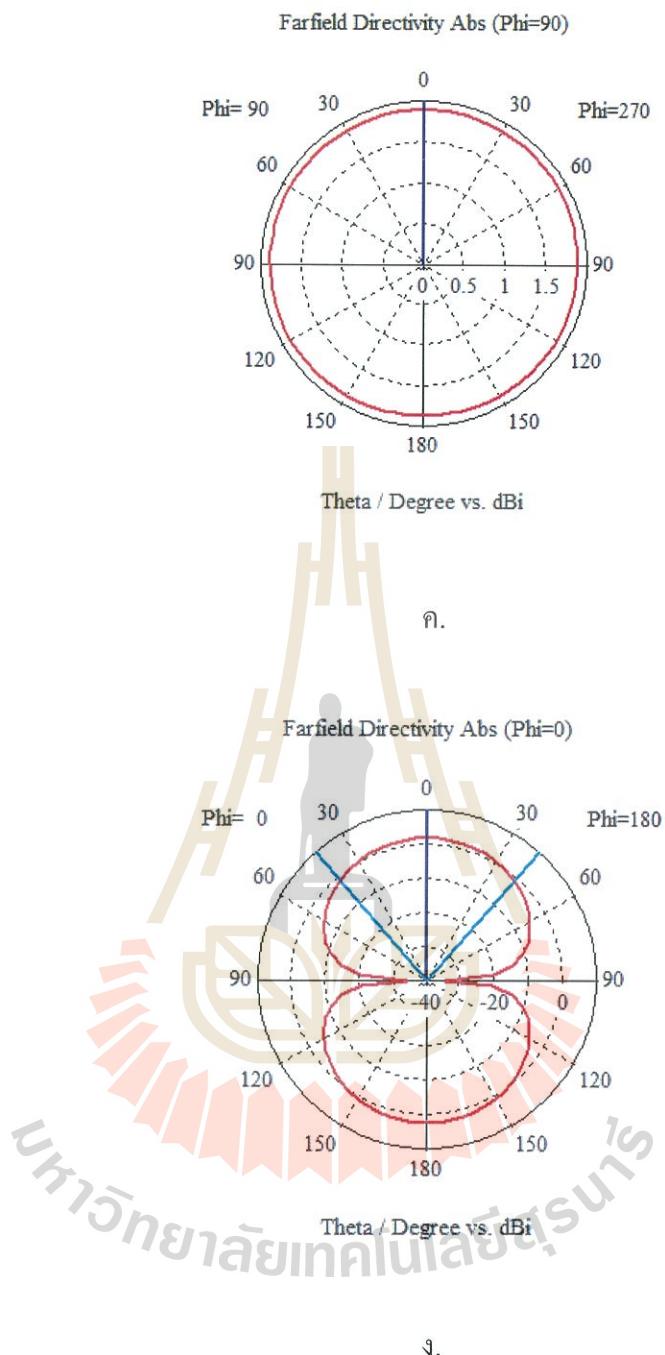
รูปที่ 3.2 แบบจำลองสายอากาศไดโพลที่ความถี่ 1.8 GHz

ก. ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ

ข. แบบรูปการแผ่พลังงานแบบ 3 มิติ

ค. แบบรูปการแผ่พลังงานในระนาบผืนามแม่เหล็ก

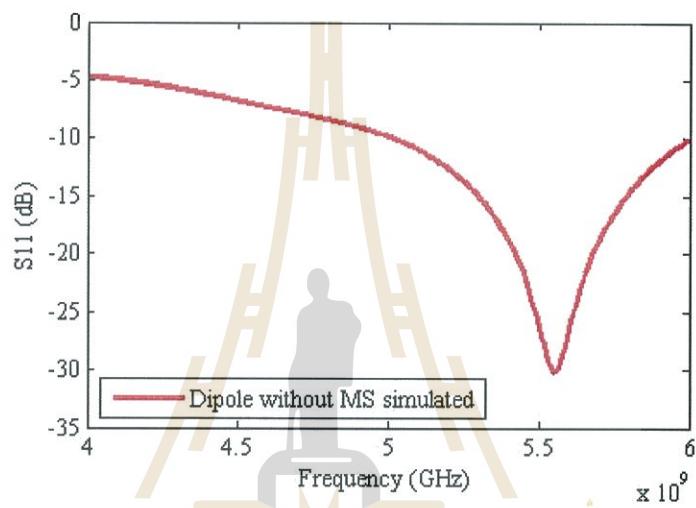
ง. แบบรูปการแผ่พลังงานในระนาบผืนามไฟฟ้า



รูปที่ 3.2 แบบจำลองสายอากาศไดโอลท์ที่ความถี่ 1.8 GHz (ต่อ)

- ก. ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ
- ข. แบบรูปการแผ่พลังงานแบบ 3 มิติ
- ค. แบบรูปการแผ่พลังงานในระนาบสนา�แม่เหล็ก
- ง. แบบรูปการแผ่พลังงานในระนาบสนาમไฟฟ้า

จากรูปที่ 3.3 แบบจำลองสายอากาศไดโอลที่ความถี่ 5.5 GHz โดยรูปที่ 3.3 (ก.) จะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับที่ต่ำกว่า -10 dB จะครอบคลุมช่วงความถี่ตั้งแต่ 5.01 GHz ถึง 5.96 GHz ซึ่งความถี่ที่เราต้องการใช้งานคือ 5.5 GHz รูปที่ 3.3 (ข.) จะแสดงแบบรูปการแพเพลิงงานแบบ 3 มิติ และรูปที่ 3.3 (ค.) แบบรูปการแพเพลิงงานในระบบสนามแม่เหล็กสำหรับแบบรูปการแพเพลิงงานในระบบสนามไฟฟ้าจะแสดงในรูปที่ 3.3 (ง.) และค่าอัตราขยายจะแสดงในตารางที่ 3.2



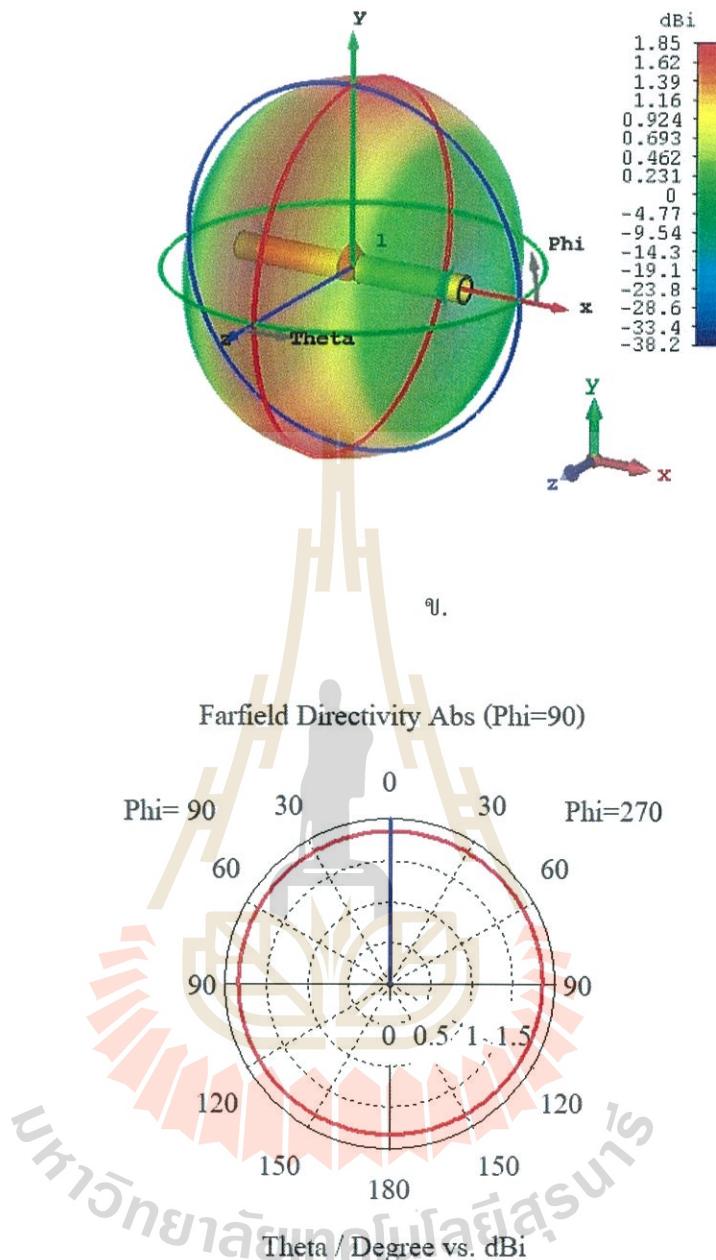
รูปที่ 3.3 แบบจำลองสายอากาศไดโอลที่ความถี่ 5.5 GHz

ก. ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ

ข. แบบรูปการแพเพลิงงานแบบ 3 มิติ

ค. แบบรูปการแพเพลิงงานในระบบสนามแม่เหล็ก

ง. แบบรูปการแพเพลิงงานในระบบสนามไฟฟ้า

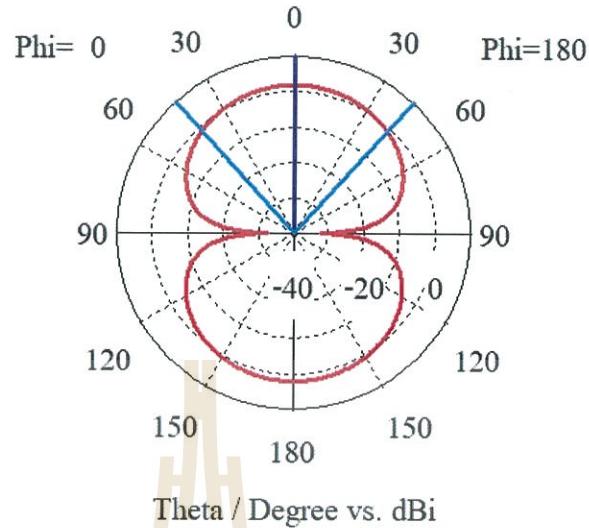


ค.

รูปที่ 3.3 แบบจำลองสายอากาศไดโอดที่ความถี่ 5.5 GHz (ต่อ)

- ก. ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ
- ข. แบบรูปการแผ่พลังงานแบบ 3 มิติ
- ค. แบบรูปการแผ่พลังงานในระนาบสนานแม่เหล็ก
- ง. แบบรูปการแผ่พลังงานในระนาบสนานไฟฟ้า

Farfield Directivity Abs (Phi=0)



รูปที่ 3.3 แบบจำลองสายอากาศไดโอลที่ความถี่ 5.5 GHz (ต่อ)

- ก. ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ
- บ. แบบรูปการแผ่พลังงานแบบ 3 มิติ
- ค. แบบรูปการแผ่พลังงานในระนาบสันમแม่เหล็ก
- ง. แบบรูปการแผ่พลังงานในระนาบสันมไฟฟ้า

ตารางที่ 3.2 ค่าอัตราขยายจากผลการจำลองสายอากาศไดโอล

ความถี่ (GHz)	อัตราขยาย (dBi)
1.8	1.9
5.5	1.85

3.3 การออกแบบตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุโดยพิจารณาユニตเซลล์ (Unit cell)

3.3.1 การออกแบบโดยใช้เรโซเนเตอร์ร่วงเหวน

การออกแบบตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ โดยพิจารณาユニตเซลล์เริ่มจากการออกแบบ เรโซเนเตอร์ร่วงเหวนแบบสี่เหลี่ยมขึ้นมา 1 วงเหวน ซึ่ง ได้กำหนดความถี่เรโซโนนซ์ที่ความถี่คลัง $f_0 = 1.8 \text{ GHz}$ โดยใช้วัสดุแผ่นพิมพ์วงจร FR-4 ที่มีค่าคงตัวไดอเล็กทริก $\epsilon_r = 4.3$ และมีความหนา

เท่ากับ 1.6 มิลลิเมตร กำหนดให้พารามิเตอร์ของเรโซโนเตอร์ร่วงແວນແບບສື່ເຫຼື່ອມັດນີ້ $W = 1.25$ ມີລັບມືມີ $G = 12$ ມີລັບມືມີ $R_1 = 32$ ມີລັບມືມີ $R_2 = 27$ ມີລັບມືມີ $R_3 = 7.5$ ມີລັບມືມີ $h = 0.035$ ມີລັບມືມີ $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} C^2/N.m^2$ ແລະ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T.m/A$ ໂດຍຈາກການກຳນົດຄ່າພາຣາມີເຕືອຮ່າງລ່າວມາຂ້າງຕົ້ນນີ້ສາມາດນຳມາຄຳນວນຫາຄວາມຄືເຮົາໂຊແນນໜີໄດ້ຈາກສົມກາຣ

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (3.1)$$

f ຄື່ອ ຄວາມຄືເຮົາໂຊແນນໜີ

L ຄື່ອ ດ້ວຍອອກຕົວເໜີຍວ່ານຳ

C ຄື່ອ ດ້ວຍເກີບປະຈຸ

ສາມາດຫາຄ່າຂອງຕົວເໜີຍວ່ານຳແລະຄ່າດ້ວຍເກີບປະຈຸໄດ້ຈາກສົມກາຣ (Jesús Sánchez Pastor, 2017)

$$L_{tot} = \frac{\mu_0 R_1 R_2}{h} \quad (3.2)$$

$$C_{surf} = \frac{\varepsilon_0 [(h + 2w) \times (R_2 + 2R_3)]}{\gamma} \quad (3.3)$$

ຕີ້ງຈາກສົມກາຣ (3.2) ຈະສາມາດຄຳນວນຄ່າດ້ວຍເໜີຍວ່ານຳໄດ້ດັ່ງນີ້

$$\begin{aligned} L_{tot} &= \frac{\mu_0 R_1 R_2}{h} \\ &= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times (32 \times 10^{-3}) \times (27 \times 10^{-3})}{0.035 \times 10^{-3}} \\ &= 31.02 \times 10^{-6} \text{ ພຣີອ } 31.02 \mu H \end{aligned}$$

ຈາກສົມກາຣ (3.3) ຈະສາມາດຄຳນວນຄ່າດ້ວຍເກີບປະຈຸທີ່ພົວອກິວສຸດ ໄດ້ດັ່ງນີ້

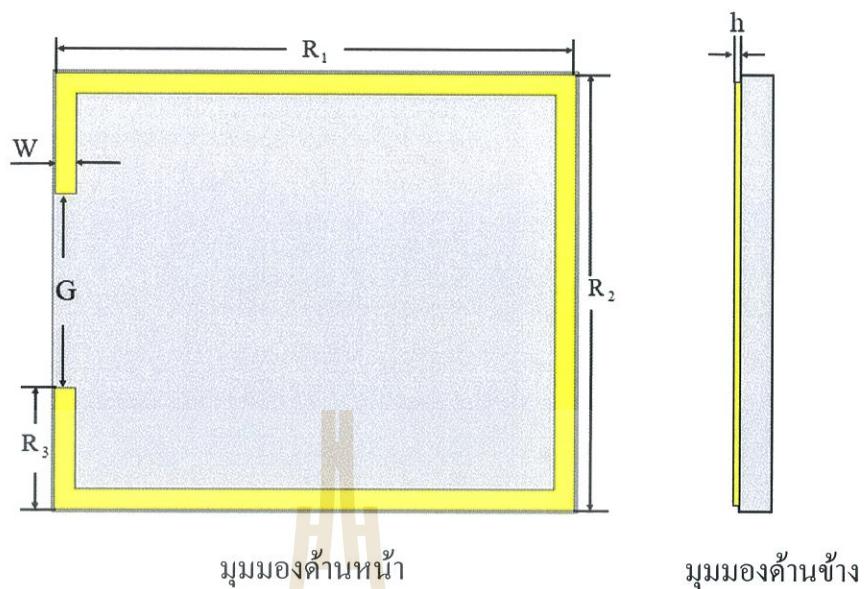
ເນື່ອງ $\gamma = 2.853$ ຄື່ອຄ່າຄົງທີ່ຂອງເຮົາຄົມືຕື່ເຫຼື່ອມັດ (Nor MuzlifahMahyuddin and NurLiyana Abdul Latif, 2013)

$$\begin{aligned}
 C_{\text{surf}} &= \frac{\varepsilon_0 [(h + 2w) \times (R_2 + 2R_3)]}{\gamma} \\
 &= \frac{8.85 \times 10^{-12} [(0.035 \times 10^{-3}) + (2 \times 1.25 \times 10^{-3})] \times (27 \times 10^{-3} + (2 \times 7.5 \times 10^{-3}))}{2.853} \\
 &= 0.33 \times 10^{-15} \text{ หรือ } 0.33 \text{ fF}
 \end{aligned}$$

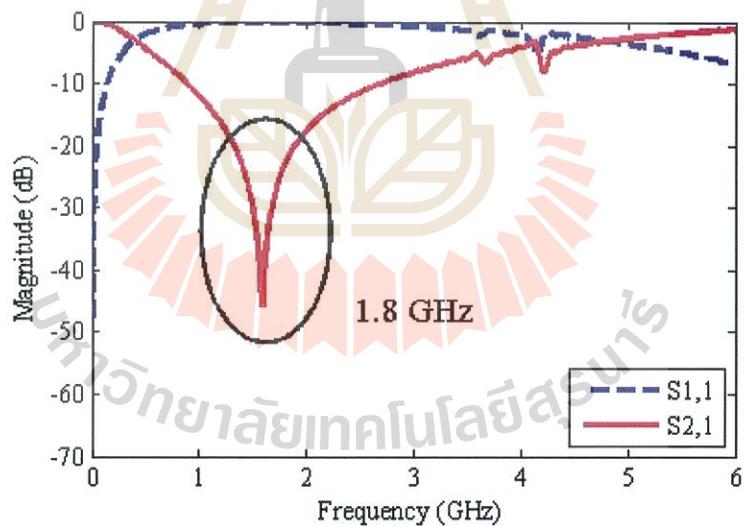
เมื่อได้ค่าตัวเหนี่ยวนำเท่ากับ $31.02 \mu\text{H}$ และค่าตัวเก็บประจุเท่ากับ 0.33 fF จึงสามารถคำนวณค่าของตัวเหนี่ยวนำรวมและค่าตัวเก็บประจุรวมที่ได้นั้นไปคำนวณหาความถี่เรโซแนนซ์ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 f &= \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{\text{tot}}C_{\text{tot}}}} \\
 &= \frac{1}{2\pi\sqrt{31.02 \times 10^{-6} \times (0.33 \times 10^{-15})}} \\
 &= 1.57 \times 10^{-9} \text{ หรือ } 1.57 \text{ GHz}
 \end{aligned}$$

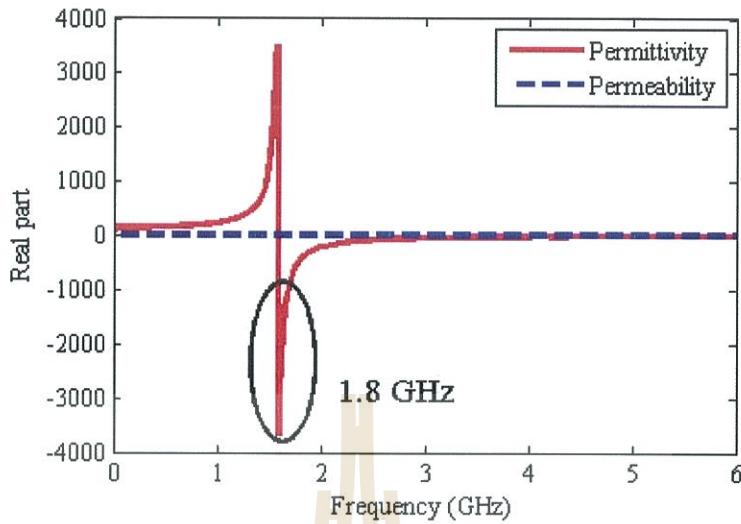
จากนั้นได้นำค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้มาทำการจำลองแบบตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุ โดยแสดงโครงสร้างเรโซเนเตอร์ร่วงเหวนแบบสี่เหลี่ยม 1 วงเหวน ในรูปที่ 3.4 และแสดงผลค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนและค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านดังรูปที่ 3.5 โดยสังเกตได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านที่ความถี่ 1.8 GHz นั้นมีค่าเป็นลบ ทำให้ตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุส่งผ่านได้ไม่ดี ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนนั้นมีค่าเข้าใกล้ 0 ทำให้ตัวสะท้อนผิวอภิวัสดุเกิดการสะท้อนคลื่นที่ช่วงความถี่ 1.8 GHz จึงวิเคราะห์ได้ว่าเรโซเนเตอร์ร่วงเหวนที่ทำการจำลองนี้จะสะท้อนได้ดีที่ความถี่ 1.8 GHz สำหรับค่าสภาพยอมไฟฟ้าและค่าซึมซาบแม่เหล็กจะแสดงในรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.4 โครงสร้างเรโซเนเตอร์วงแหวนพื้นฐาน 1 วงแหวน



รูปที่ 3.5 ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนและค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน
ของเรโซเนเตอร์วงแหวนแบบสี่เหลี่ยม 1 วงแหวน

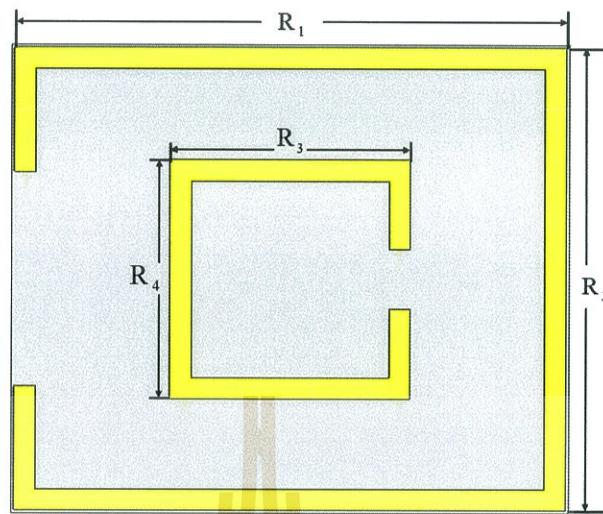


รูปที่ 3.6 ค่าสภายومไฟฟ้าและค่าซึ่งชานแม่เหล็กของเรโซโนเตอร์วงแหวนแบบสี่เหลี่ยม 1 วงแหวน

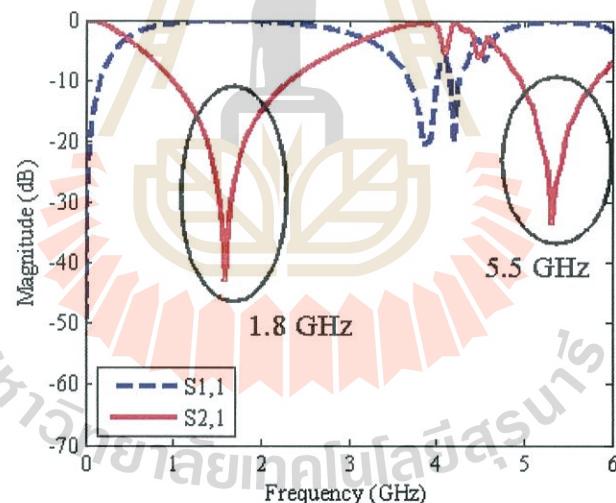
จากการคำนวณหาความถี่เรโซแนนซ์โดยการจำลองเรโซโนเตอร์วงแหวนแบบสี่เหลี่ยม 1 วงแหวน โดยกำหนดค่าพารามิเตอร์นี้จะเห็นได้ว่าผลที่คำนวณมีความถี่เรโซแนนซ์เท่ากับ 1.57 GHz ส่วนผลที่ได้จากการจำลองด้วยโปรแกรมจะมีความถี่เรโซแนนซ์เท่ากับ 1.59 GHz ซึ่งความถี่เรโซแนนซ์ที่ได้นั้นมีค่าที่ใกล้เคียงกันและครอบคลุมย่านความถี่ 1.8 GHz

3.3.2 ศึกษาการออกแบบตัวสะท้อนผิวอวบอุดูโดยใช้เรโซโนเตอร์วงแหวน 2 วงแหวน

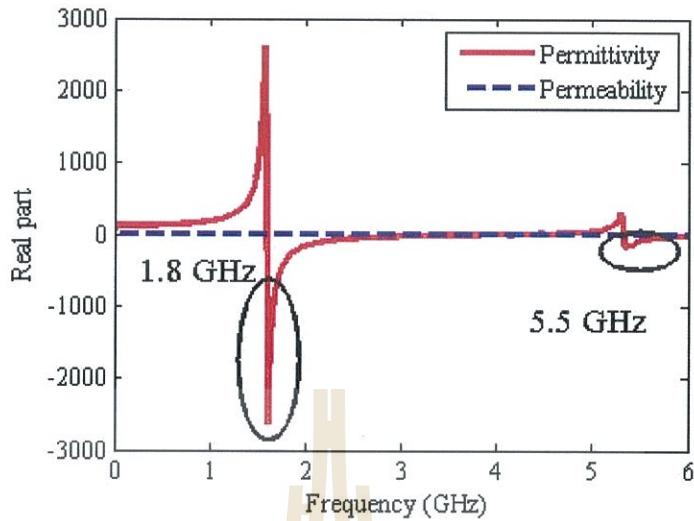
เนื่องจากเรโซโนเตอร์วงแหวน 1 วงแหวน สามารถทำงานได้ 1 ความถี่ ซึ่งงานวิจัยนี้ต้องการที่จะออกแบบตัวสะท้อนผิวอวบอุดูที่สามารถรองรับการใช้งานได้ 2 ความถี่ แต่เนื่องจากว่าเรโซโนเตอร์วงแหวน 1 วงแหวนนั้นสามารถรองรับการใช้งานได้ 1 ความถี่ โดยงานวิจัยส่วนใหญ่ถ้าต้องการให้ใช้งานได้ที่ 2 ความถี่ จะต้องทำการจำลองเรโซโนเตอร์วงแหวน 2 วง ดังแสดงในรูปที่ 3.7 จะแสดงโครงสร้างเรโซโนเตอร์วงแหวน 2 วงแหวน โดยวงนอกมีขนาดของเรโซโนเตอร์-วงแหวน $R_1 = 32$ มิลลิเมตร และ $R_2 = 27$ มิลลิเมตร ส่วนวงในมีขนาดของเรโซโนเตอร์-วงแหวน $R_3 = 14$ มิลลิเมตร และ $R_4 = 14$ มิลลิเมตร รูปที่ 3.8 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนและค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านของเรโซโนเตอร์วงแหวน 2 วงแหวน ซึ่งจะมีค่าสภายومไฟฟ้าและค่าซึ่งชานแม่เหล็กของเรโซโนเตอร์วงแหวน 2 วงแหวน ดังแสดงในรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.7 โครงสร้างเรโซเนเตอร์วงแหวนแบบสี่เหลี่ยม 2 วงแหวน



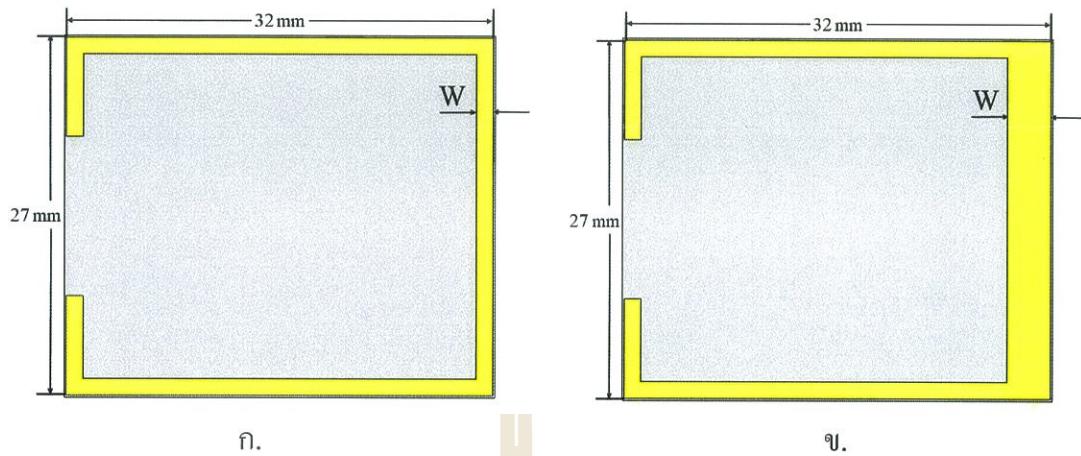
รูปที่ 3.8 ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนและค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน
ของเรโซเนเตอร์วงแหวนแบบสี่เหลี่ยม 2 วงแหวน



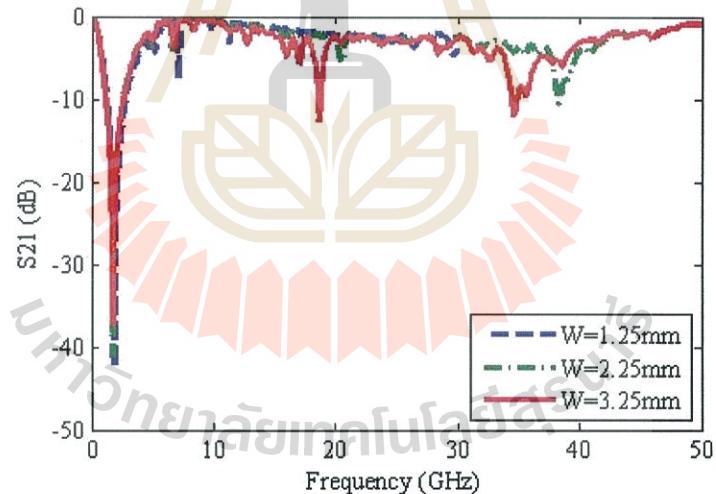
รูปที่ 3.9 ค่าสภารอยม์ไฟฟ้าและค่าซึ่งชามแม่เหล็กของเรโซโนเตอร์วงแหวนแบบสี่เหลี่ยม 2 วงแหวน

3.3.3 ศึกษาการออกแบบตัวสะท้อนผิวอวัสดุโดยใช้เรโซโนเตอร์วงแหวนร่วมกับเทคนิคเรโซโนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้น

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการเพิ่มเรโซโนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้นให้กับเรโซโนเตอร์วงแหวนพื้นฐานดังแสดงในรูปที่ 3.10 ก. เพื่อปรับให้ความถี่ darm อนิกส์สามารถใช้งานได้ ซึ่งจะแสดงโครงสร้างของเรโซโนเตอร์วงแหวนร่วมกับเรโซโนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้นดังรูปที่ 3.10 ข. จากการเพิ่มเรโซโนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้นเมื่อค่า W กว้างขึ้นจะทำให้ความถี่ darm อนิกส์มีค่าลดลงถ้า W แคบลงจะทำให้ความถี่ darm อนิกส์มีค่าเพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 3.11



รูปที่ 3.10 โครงสร้างของเรโซเนเตอร์ร่วงเหวนร่วมกับเรโซเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้น
ก. โครงสร้างของเรโซเนเตอร์ร่วงเหวน
ข. โครงสร้างของเรโซเนเตอร์ร่วงเหวนร่วมกับเรโซเนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้น

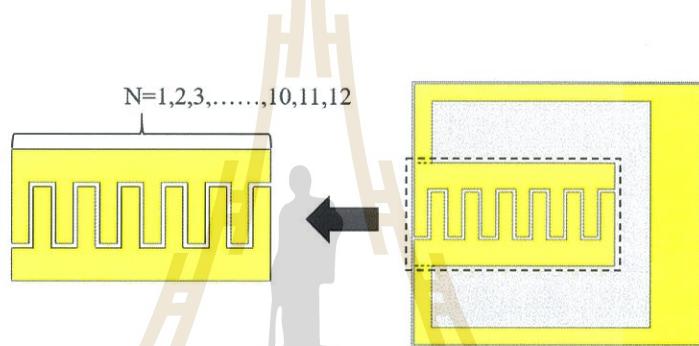


รูปที่ 3.11 ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านของเรโซโนเตอร์วงแหวนร่วงกับ
เรโซโนเตอร์อิมพีเดนซ์แบบขั้น

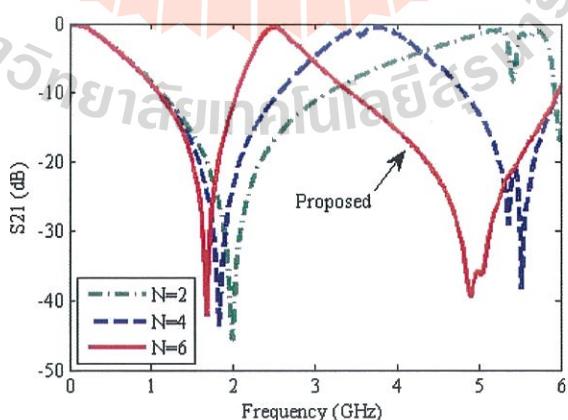
3.3.4 ศึกษาการออกแบบตัวสะท้อนผิวอวิสุดโดยใช้เรโซเนเตอร์ร่วงແหวนร่วมกับ

เทคนิคเรโซเนเตอร์อิมพิเดนซ์แบบขั้น และเทคนิคอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊ซิเตอร์

เนื่องจากการใช้เรโซเนเตอร์ร่วงແหวนร่วมกับเทคนิคของเรโซเนเตอร์อิมพิเดนซ์-แบบขั้นนั้นยังทำให้ชิ้นงานมีขนาดที่ใหญ่และปรับความถี่iar์มอนิกส์ได้ยาก ในงานวิจัยนี้จึงได้ทำการประยุกต์ใช้อินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊ซิเตอร์ เพื่อลดขนาดของเรโซเนเตอร์ร่วงແหวนและใช้เรโซเนเตอร์อิมพิเดนซ์แบบขั้นทำการปรับควบคุมความถี่iar์มอนิกส์ร่วมกับอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊ซิเตอร์ซึ่งจากรูปที่ 3.12 แสดงโครงสร้างการใช้เรโซเนเตอร์ร่วงແหวนร่วมกับเรโซเนเตอร์อิมพิเดนซ์แบบขั้น และเพิ่มอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊ซิเตอร์โดยปรับจำนวนของอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊ซิเตอร์เพิ่มขึ้น และจากรูปที่ 3.13 จะแสดงค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน



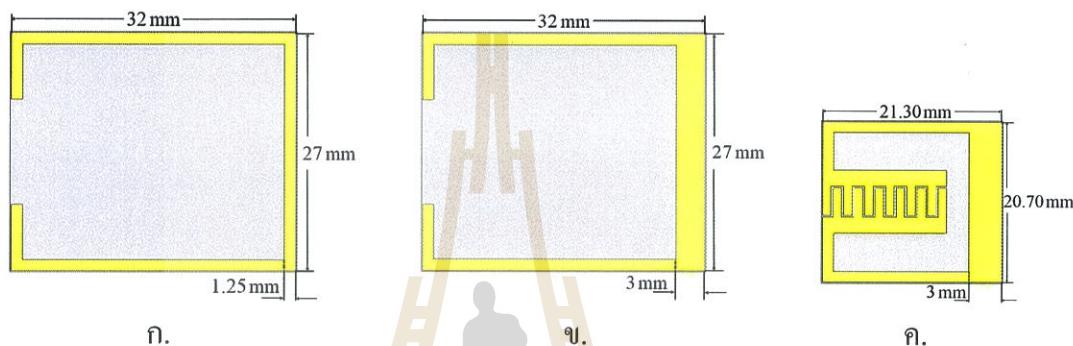
รูปที่ 3.12 โครงสร้างการใช้เรโซเนเตอร์ร่วงແหวนร่วมกับเรโซเนเตอร์อิมพิเดนซ์แบบขั้น และอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊ซิเตอร์



รูปที่ 3.13 ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน (S_{21}) ที่ได้จากการปรับเพิ่มจำนวนฟันของ อินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊ซิเตอร์ (N)

3.3.5 สรุปการศึกษาการออกแบบตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ

งานวิจัยนี้ได้ออกแบบตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุโดยเริ่มจากโครงสร้างพื้นฐานเร ไซเนเตอร์ร่วงเหวน รูป 3.14 ก. โดยใช้เทคนิคเพิ่มอินพีเดนซ์แบบขั้น รูป 3.14 ข. เพื่อช่วยในการปรับและควบคุมความถี่谐振อนิกส์ ซึ่งจะเห็นว่าในรูป 3.14 ก. และรูป 3.14 ข. ขนาดของชิ้นงานมีขนาดที่ใหญ่ จึงได้เพิ่มอินเตอร์ดิจิตอลคาปาซิเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในโครงสร้างเพื่อให้ชิ้นงานมีขนาดเล็กลงที่ ($\lambda/4$) แสดงในรูป 3.14 ค.

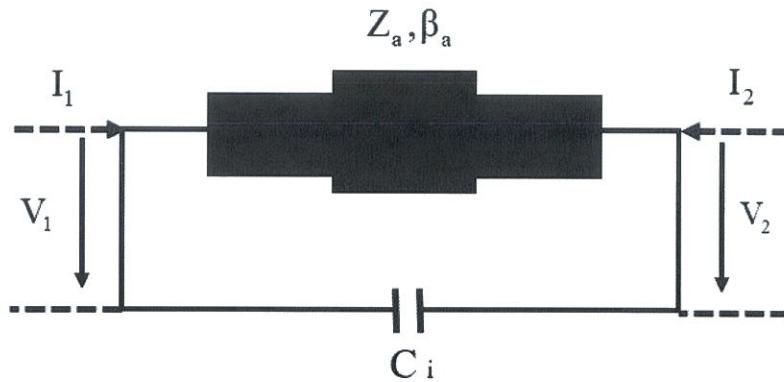


รูปที่ 3.14 รูปแบบโครงสร้างของตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ

- ก. โครงสร้างพื้นฐานเร ไซเนเตอร์ร่วงเหวน
- ข. โครงสร้างพื้นฐานเร ไซเนเตอร์ร่วงเหวนร่วมกับเทคนิคเร ไซเนเตอร์อินพีเดนซ์แบบขั้น
- ค. โครงสร้างพื้นฐานเร ไซเนเตอร์ร่วงเหวนร่วมกับเทคนิคเร ไซเนเตอร์อินพีเดนซ์แบบขั้น และเทคนิคอินเตอร์ดิจิตอลคาปาซิเตอร์

3.4 การวิเคราะห์สมการทางคณิตศาสตร์

เนื่องจากการออกแบบชิ้นงานตามความถี่ที่ 1.8 GHz โดยใช้โครงสร้างเร ไซเนเตอร์ร่วงเหวนพื้นฐาน 1 วงเหวน ซึ่งสามารถคำนวณหาความถี่ได้จากการที่ (3.1) คำนวณหาค่าของตัวหนึ่งนำ ได้จากการที่ (3.2) และคำนวณหาค่าของตัวเก็บประจุ ได้จากการที่ (3.3) แต่เนื่องจากการออกแบบตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุในงานวิจัยนี้ได้ใช้เร ไซเนเตอร์ร่วงเหวนร่วมกับเทคนิคเร ไซเนเตอร์อินพีเดนซ์แบบขั้นเพื่อช่วยในการควบคุมความถี่และเทคนิคอินเตอร์ดิจิตอลคาปาซิเตอร์เพื่อลดขนาดชิ้นงาน โดยการออกแบบสามารถอธิบายได้จากรูปที่ 3.15 วงจรสมมูล



รูปที่ 3.15 วงจรสมมุติ

เมื่อกำหนดให้ (X. Zhang, Y. Wen, and K. Zhou, 2009)

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

และ

$$A = D = \cos\theta_a - \frac{1}{2}\omega C_i Z_a \sin\theta_a \quad (3.5)$$

$$B = jZ_a \sin\theta_a \quad (3.6)$$

$$C = j \left(\omega C_i \cos\theta_a + \frac{1}{Z_a} \sin\theta_a - \frac{1}{4} \omega^2 C_i^2 Z_a \sin\theta_a \right) \quad (3.7)$$

เมื่อค่าของความยาวทางไฟฟ้าของสายนำสัญญาณ $\theta_a = \beta l$ ซึ่งมีผู้ที่ได้ทำการศึกษาและวิจัย (พงศธร ชุมทอง, 2554) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของอินพีเดนซ์ภายนอกสายนำสัญญาณโดยมองให้สายนำสัญญาณมีอินพีเดนซ์ที่เท่ากัน แล้วพิจารณาความยาวทางไฟฟ้าที่มีความถี่เรโซแนนซ์ ซึ่งจะมีผลต่อความถี่เรโซแนนซ์ที่ทุกช่วงความถี่ตั้งแต่สองความถี่ขั้นไปจนถึงลำดับที่ n และได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวด้วยสมการดังต่อไปนี้ โดยกำหนดให้

C_i คืออินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์

L_3 คือความยาวรวมของอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์

L_4 คือความสูงของพื้นที่อินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์

Z_a คือค่าของอัมพีเดนซ์สายนำสัญญาณ

β_a คือค่าคงตัวการแพร่กระจาย

θ_a คือความยาวทางไฟฟ้าของสายนำสัญญาณ

I คือความยาวสายนำสัญญาณที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์

$$C_i = \frac{(\varepsilon_r + 1)}{L_3} L_4 (\varepsilon_r + 1) [0.1(n - 3) + 0.11] \quad (3.8)$$

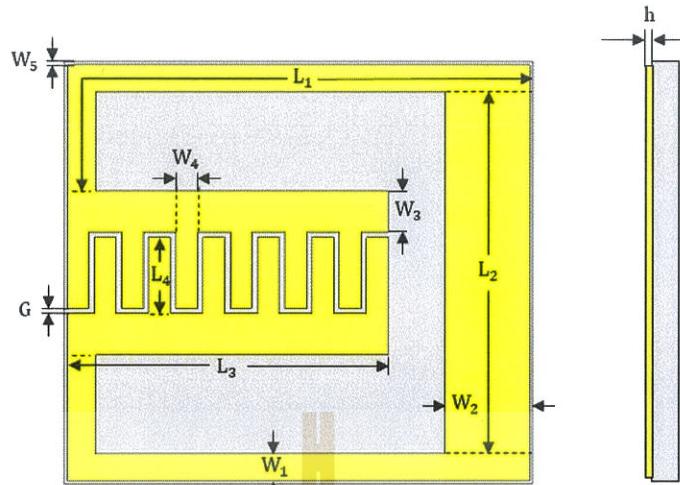
$$\theta_{a0} = 2 \tan^{-1} \frac{1}{\pi f_1 Z_a C_i} \quad (3.9)$$

$$\theta_{a1} = 2\pi - 2 \tan^{-1} (\pi f_2 Z_a C_i) \quad (3.10)$$

จากสมการข้างต้นจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ความถี่เรโซแนนซ์ ซึ่งจะพบว่า ค่าของ C_i จะมีผลกระทบต่อความถี่มุลฐานน้อย แต่จะมีผลกระทบต่อความถี่สารมอนิกส์มากกว่า ทำให้สรุปได้ว่า โครงสร้างของอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์จะมีผลกระทบต่อความถี่สารมอนิกส์มากกว่าความถี่มุลฐานและการนำเทคนิคของอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์มาประยุกต์ใช้งานทำให้ชิ้นงานมีขนาดเล็กลงอีกด้วย

3.5 การออกแบบตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ

จากการศึกษาการออกแบบตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุโดยใช้โครงสร้างเรโซเนเตอร์ร่วงเหวนร่วมกับเทคนิคเรโซเนเตอร์อัมพีเดนซ์แบบขั้น และเทคนิค อินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์ ทำให้ได้โครงสร้างชิ้นงานของตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ ดังแสดงในรูปที่ 3.15 ซึ่งในการออกแบบตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ (metasurface) จะเลือกใช้แผ่นพิมพ์วงจรซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ และความถี่ที่ต้องการจะแสดงในตารางที่ 3.3 และมีค่าพารามิเตอร์ของตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุตามตารางที่ 3.4



รูปที่ 3.16 โครงสร้างชั้นงานของตัวสะท้อนผิวอิเล็กทรอนิกส์

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของแพนพิมพ์วงจรและความถี่ที่ต้องการ

แพนพิมพ์วงจร	FR-4
ค่าความสูงของชั้บสเตรต	1.6 มิลลิเมตร
ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์	4.3
ค่าแทนเงนต์การสัญญาณ	0.025
ค่าความถี่มูลฐาน	1.8 GHz
ค่าความถี่ชาร์มอนิกส์	5.5 GHz

ตารางที่ 3.4 ค่าพารามิเตอร์ของตัวสะท้อนผิวอิเล็กทรอนิกส์

พารามิเตอร์	ขนาด (มิลลิเมตร)	ขนาด (λ)
W_1	1.25	0.0075λ
W_2	3.00	0.0180λ
W_3	1.80	0.0108λ
W_4	1.00	0.0060λ
W_5	0.15	0.0009λ
L_1	26.72	0.1603λ
L_2	18.20	0.1091λ

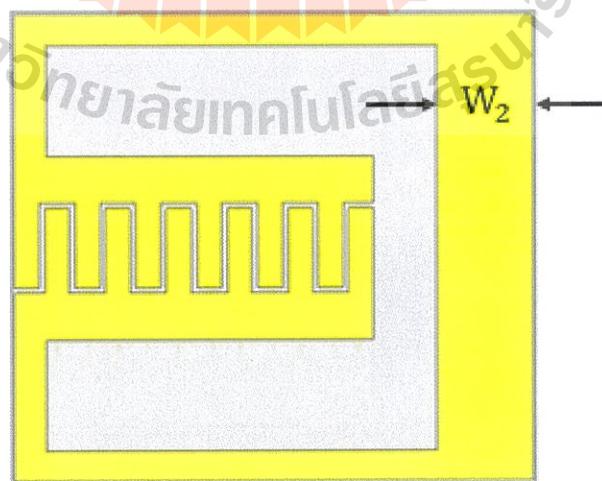
ตารางที่ 3.4 ค่าพารามิเตอร์ของตัวสะท้อนผิวอวัสดุ (ต่อ)

พารามิเตอร์	ขนาด (มิลลิเมตร)	ขนาด (λ)
L_3	14.75	0.0885λ
L_4	3.50	0.0210λ
G	0.25	0.0015λ
h	0.035	0.0002λ

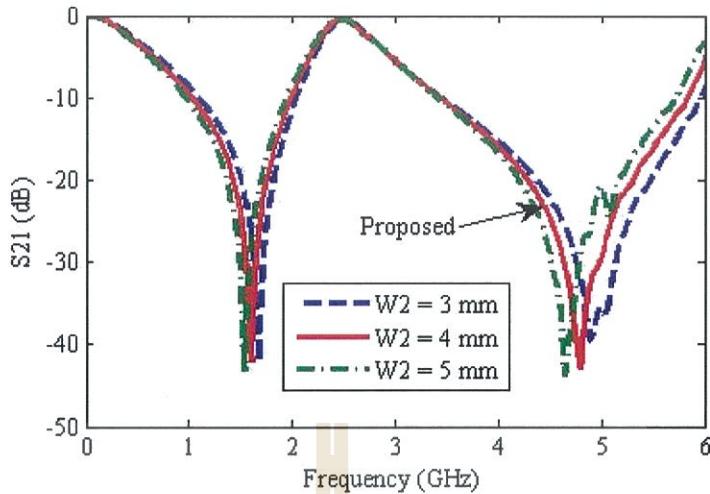
3.6 การปรับพารามิเตอร์ของตัวสะท้อนผิวอวัสดุ

3.6.1 การจำลองตัวสะท้อนผิวอวัสดุด้วยการปรับขนาดความกว้าง (W_2)

จากพารามิเตอร์ ในตารางที่ 3.3 จึงได้ทำการจำลองเปลี่ยนแปลงค่า W_2 เพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสมที่สุด โดยการปรับพารามิเตอร์นี้จะปรับทีละตัว โดยขณะที่พารามิเตอร์ตัวอื่นๆ จะต้องคงที่ จากนั้นจึงทำการจำลองปรับขนาดของ W_2 โดยเริ่มจากขนาด 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร และ 5 มิลลิเมตร ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 3.16 ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนแปลงค่า W_2 จะส่งผลกระทบต่อกำลังดูดดันที่มีอยู่ แต่จะส่งผลกระทบต่อกำลังดูดดันที่ชาร์มอนิกส์ โดยถ้า W_2 มีขนาดกว้างจะทำให้กำลังดูดดันที่ชาร์มอนิกส์เพิ่มขึ้น แต่ถ้า W_2 มีขนาดแคบลงจะทำให้กำลังดูดดันที่ชาร์มอนิกส์ลดลง แต่ถ้า W_2 มีค่าเพิ่มขึ้น สุดท้ายได้พิจารณาความกว้างของ W_2 ที่เหมาะสมที่สุดจะมีค่าเท่ากับ 3 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3.17



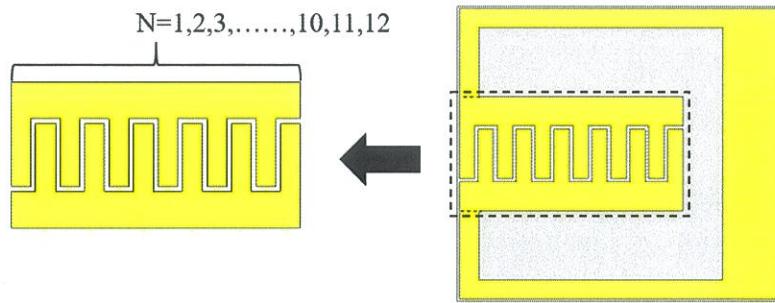
รูปที่ 3.17 การจำลองตัวสะท้อนผิวอวัสดุด้วยการปรับขนาดความกว้าง (W_2)



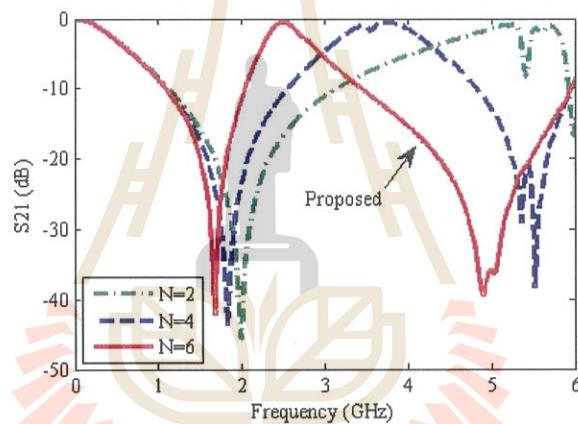
รูปที่ 3.18 ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน (S_{21}) ที่ได้จากการปรับขนาดความกว้าง (W_2)

3.6.2 การจำลองตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุต้นแบบด้วยการปรับเพิ่มจำนวนฟันของ อินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์ (N)

การจำลองปรับเพิ่มจำนวนฟันของอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์เพื่อให้ได้ คุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด ขณะที่ทำการปรับเพิ่มจำนวนฟันของอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์นี้ พารามิเตอร์ตัวอื่นๆ จะต้องคงที่ จากนั้นจึงทำการเพิ่มจำนวนฟันของอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์ เข้าไปทีละสองคู่โดยเริ่มจาก 2 คู่ 4 คู่ และ 6 คู่ ตามลำดับ หลังจากการจำลองเพิ่มจำนวนฟันของ อินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์แล้วจะเห็นได้ว่าการจำลองนี้ส่งผลต่อความถี่มูลฐานเล็กน้อยแต่ส่งผล กะทบต่อ ความถี่ชาร์มอนิกส์เป็นอย่างมาก โดยถ้ายังจำนวนฟันของอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์ มากก็จะยิ่งทำให้ความถี่มูลฐานและความถี่ชาร์มอนิกส์มีค่าลดลง ดูท้ายพิจารณาจำนวนฟันของ อินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดจะได้เท่ากับ 6 คู่หรือ 12 ชี๊ฟน์ ซึ่งครอบคลุมย่าน ความถี่ที่ 1.8 GHz และ 5.5 GHz ดังแสดงในรูปที่ 3.18 และผลในรูปที่ 3.19



รูปที่ 3.19 การจำลองตัวสะท้อนผิวอวัสดุต้นแบบด้วยการปรับเพิ่มจำนวนฟันของ อินเตอร์ดิจิตอลค่าปาซิเตอร์ (N)

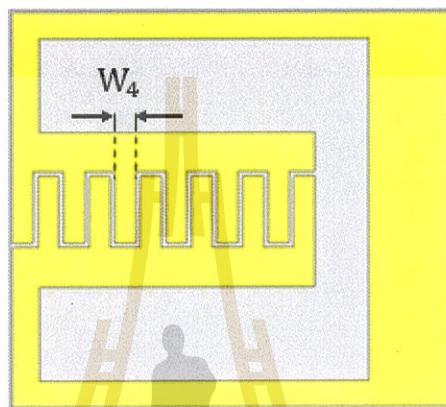


รูปที่ 3.20 ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน (S_{21}) ที่ได้จากการปรับเพิ่มจำนวนฟันของ อินเตอร์ดิจิตอลค่าปาซิเตอร์ (N)

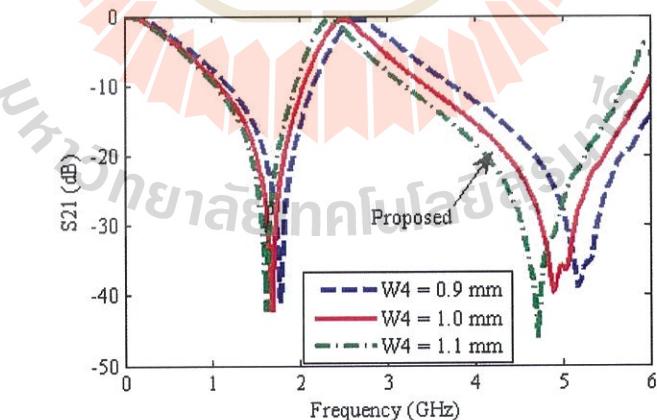
3.6.3 การจำลองตัวสะท้อนผิวอวัสดุต้นแบบด้วยการปรับขนาดความกว้างของฟันใน อินเตอร์ดิจิตอลค่าปาซิเตอร์ (W_4)

การจำลองปรับขนาดความกว้างของฟันในอินเตอร์ดิจิตอลค่าปาซิเตอร์ เพื่อให้ได้ คุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด ขณะที่ทำการปรับขนาดความกว้างของฟันในอินเตอร์ดิจิตอลค่าปาซิเตอร์นี้ พารามิเตอร์ตัวอื่นๆ จะต้องคงที่ จากนั้นปรับขนาดความกว้างของฟันในอินเตอร์ดิจิตอลค่าปาซิเตอร์เริ่มจาก 0.9 มิลลิเมตร 1.0 มิลลิเมตร และ 1.1 มิลลิเมตร ตามลำดับ หลังทำการจำลองปรับ ขนาดความกว้างของฟันในอินเตอร์ดิจิตอลค่าปาซิเตอร์แล้ว จะเห็นได้ว่า ส่วนผลกระทบทั้ง ความถี่มูลฐานและความถี่ชาร์มอนิกส์ เพราะฟันของอินเตอร์ดิจิตอลค่าปาซิเตอร์นั้นมีผลต่อความถี่

ทั้งสอง โดยถ้าปรับขนาดความกว้างของพื้นในอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเทอร์ให้มีความกว้างมากขึ้น จะทำให้ความถี่มุ่งฐานและความถี่ชาร์มอนิกส์มีค่าลดลง และถ้าปรับขนาดความกว้างของพื้นใน อินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเทอร์ให้แคบลงก็จะทำให้ความถี่มุ่งฐานและความถี่ชาร์มอนิกส์มีค่าเพิ่มขึ้น สุดท้ายพิจารณาความกว้างของพื้นในอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเทอร์ที่เหมาะสมที่สุดจะได้ขนาด เท่ากับ 1 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3.20 และผลในรูปที่ 3.21



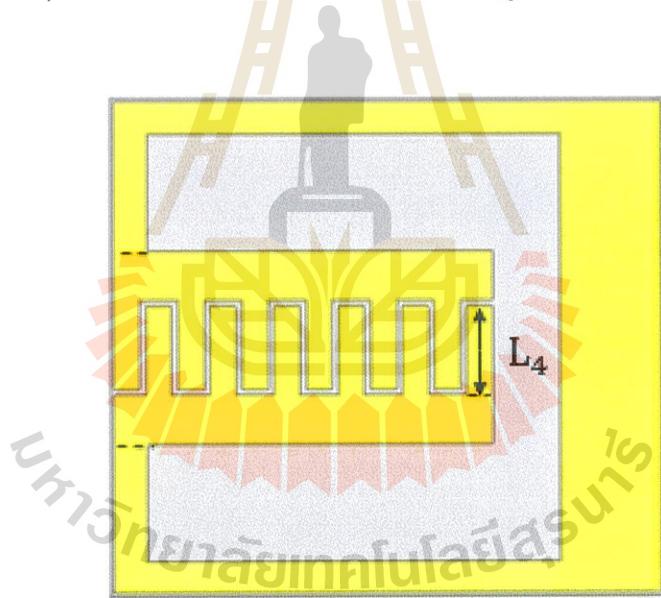
รูปที่ 3.21 การจำลองตัวสะท้อนผิวอวบน้ำสกัดด้านแบบด้วยการปรับขนาดความกว้างของ พื้นในอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเทอร์ (W_4)



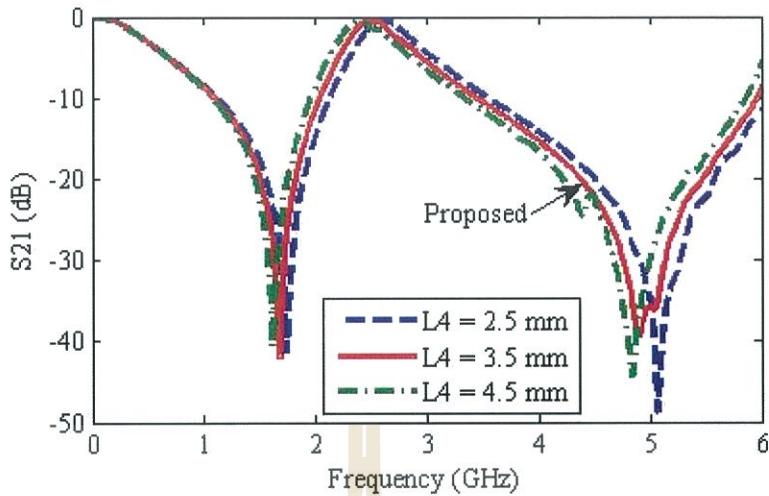
รูปที่ 3.22 ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน (S_{21}) ที่ได้จากการปรับขนาดความกว้างของพื้นใน อินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเทอร์ (W_4)

3.6.4 การจำลองตัวสะท้อนผิวอวิสุดตันแบบด้วยการปรับขนาดความสูงของพื้นในอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์ (L_4)

การจำลองปรับขนาดความสูงของพื้นในอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์ เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด ขณะที่ทำการปรับขนาดความสูงของพื้นในอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์ นี้ พารามิเตอร์ตัวอื่นๆ จะต้องคงที่ จากนั้นทำการเริ่มปรับขนาดความสูงของพื้นในอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์ จาก 2.5 มิลลิเมตร 3.5 มิลลิเมตร และ 4.5 มิลลิเมตร หลังจากทำการจำลองปรับขนาดความสูงของพื้นในอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์แล้ว จะเห็นได้ว่าส่งผลกระทบต่อความถี่มูลฐาน และความถี่ชาร์มอนิกส์เด่นน้อย โดยถ้าทำการปรับขนาดความสูงของพื้นในอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์ให้มีความสูงมากขึ้นจะทำให้ความถี่มูลฐานและความถี่ชาร์มอนิกส์มีค่าน้อยลง และถ้าทำการปรับขนาดความสูงของพื้นในอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์ให้สั้นลงก็จะทำให้ความถี่มูลฐาน และความถี่ชาร์มอนิกส์เพิ่มขึ้น สุดท้ายพิจารณาขนาดความสูงของพื้นในอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดจะได้เท่ากับ 3.5 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3.22 และผลในรูปที่ 3.23



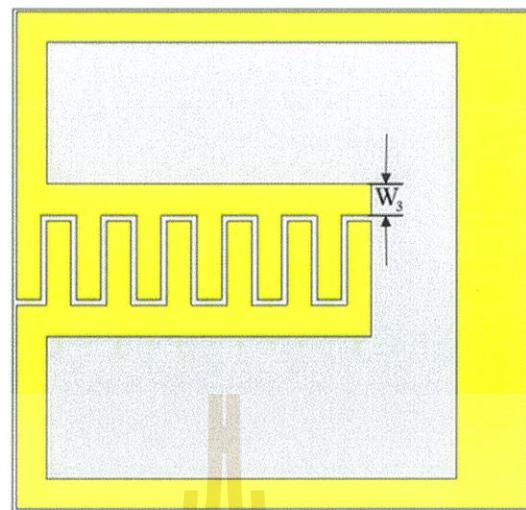
รูปที่ 3.23 การจำลองตัวสะท้อนผิวอวิสุดตันแบบด้วยการปรับขนาดความสูงของพื้นในอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์ (L_4)



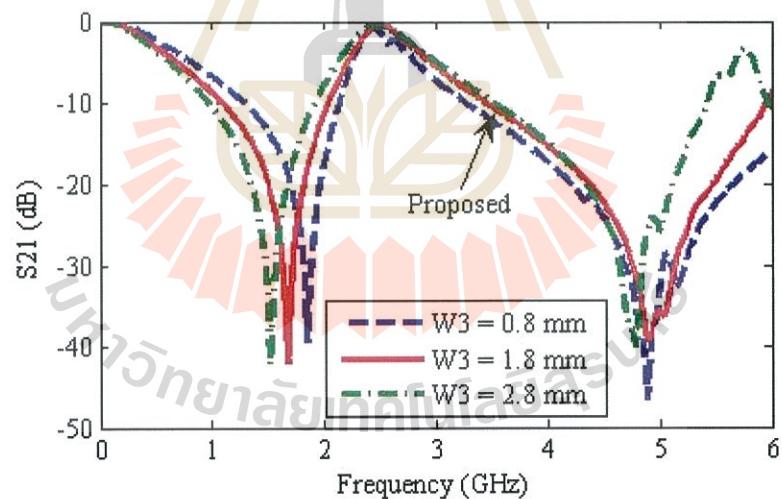
รูปที่ 3.24 ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน (S_{21}) ที่ได้จากการปรับขนาดความสูงของพื้นในอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊วิเตอร์ (L_4)

3.6.5 การจำลองตัวสะท้อนผิวอวิสุทธิ์แบบด้วยการปรับขนาดของแกนที่รองรับพื้นของอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊วิเตอร์ (W_3)

การจำลองตัวสะท้อนผิวอวิสุทธิ์แบบด้วยการปรับขนาดของแกนที่รองรับพื้นของอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊วิเตอร์ เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด ทำการเริ่มปรับขนาดของแกนที่รองรับพื้นของอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊วิเตอร์ เริ่มจาก 0.8 มิลลิเมตร 1.8 มิลลิเมตร และ 2.8 มิลลิเมตร หลังจากทำการจำลองปรับขนาดของแกนที่รองรับพื้นของอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊วิเตอร์ แล้วจะเห็นได้ว่าส่วนผลกระทบต่อความถี่มุกฐานและความถี่ขาวยอนิกต์ โดยถ้าทำการปรับขนาดของแกนที่รองรับพื้นของอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊วิเตอร์ ให้มีความกว้างมากขึ้นจะทำให้ความถี่มุกฐานและความถี่ขาวยอนิกต์ โดยถ้าทำการปรับขนาดของแกนที่รองรับพื้นของอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊วิเตอร์ ให้แคบลงก็จะทำให้ความถี่มุกฐานและความถี่ขาวยอนิกต์มีค่าเพิ่มมากขึ้น สุดท้ายพิจารณาขนาดของแกนที่รองรับพื้นของอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊วิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดจะได้เท่ากับ 1.8 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3.24 และผลแสดงในรูปที่ 3.25



รูปที่ 3.25 การจำลองตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุตื้นแบบด้วยการปรับขนาดของแกนที่รองรับพื้นของ อินเตอร์ดิจิตอลคาปซิเตอร์ (W_3)



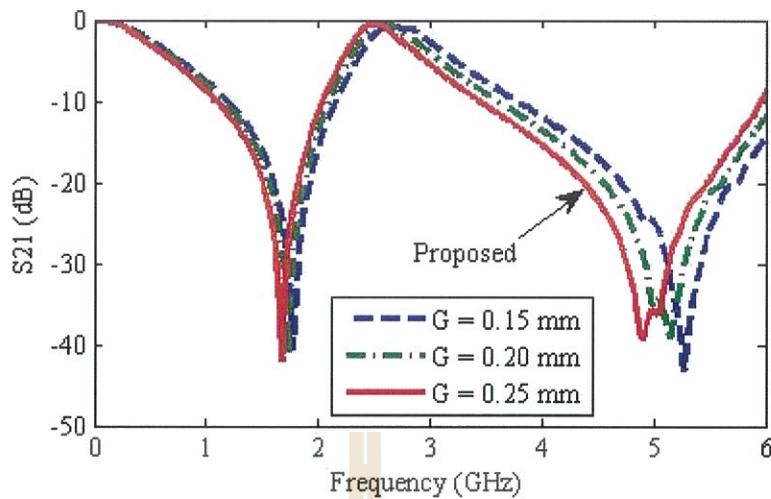
รูปที่ 3.26 ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน (S_{21}) ที่ได้จากการปรับขนาดของแกนที่รองรับพื้นของ อินเตอร์ดิจิตอลคาปซิเตอร์ (W_3)

3.6.6 การจำลองตัวสะท้อนผิวอวิสสูตันแบบด้วยการปรับระยะห่างของช่องว่างระหว่างพื้นของอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์ (G)

การจำลองตัวสะท้อนผิวอวิสสูตันแบบด้วยการปรับระยะห่างของช่องว่างระหว่างพื้นของ อินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์ เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด ทำการเริ่มปรับระยะห่างของช่องว่างระหว่างพื้นของอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์ เริ่มจาก 0.15 มิลลิเมตร 0.20 มิลลิเมตร และ 0.25 มิลลิเมตร หลังจากทำการจำลองปรับระยะห่างของช่องว่างระหว่างพื้นของอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์แล้ว จากรูปที่ 3.27 จะเห็นได้ว่าส่วนผลกระทบต่อความถี่มุกฐานและความถี่ชาร์มนิกส์มีค่าลดลง หรือถ้าการปรับขนาดเพิ่มช่องว่างมากขึ้นจะทำให้ความถี่มุกฐานและความถี่ชาร์มนิกส์มีค่าเพิ่มขึ้น โดยช่องว่างระหว่างพื้นของอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์นี้จะต้องเลือกค่าที่เหมาะสมที่สุดซึ่งจะต้องครอบคลุมย่านความถี่ที่เราต้องการจะออกแบบและสุดท้ายพิจารณาขนาดของช่องว่างระหว่างพื้นของอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดจะได้เท่ากับ 0.25 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3.26 และผลแสดงในรูปที่ 3.27



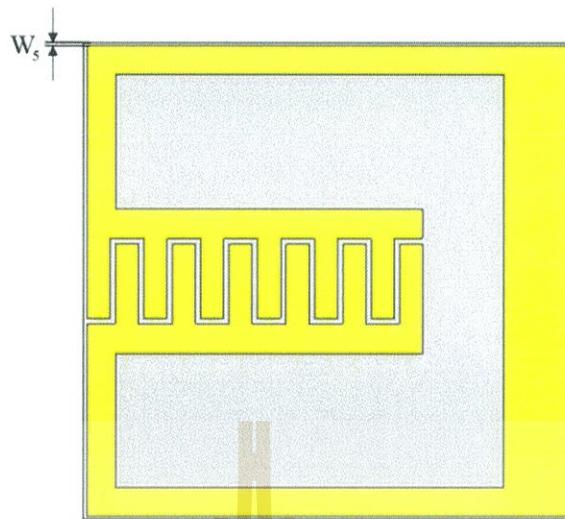
รูปที่ 3.27 การจำลองตัวสะท้อนผิวอวิสสูตันแบบด้วยการปรับระยะห่างของช่องว่างระหว่างพื้นของอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าซิเตอร์ G



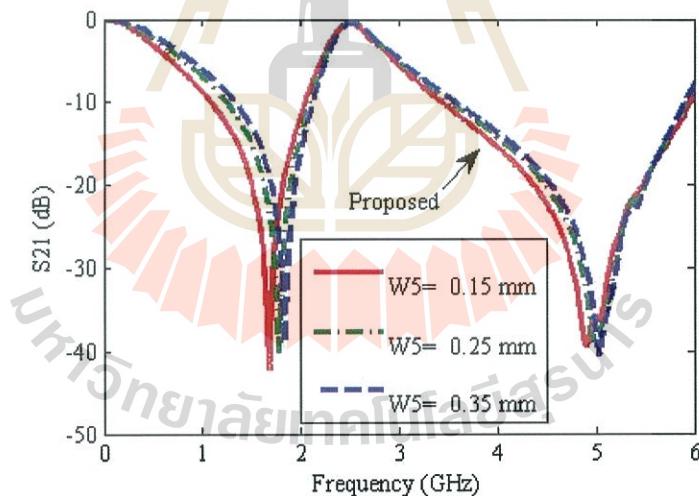
รูปที่ 3.28 ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน (S_{21}) ที่ได้จากการปรับระยะห่างของช่องว่างระหว่างพื้นของ อินเตอร์ดิจิตอลคาป้าซิเตอร์ G

3.6.7 การจำลองตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุต้นแบบด้วยการปรับระยะห่างระหว่างวัสดุ ทองแดงกับแผ่นพิมพ์วงจร (W_5)

การจำลองตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุต้นแบบด้วยการปรับระยะห่างระหว่างวัสดุ ทองแดงกับแผ่นพิมพ์วงจรเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด ขณะที่ทำการปรับระยะห่างระหว่างวัสดุทองแดงกับแผ่นพิมพ์วงจนี้ พารามิเตอร์ตัวอื่นๆ จะต้องคงที่ จากนั้นทำการเริ่มปรับระยะห่างระหว่างวัสดุทองแดงกับแผ่นพิมพ์วงจรเริ่มจาก 0.15 มิลลิเมตร 0.25 มิลลิเมตร และ 0.35 มิลลิเมตร หลังจากทำการจำลองปรับระยะห่างระหว่างวัสดุทองแดงกับแผ่นพิมพ์วงจรแล้ว จะเห็นได้ว่าระยะห่างมีผลกระทบต่อความถี่มูลฐานและมีผลกระทบต่อความถี่ชานอนิกส์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยถ้าทำการปรับระยะห่างระหว่างวัสดุทองแดงกับแผ่นพิมพ์วงจรให้มีความกว้างมากขึ้นจะทำให้ความถี่ที่ความถี่มูลฐานและความถี่ชานอนิกส์มีค่าเพิ่ม และถ้าทำการปรับระยะห่างระหว่างวัสดุทองแดงกับแผ่นพิมพ์วงจรให้แคบลงก็จะทำให้ความถี่มูลฐานและความถี่ชานอนิกส์ลดลง ดูท้ายพิจารณาระยะห่างระหว่างวัสดุทองแดงกับแผ่นพิมพ์วงจรที่เหมาะสมที่สุดจะได้เท่ากับ 0.15 มิลลิเมตร ดังแสดงจากในรูปที่ 3.28 และผลแสดงในรูปที่ 3.29



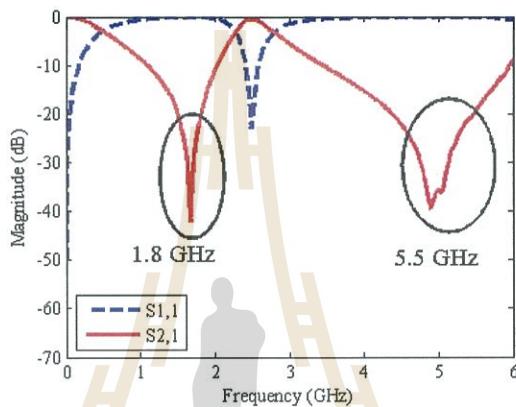
รูปที่ 3.29 การจำลองตัวสะท้อนผิวอวัสดุด้านแบบด้วยการปรับระยะห่างระหว่างวัสดุทองแดงกับแผ่นพิมพ์วงจร (W_5)



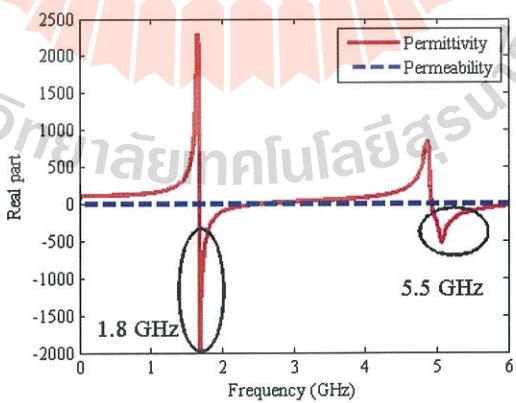
รูปที่ 3.30 ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน (S_{21}) ที่ได้จากการปรับระยะห่างระหว่างวัสดุทองแดงกับแผ่นพิมพ์วงจร (W_5)

จากการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป CST ใน การจำลองสร้างตัวสะท้อนผิวอวัสดุ เพื่อปรับหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ จนกระทั้งได้ค่าที่เหมาะสม ทำให้ได้ตัวสะท้อนผิวอวัสดุครอบคลุมช่วงความถี่ 2 ช่วงความถี่ โดยในรูปที่ 3.30 จะแสดงให้เห็นถึงค่าของสัมประสิทธิ์การส่งผ่านของ

แบบจำลองตัวสะท้อนผิวอวิสสูตรีติดลบ ช่วงความถี่แรกคือตั้งแต่ 1.12 GHz ถึง 2.02 GHz จะอยู่ในย่านความถี่ 1.8 GHz และช่วงความถี่ที่สองคือตั้งแต่ 3.45 GHz ถึง 5.95 GHz จะอยู่ในย่านความถี่ 5.5 GHz จากรูปที่ 3.31 จะแสดงให้เห็นถึงค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้าและค่าซึมซาบแม่เหล็กซึ่งค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้าจะมีค่าเป็นลบที่ช่วงความถี่ตั้งแต่ 1.67 GHz ถึง 2.48 GHz และช่วงความถี่ 4.92 GHz ถึง 6.21 GHz ซึ่งค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้าติดลบที่ได้จากการจำลองของตัวสะท้อนผิวอวิสสูตรีอยู่ในช่วงย่านความถี่ที่เราต้องการใช้งาน

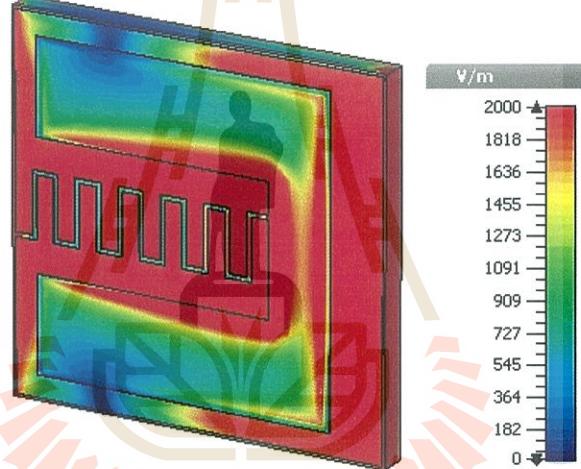


รูปที่ 3.31 ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับของแบบจำลองตัวสะท้อนผิวอวิสสูตรี (S_{11}) และค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านของแบบจำลองตัวสะท้อนผิวอวิสสูตรี (S_{21})

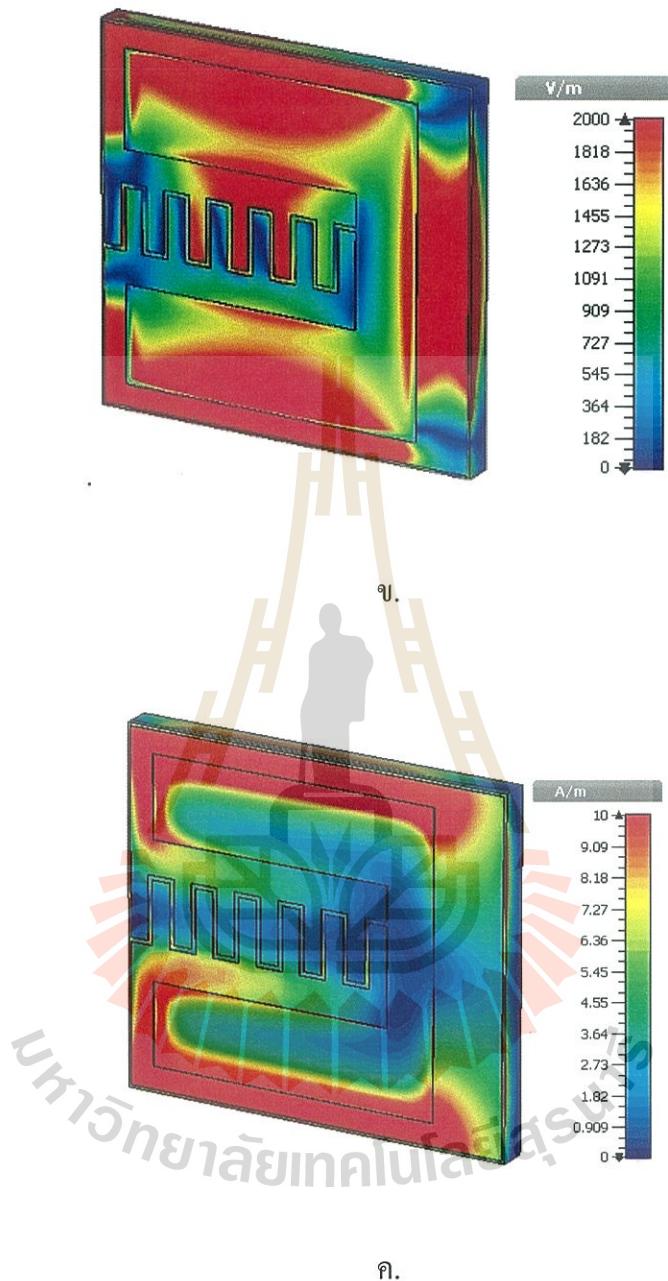


รูปที่ 3.32 ค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้า (ϵ_r) และค่าซึมซาบแม่เหล็ก (μ_r) ของแบบจำลองตัวสะท้อนผิวอวิสสูตรี

จากรูปที่ 3.32 จะแสดงสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในแบบรูป 3 มิติ จากรูปที่ 3.32 ก.จะแสดงให้เห็นถึงส่วนของผิวขวาง ซ้ายของเร โซนเตอร์วงแหวนและอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเตอร์ซึ่งจะมีผลต่อสนามไฟฟ้าที่ความถี่ 1.8 GHz จากรูปที่ 3.32 ข. จะแสดงให้เห็นถึงส่วนของขอบนและขอบล่างของเร โซนเตอร์วงแหวน รวมไปถึงด้านขวาและซ้ายของเร โซนเตอร์วงแหวนและอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเตอร์เล็กน้อย ที่มีผลต่อสนามไฟฟ้าที่ความถี่ 5.5 GHz จากรูปที่ 3.32 ค. จะแสดงให้เห็นถึงส่วนของขอบนและล่างของเร โซนเตอร์วงแหวนซึ่งจะมีผลต่อสนามแม่เหล็กที่ความถี่ 1.8 GHz และจากรูปที่ 3.32 ง. จะแสดงให้เห็นถึงส่วนของขอบน ล่างของเร โซนเตอร์วงแหวนและแกนที่รองรับพื้นของอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊มเตอร์ซึ่งจะมีผลต่อสนามแม่เหล็กที่ความถี่ 5.5 GHz ตามลำดับ



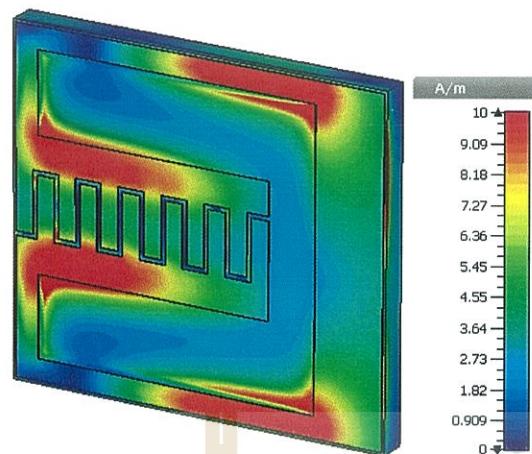
รูปที่ 3.33 แบบรูปสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของตัวสะท้อนผิวอวบกิวสตุ
 ก. สนามไฟฟ้าที่ความถี่ 1.8 GHz
 ข. สนามไฟฟ้าที่ความถี่ 5.5 GHz
 ค. สนามแม่เหล็กที่ความถี่ 1.8 GHz
 ง. สนามแม่เหล็กที่ความถี่ 5.5 GHz



ก.

รูปที่ 3.33 แบบรูปสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของตัวสะท้อนผิวอวบสุด (ต่อ)

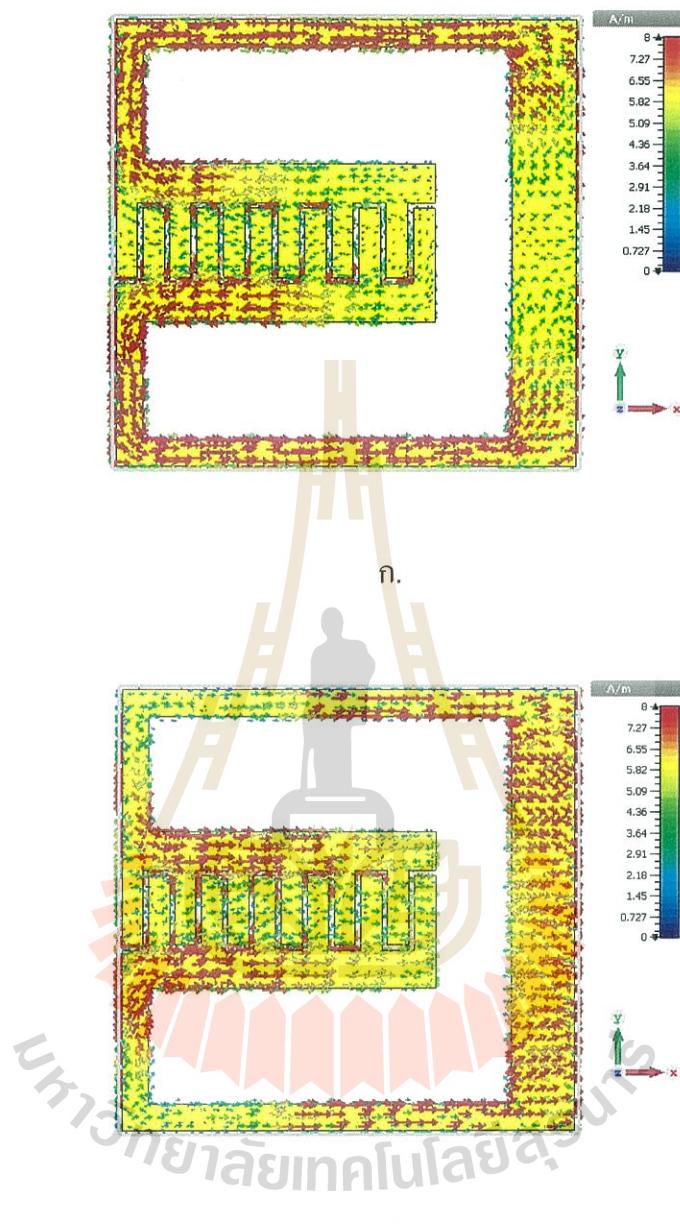
- ก. สนามไฟฟ้าที่ความถี่ 1.8 GHz
- ข. สนามไฟฟ้าที่ความถี่ 5.5 GHz
- ค. สนามแม่เหล็กที่ความถี่ 1.8 GHz
- ง. สนามแม่เหล็กที่ความถี่ 5.5 GHz



รูปที่ 3.33 แบบรูปสนาณไฟฟ้าและสนาณแม่เหล็กของตัวสะท้อนผิวอวัสดุ (ต่อ)

- ก. สนาณไฟฟ้าที่ความถี่ 1.8 GHz
- ข. สนาณไฟฟ้าที่ความถี่ 5.5 GHz
- ค. สนาณแม่เหล็กที่ความถี่ 1.8 GHz
- ง. สนาณแม่เหล็กที่ความถี่ 5.5 GHz

จากรูปที่ 3.33 จะแสดงทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่ตัวสะท้อนผิวอวัสดุ ซึ่งในรูปที่ 3.33 ก. สำหรับความถี่ 1.8 GHz ทิศทางของกระแสไฟฟ้าจะเกิดบริเวณด้านบนและด้านล่างของเรโซเนเตอร์วงแหวนและบริเวณของอินเตอร์ดิจิตอลคาปaziเตอร์เล็กน้อย ในรูปที่ 3.33 ข. สำหรับความถี่ 5.5 GHz ทิศทางของกระแสจะเกิดบริเวณในส่วนของอินเตอร์ดิจิตอลคาปaziเตอร์และฝั่งทางด้านขวาของเรโซเนเตอร์วงแหวน รวมถึงด้านบนและด้านล่างของเรโซเนเตอร์วงแหวนด้วย



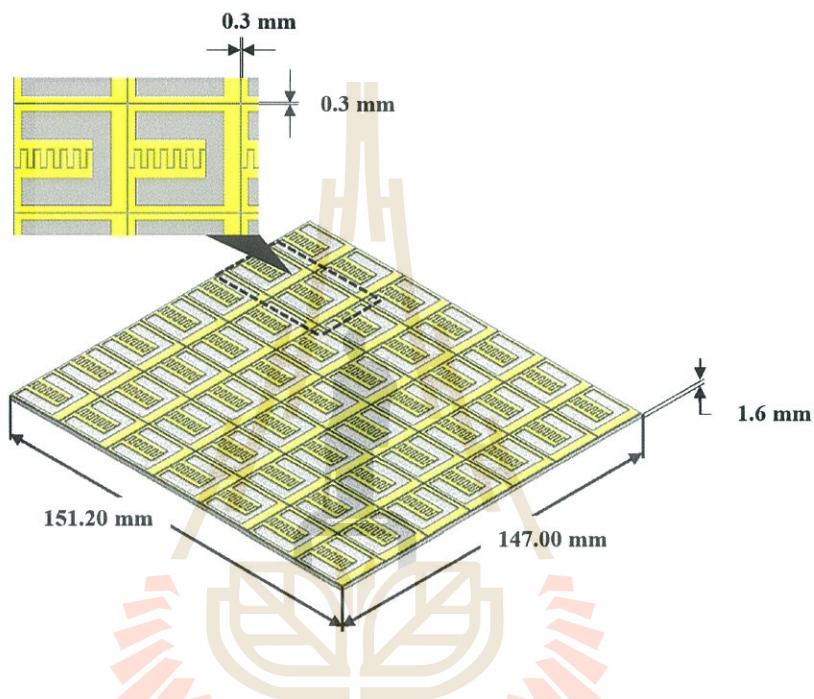
รูปที่ 3.34 กระแสเชิงผิวของตัวสะสมท่อนผิวอภิวัสดุ

ก. กระแสเชิงผิวที่ความถี่ 1.8 GHz

ข. กระแสเชิงผิวที่ความถี่ 5.5 GHz

3.7 การจำลองแบบตัวสะท้อนผิวอวัสดุเควลำดับ

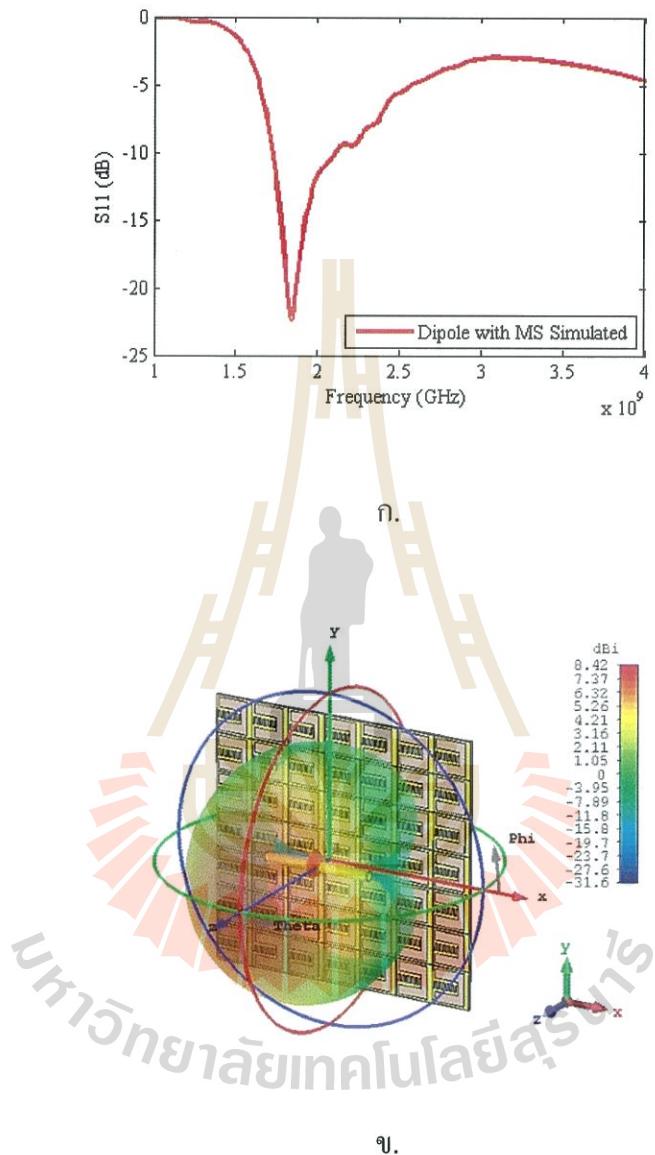
เนื่องจากการออกแบบชิ้นงานในวิทยานิพนธ์นี้มีขนาดชิ้นงานที่เล็กมาก จึงไม่สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุตัวสะท้อนร่วมกับสายอากาศได้โดยได้ที่หนึ่งยูนิต เนื่องจากว่าขนาดของชิ้นงานจะต้องครอบคลุมแบบรูปการแผ่กระจายของสายอากาศได้โดย ดังนั้นเราจึงได้ทำการจำลองสร้างให้เป็นเควลำดับจำนวน 7×7 อลิเมนต์ ดังแสดงในรูปที่ 3.34



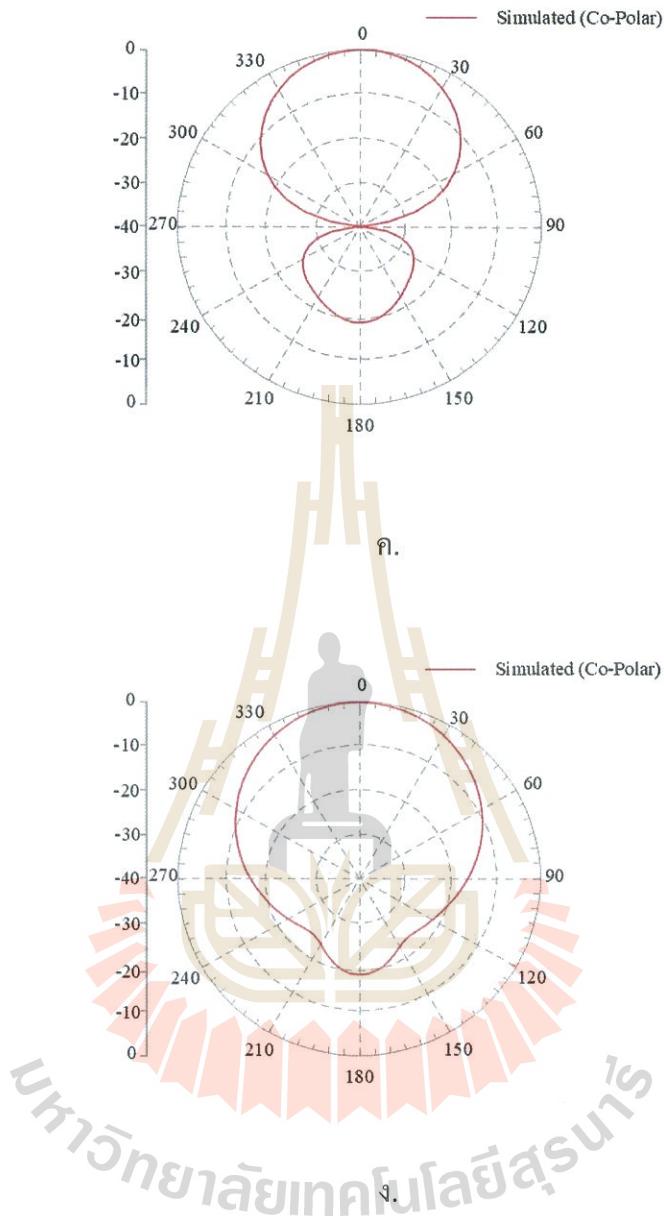
รูปที่ 3.35 แบบจำลองตัวสะท้อนผิวอวัสดุเควลำดับจำนวน 7×7 อลิเมนต์

หลังจากที่ได้ทำการจำลองสายอากาศได้โดยไปในหัวข้อก่อนหน้านี้แล้วจึงนำแบบจำลองตัวสะท้อนผิวอวัสดุเควลำดับจำนวน 7×7 อลิเมนต์ มาทำการทดสอบร่วมกับสายอากาศได้โดย ด้วยโปรแกรม CST โดยได้ทำการทดลองกับสายอากาศได้โดยที่ความถี่ 1.8 GHz และ 5.5 GHz ตามลำดับ เริ่มจากการทดลองแบบจำลองตัวสะท้อนผิวอวัสดุร่วมกับสายอากาศได้โดยที่ความถี่ 1.8 GHz โดยจะว่างสายอากาศได้โดยไว้ที่จุดกึ่งกลางด้านหน้าของตัวสะท้อนผิวอวัสดุ ซึ่งสายอากาศได้โดยจะวางบนนานกับสนามไฟฟ้าหรือในแนวเดียวกันกับอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊เตอร์ที่ระยะห่างระหว่างสายอากาศได้โดยกับตัวสะท้อนผิวอวัสดุจะอยู่ที่ $\lambda/8$ จากรูปที่ 3.35 ก. ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ (S_{11}) ที่มาจากการนำตัวสะท้อนผิวอวัสดุมาทดสอบกับสายอากาศได้โดยความถี่ 1.8 GHz โดยค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับที่ค่าต่ำกว่า -10 dB จะครอบคลุมช่วงความถี่ตั้งแต่ 1.72 GHz ถึง 2.11 GHz และรูปที่ 3.35 ข. จะแสดง

แบบรูปการแผ่พลังงานแบบ 3 มิติ สำหรับแบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามไฟฟ้าและในระบบสนามแม่เหล็กจะแสดงในรูปที่ 3.35 ค. และรูปที่ 3.35 ง. ตามลำดับ

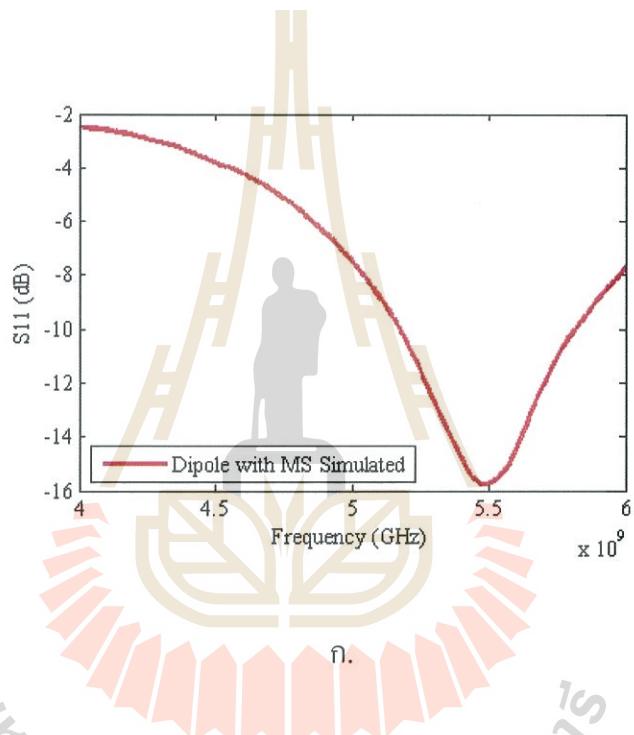


รูปที่ 3.36 ผลจากการจำลองตัวสะท้อนผิวอวบวัสดุแล้วลำดับจำนวน 7×7 อิเลมเม้นต์ กับสายอากาศได้โดยความถี่ 1.8 GHz ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป CST
ก. ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ (S_{11})
ข. แบบรูปการแผ่พลังงานแบบ 3 มิติ
ค. แบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามไฟฟ้า
ง. แบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามแม่เหล็ก



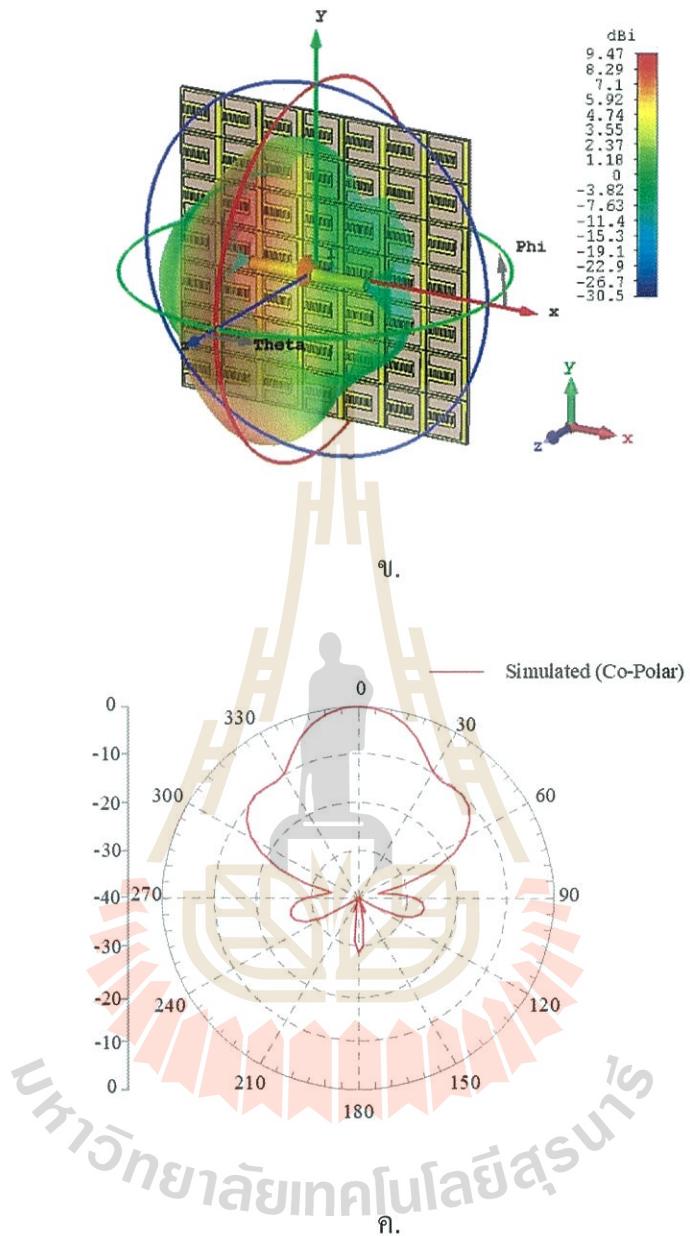
รูปที่ 3.36 ผลจากการจำลองตัวสะท้อนผิวอวัสดุเควาดับจำนวน 7×7 อิเดมเนต์ กับสายอากาศได้โดยความถี่ 1.8 GHz ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป CST (ต่อ)
 ก. ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ (S_{11})
 ข. แบบรูปการແเพลิงงานแบบ 3 มิติ
 ค. แบบรูปการແเพลิงงานในระบบสนามไฟฟ้า
 ง. แบบรูปการແเพลิงงานในระบบสนามแม่เหล็ก

จากนั้นได้ทำการนำตัวสะท้อนผิวอวิสสคุมาทดสอบร่วมกับساอยาคน้ำใจ โผล ความถี่ 5.5 GHz โดยทางสายอากาศได้โผลไว้ที่จุดกึ่งกลางด้านหน้าของตัวสะท้อนผิวอวิสสคุซึ่งสายอากาศได้โผลจะวางบนกับระนาบสนามไฟฟ้าหรือในแนวเดียวกันกับอินเตอร์ดิจิตอลภาคปานิชเตอร์ที่ระยะห่างระหว่างสายอากาศได้โผลกับตัวสะท้อนผิวอวิสสคุจะอยู่ที่ $\lambda/8$ จากรูปที่ 3.36 ก. จะแสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับที่ค่าต่ำกว่า -10 dB จะครอบคลุมช่วงความถี่ตั้งแต่ 5.17 GHz ถึง 5.80 GHz และรูปที่ 3.36 ข. จะแสดงแบบรูปการແພັດງານແບບ 3 ມິຕີ ສໍາຫຼັບແບບຮູບການແພັດງານໃນระนาบສານາມไฟฟ້າແລະ ຮະນາບສານາມແມ່ເໜື້ອກຈະແສດງໃນຮູບທີ 3.36 ດ. ແລະຮູບທີ 3.36 ງ.



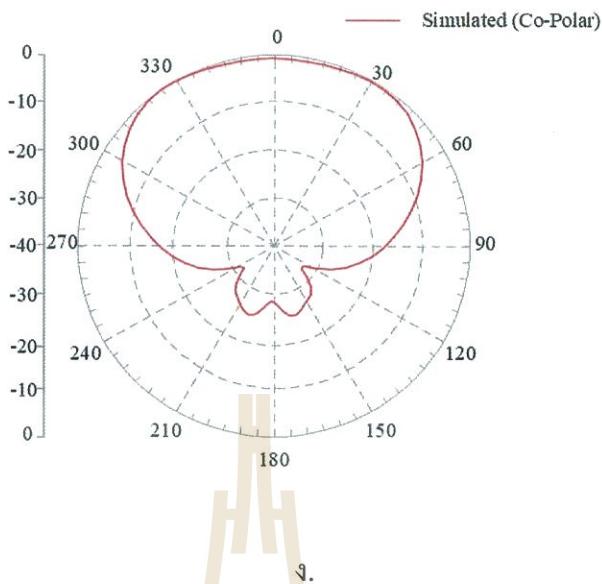
ຮູບທີ 3.37 ລົດຂາກການຈຳລອງຕັ້ງສະຫຼຸບທຶນຜົວອວິສສຸດແລວດຳນັກຈຳນວນ 7×7 ອິລິມېນຕີ ກັບສາຍອາກາສໄດ້ໂພລຄວາມຄື 5.5 GHz ດ້ວຍໂປຣແກຣມສໍາເລົ້າຮູບ CST

- ກ. ຄ່າສັນປະລິທີ່ກາຮະສະຫຼຸບ (S_{11})
- ຂ. ແບບຮູບການແພັດງານແບບ 3 ມິຕີ
- ຄ. ແບບຮູບການແພັດງານໃນຮະນາບສານາມไฟฟ້າ
- ຈ. ແບບຮູບການແພັດງານໃນຮະນາບສານາມແມ່ເໜື້ອກ



รูปที่ 3.37 ผลจากการจำลองตัวสะท้อนผิวอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาระลำดับจำนวน 7×7 อิลิเมนต์ กับสายอากาศไดโอดความถี่ 5.5 GHz ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป CST (ต่อ)

- ก. ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ (S_{11})
- ข. แบบรูปการแผ่พลังงานแบบ 3 มิติ
- ค. แบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสถานีไฟฟ้า
- ง. แบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสถานีแม่เหล็ก

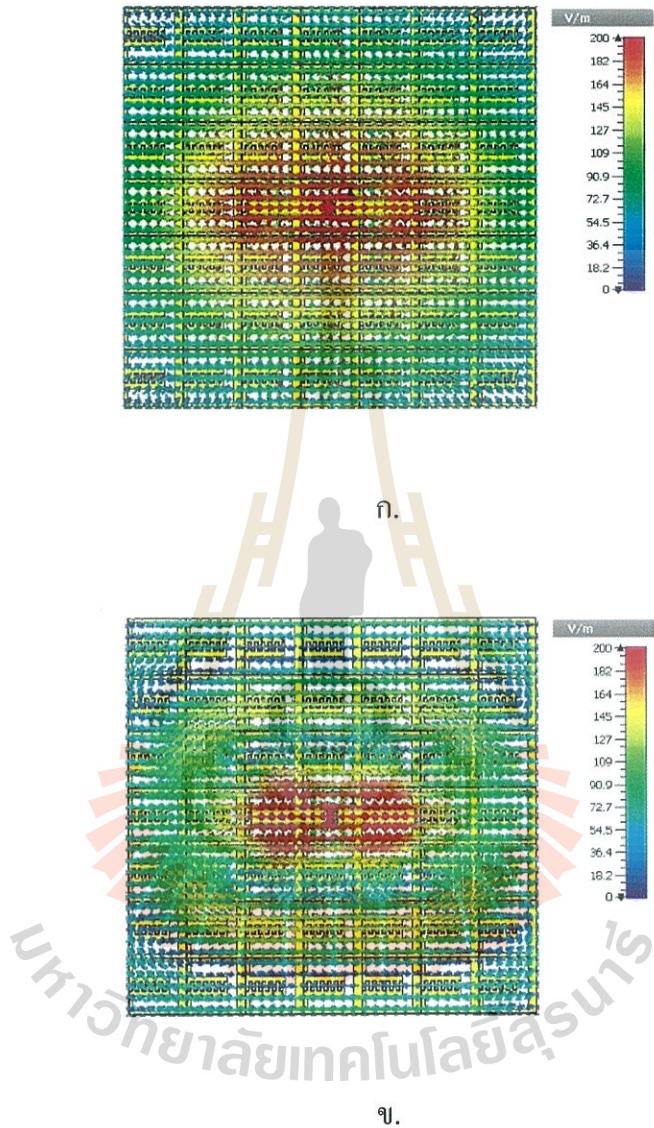


รูปที่ 3.37 ผลจากการจำลองตัวสะท้อนผิวอวัสดุ deaf สำหรับจำนวน 7×7 อิเลมเม้นต์ กับสายอากาศได้โลคลำดับที่ 5.5 GHz ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป CST (ต่อ)

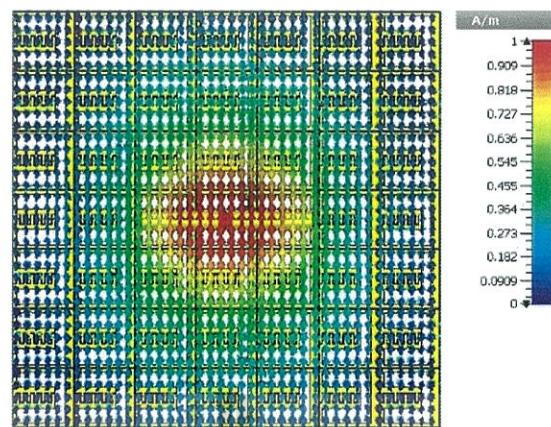
- ก. ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ (S_{11})
- ข. แบบรูปการแผ่พลังงานแบบ 3 มิติ
- ค. แบบรูปการแผ่พลังงานในระนาบสถานที่ไฟฟ้า
- ง. แบบรูปการแผ่พลังงานในระนาบสถานที่แม่เหล็ก

จากรูปที่ 3.37 การแผ่พลังงานสถานที่ไฟฟ้าและสถานที่แม่เหล็กของตัวสะท้อนผิวอวัสดุ ซึ่งในรูปที่ 3.37 ก. และ 3.37 ข. คือการแผ่พลังงานของสถานที่ไฟฟ้าที่ความถี่ 1.8 GHz และ 5.5 GHz ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่าทิศทางของสถานที่ไฟฟ้าอยู่ในระนาบหรือทิศทางเดียวกันกับสายอากาศได้โลล ล่าว ในรูปที่ 3.37 ค. และ 3.37 ง. แสดงทิศทางของสถานที่แม่เหล็กที่ความถี่ 1.8 GHz และ 5.5 GHz ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่าทิศทางของสถานที่แม่เหล็กตั้งฉากกับสายอากาศได้โลล และในรูปสุดท้าย รูปที่ 3.38 คือกระแสเชิงผิวของตัวสะท้อนผิวอวัสดุ รูปที่ 3.38 ก. กระแสเชิงผิวที่ความถี่ 1.8 GHz ซึ่งจะเห็นว่าบริเวณด้านบนและด้านล่างของเรโซนเตอร์วงแหวน รวมถึงด้านซ้ายของเรโซนเตอร์วงแหวนอิกทั้งบริเวณของอินเตอร์ดิจิตอล-คาปซิเตอร์กีชั่นเดียวกันซึ่งจะมีความหนาแน่นของกระแสอยู่ด้วย ในรูปที่ 3.38 ข. กระแสเชิงผิวที่ความถี่ 5.5 GHz จะเห็นได้ว่ากระแสมีความหนาแน่นมากบริเวณด้านบน ด้านล่าง และด้านซ้ายของ

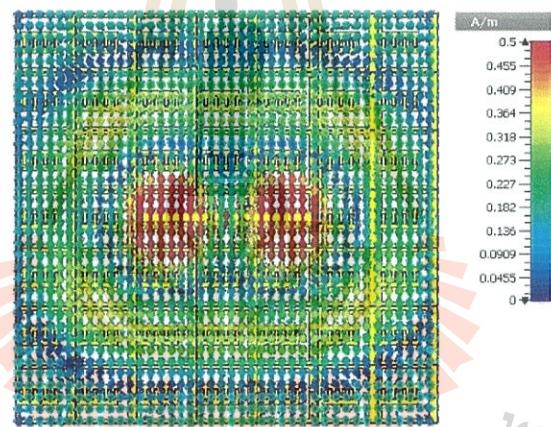
เร โ ช น เ ต อ ร์ ว ง แ ห วน รวมถึงบริเวณอินเตอร์ดิจิตอล cavity ซึ่งคล้ายกับกระแสที่ความถี่ที่ 1.8 GHz



รูปที่ 3.38 การแพ้พลังงานสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของตัวสะท้อนผิวอกวัสดุเฉพาะลำดับจำนวน 7×7 อลิเมนต์
 ก. สนามไฟฟ้าที่ความถี่ 1.8 GHz
 ข. สนามไฟฟ้าที่ความถี่ 5.5 GHz
 ค. สนามแม่เหล็กที่ความถี่ 1.8 GHz
 ง. สนามแม่เหล็กที่ความถี่ 5.5 GHz



ค.



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รูปที่ 3.38 การແພ່ພັບງານສນາມໄຟຟ້າແລະສນາມແມ່ເໜັກຂອງ

ຕົວສະຫຼອນພົວອົງວິສດຸແຄວດຳດັບຈຳນວນ 7×7 ອິລິເມັນຕີ (ຕ່ອ)

ก. ສນາມໄຟຟ້າທີ່ຄວາມຄື 1.8 GHz

ຂ. ສນາມໄຟຟ້າທີ່ຄວາມຄື 5.5 GHz

ຄ. ສນາມແມ່ເໜັກທີ່ຄວາມຄື 1.8 GHz

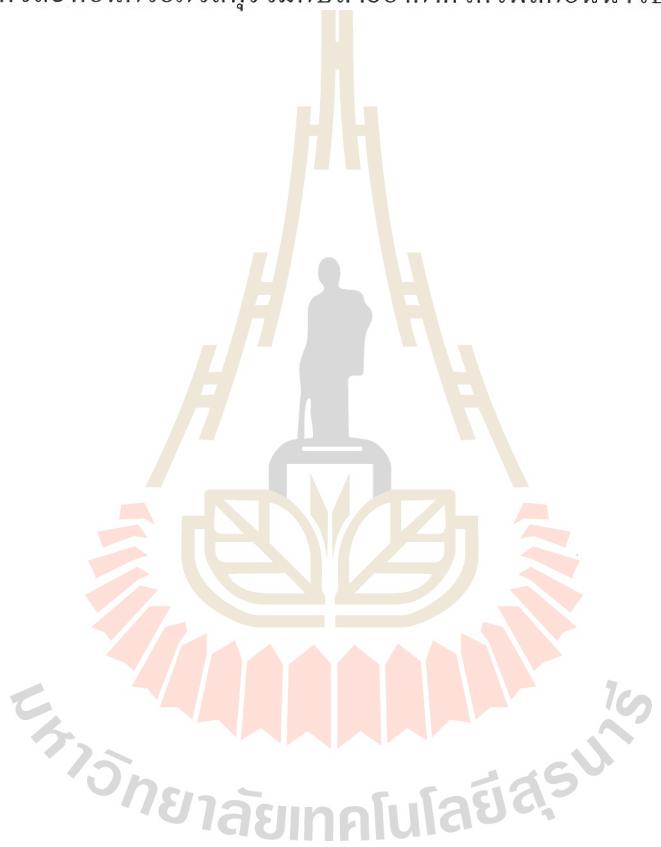
ຈ. ສນາມແມ່ເໜັກທີ່ຄວາມຄື 5.5 GHz



รูปที่ 3.39 กระดานแสดงผลของตัวสะสมห้องพิวอภิวัสดุถ่วงลำดับจำนวน 7×7 อิเลิเมนต์
ก. กระดานแสดงผลที่ความถี่ 1.8 GHz
ข. กระดานแสดงผลที่ความถี่ 5.5 GHz

3.8 สรุป

ในบทนี้ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการออกแบบ และวิเคราะห์ ตัวสะท้อนผิวอวิสุด (metasurface) ซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างเรโซเนเตอร์ร่วงเหวน และอินเตอร์ดิจิตอลค่าปั๊ตเตอร์ ซึ่งถูกนำมาใช้งานร่วมกับสายอากาศได้โดยตรง ให้ในระบบ LTE และ WLAN โดยถูกนำมาจัดแพร่ล้ำดับจำนวน 7x7 อลิเมนต์ เมื่อใช้งานร่วมกับสายอากาศได้โดยตรง ให้อัตราขยายแก่สายอากาศที่สูงขึ้น ซึ่งได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป CST ในทำการจำลองแบบก่อน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของตัวสะท้อนผิวอวิสุดร่วมกับสายอากาศได้โดยก่อนนำไปสร้างและทดสอบในบทถัดไป



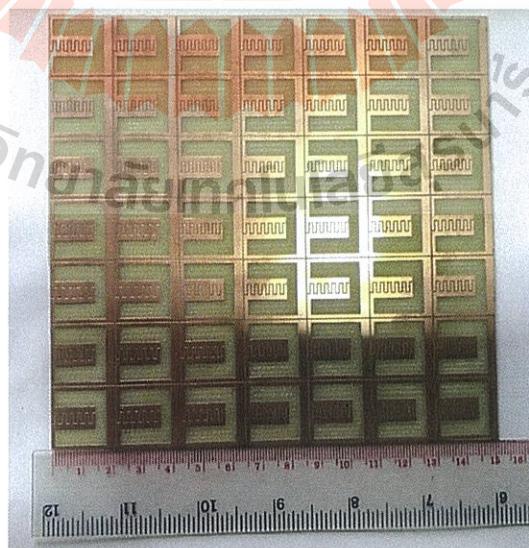
บทที่ 4

การสร้างและการวัดทดสอบ

4.1 การสร้างตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ

จากหลักการและทฤษฎีที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ผ่านมา รวมถึงการจำลองการออกแบบตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุจากบทที่ 3 ชี้ในบทนี้ จะนำผลการจำลองการสร้างตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุด้วยโปรแกรม CST Microwave Studio 2016 มาทำการสร้างตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ จากนั้นวัดทดสอบคุณลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ค่า S_{11} แบบรูปการแพ็พลังงาน และอัตราขยาย โดยใช้เครื่องวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analyzer) จากนั้นเปรียบเทียบผลการจำลองและผลจากการวิเคราะห์พร้อมทั้งอภิรายผล

โดยขั้นตอนในการสร้างจะเริ่มจากการแปลงไฟล์จาก CST นามสกุล DXF บันทึกแฟ้มข้อมูล เพื่อนำไปปิดกับโปรแกรม LPKF Circuit Pro ที่สามารถใช้งานกับเครื่อง LPKF Laser & Electronics ซึ่งสามารถดัดแปลงตามแบบจำลองที่ได้ทำการออกแบบไว้ โดยตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ จะสร้างจากแผ่นในโครงสร้างปืนนิค FR4 ($\epsilon_r = 4.3$) แสดงในรูปที่ 4.1 และ ตารางที่ 4.1 คือค่าพารามิเตอร์ที่ใช้สร้างตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ



รูปที่ 4.1 ตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ

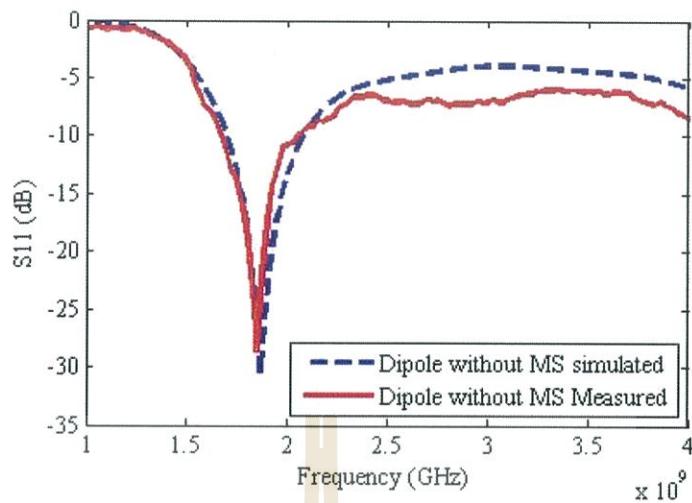
ตารางที่ 4.1 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้สร้างตัวสะท้อนผิวอวบวัสดุ

พารามิเตอร์	ขนาด (มิลลิเมตร)	ขนาด (λ)
W_1	1.25	0.0075λ
W_2	3.00	0.0180λ
W_3	1.80	0.0108λ
W_4	1.00	0.0060λ
W_5	0.15	0.0009λ
L_1	26.72	0.1603λ
L_2	18.20	0.1091λ
L_3	14.75	0.0885λ
L_4	3.50	0.0210λ
G	0.25	0.0015λ
h	0.035	0.0002λ

4.2 ผลการวัดทดสอบสัมประสิทธิ์การสะท้อน

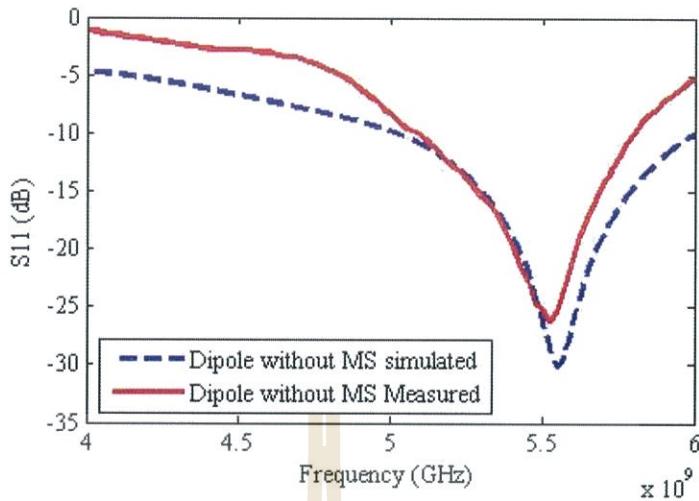
4.2.1 สายอากาศไคลโพร

จากการที่ได้จำลองสายอากาศไคลโพรในบทที่ 3 เพื่อนำมาเป็นสายอากาศในการรับ โดยรูปที่ 4.2 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับระหว่างผลการจำลองของสายอากาศไคลโพรและผลวัดทดสอบของสายอากาศไคลโพรที่ความถี่ 1.8 GHz จะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับที่ได้จากการจำลองของสายอากาศไคลโพรที่ต่ำกว่า -10 dB จะครอบคลุมช่วงความถี่ตั้งแต่ 1.68 GHz ถึง 2.08 GHz และค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับที่ได้จากการวัดทดสอบของสายอากาศไคลโพรที่ต่ำกว่า -10 dB จะครอบคลุมช่วงความถี่ตั้งแต่ 1.67 GHz ถึง 2.00 GHz การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับระหว่างผลการจำลองของสายอากาศไคลโพรและผลวัดทดสอบของสายอากาศไคลโพรที่ความถี่ 1.8 GHz จะเห็นได้ว่าค่าที่ได้นั้นมีค่าที่ใกล้เคียงกัน



รูปที่ 4.2 กราฟเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับระหว่างผลการจำลองของสายอากาศได้โพลและผลวัดทดสอบของสายอากาศได้โพลที่ความถี่ 1.8 GHz

จากรูปที่ 4.3 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับระหว่างผลการจำลองของสายอากาศได้โพลและผลวัดทดสอบของสายอากาศได้โพลที่ความถี่ 5.5 GHz จะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับที่ได้จากการจำลองของสายอากาศได้โพลที่ต่ำกว่า -10 dB จะครอบคลุมช่วงความถี่ตั้งแต่ 5.01 GHz ถึง 5.96 GHz และค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับที่ได้จากการทดสอบของสายอากาศได้โพลที่ค่าต่ำกว่า -10 dB จะครอบคลุมช่วงความถี่ตั้งแต่ 5.10 GHz ถึง 5.80 GHz การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับระหว่างผลการจำลองของสายอากาศได้โพลและผลวัดทดสอบของสายอากาศได้โพลที่ความถี่ 5.5 GHz จะเห็นได้ว่าค่าที่ได้นั้นมีค่าที่ใกล้เคียงกัน

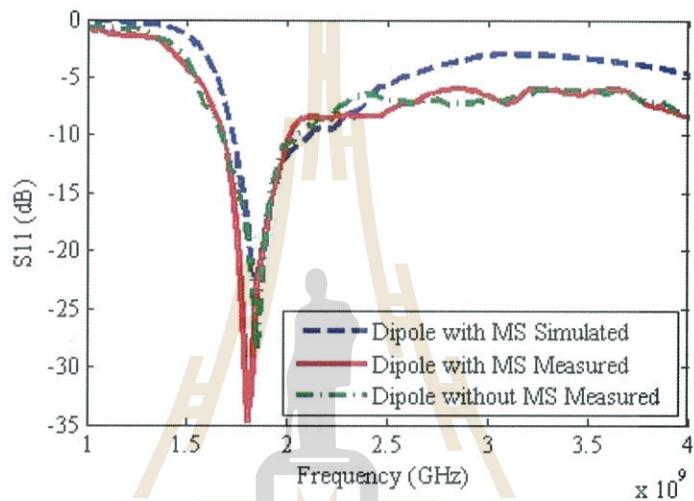


รูปที่ 4.3 กราฟเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับระหว่างผลการจำลองของสายอากาศได้โพลและผลวัดทดสอบของสายอากาศได้โพลที่ความถี่ 5.5 GHz

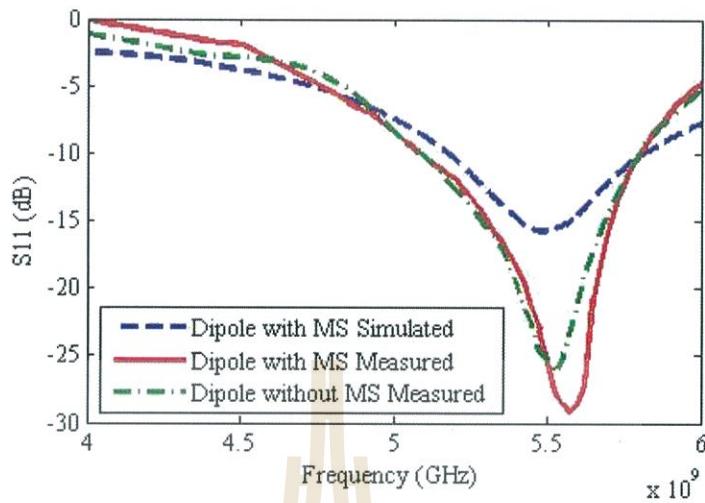
4.2.2 ตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ

เนื่องจากการพิจารณาเพื่อที่จะนำตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุไปใช้งานได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยหลักการการแม่เหล็กอิมพีเดนซ์ โดยสามารถดูได้จากค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ (S_{11}) โดยค่าที่จะสามารถนำไปใช้งานควรจะมีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ -10 dB จึงจะทำให้เกิดการแม่เหล็กอิมพีเดนซ์ที่ดี จากรูปที่ 4.4 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนระหว่างผลการจำลองของตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ ผลวัดทดสอบของตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุและผลวัดทดสอบของสายอากาศได้โพลที่ความถี่ 1.8 GHz จะสังเกตได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนของการวัดทดสอบ ตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุจะมีช่วงความถี่ตั้งแต่ 1.68 GHz ถึง 2.00 GHz ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนของการจำลองตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุจะมีช่วงความถี่ตั้งแต่ 1.72 GHz ถึง 2.11 GHz และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนของสายอากาศได้โพลจะมีช่วงความถี่ตั้งแต่ 1.67 GHz ถึง 2.00 GHz จากรูปที่ 4.5 กราฟเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนระหว่างผลการจำลองของตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ ผลวัดทดสอบของตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุและผลวัดทดสอบของสายอากาศได้โพลที่ความถี่ 5.5 GHz จะสังเกตได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนของการวัดทดสอบตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุจะมีช่วงความถี่ตั้งแต่ 4.97 GHz ถึง 5.80 GHz ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนของการจำลองตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุจะมีช่วงความถี่ตั้งแต่ 5.17 GHz ถึง 5.80 GHz และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนของสายอากาศได้โพลจะมีช่วงความถี่ตั้งแต่ 5.10 GHz ถึง 5.80 GHz จากกราฟที่แสดงการเปรียบเทียบ

ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนระหว่างผลการจำลองของตัวสะท้อนผิวอวิสสู ผลวัดทดสอบของตัวสะท้อนผิวอวิสสูและผลวัดทดสอบของสายอากาศได้โพลผลที่ความถี่ 1.8 GHz และ 5.5 GHz ตามลำดับ มีลักษณะที่คล้ายกัน ซึ่งผลของการวัดทดสอบตัวสะท้อนผิวอวิสสูจะสังเกตได้ว่า ช่วงความถี่ที่ได้จากการวัดทดสอบนี้ครอบคลุมความถี่ 1.8 GHz และ 5.5 GHz ซึ่งในทางปฏิบัติ สายอากาศได้โพลนี้มีช่วงของความถี่ที่แคน จึงทำให้ผลการวัดทดสอบมีช่วงความถี่ที่แคนหรือไม่ ครอบคลุมความถี่ทั้งหมดตามที่ได้ออกแบบความถี่ใช้งานไว้



รูปที่ 4.4 กราฟเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนระหว่างผลการจำลองของตัวสะท้อนผิวอวิสสู ผลวัดทดสอบของตัวสะท้อนผิวอวิสสูและผลวัดทดสอบของสายอากาศได้โพลที่ความถี่ 1.8 GHz

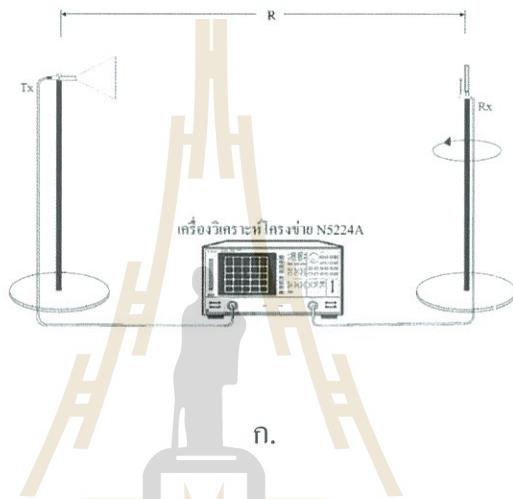


รูปที่ 4.5 กราฟเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนระหว่างผลการจำลองของตัวสะท้อนผิวอิเล็กทรอนิกส์ดู ผลวัดทดสอบของตัวสะท้อนผิวอิเล็กทรอนิกส์ดูและผลวัดทดสอบของสายอากาศโดย一波ลที่ความถี่ 5.5 GHz

4.3 ผลการวัดแบบรูปการแผ่พลังงาน

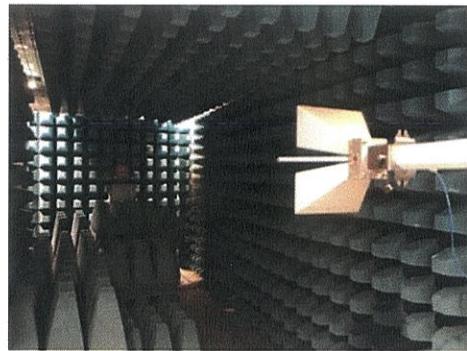
วิธีการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานได้ทำการทดสอบที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า-พระนครเหนือ ซึ่งภายในห้องวัด ห้องจะสามารถปิดกันคลื่นจากภายนอกและลดการสะท้อนของคลื่นภายในห้อง โดยการติดตั้งตัวสะท้อนผิวอิเล็กทรอนิกส์และสายอากาศอ้างอิง จะให้ระยะห่าง R เท่ากับสนามระยะใกล้ คำนวณจาก $R \geq 2D^2 / \lambda$ เมื่อ D คือ ขนาดของสายอากาศที่จะทำการวัดทดสอบเนื่องจาก ตัวสะท้อนผิวอิเล็กทรอนิกส์สามารถรองรับการทำงานได้ 2 ความถี่ คำนวณระยะสนามใกล้ได้ดังนี้ ที่ความถี่ 1.8 GHz $R \geq 1.13$ เมตร และที่ความถี่ 5.5 GHz $R \geq 3.30$ เมตร โดยกำหนดให้ระยะสนามใกล้เท่ากับ 4 เมตรทั้งสองความถี่ ซึ่งในรูปที่ 4.6 จะแสดงวิธีการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานระนาบสนามไฟฟ้า และในรูปที่ 4.7 จะแสดงวิธีการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานระนาบสนามแม่เหล็ก ซึ่งในการวัดทดสอบครั้งนี้ใช้สายอากาศปากแตรในการทำหน้าที่ของภาคส่งสัญญาณและในส่วนของภาครับจะมีจานหมุนที่สามารถหมุนได้ตั้งแต่ 0 องศาจนถึง 360 องศาเพื่อที่จะรับสัญญาณจากภาคส่งให้แสดงแบบรูปการแผ่พลังงานในระนาบสนามไฟฟ้าและระนาบสนามแม่เหล็ก จากรูปที่ 4.8 จะแสดงแบบรูปการแผ่พลังงานของตัวสะท้อนผิวอิเล็กทรอนิกส์ในระนาบสนามไฟฟ้าและระนาบสนามแม่เหล็กที่ความถี่ 1.8 GHz ในกราฟจะแสดงการเปรียบเทียบทองรูปการแผ่พลังงานร่วมกันและข้ามกัน ซึ่งการแผ่พลังงานข้ามกันจากการวัดทดสอบ

และการแผ่พลังงานร่วมขึ้นจากการจำลองและวัดทดสอบ จากรูปที่ 4.9 จะแสดงแบบรูปการแผ่พลังงานของตัวสะท้อนผิวอิฐสหุในระบบสนามไฟฟ้าและระบบสนามแม่เหล็กที่ความถี่ 5.5 GHz ซึ่งกราฟจะแสดงการเปรียบเทียบของรูปการแผ่พลังงานร่วมขึ้นและขึ้นช้า ซึ่งการแผ่พลังงานขึ้นช้าจากการวัดทดสอบและการแผ่พลังงานร่วมขึ้นจากการจำลองและวัดทดสอบ โดยจะสังเกตได้ว่าการเปรียบเทียบของกราฟมีรูปการแผ่พลังงานในลักษณะเดียว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน



รูปที่ 4.6 วิธีการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามไฟฟ้าของตัวสะท้อนผิวอิฐสหุ

- ก. แสดงวิธีการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามไฟฟ้า
- ข. การติดตั้งจริงสำหรับการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามไฟฟ้า

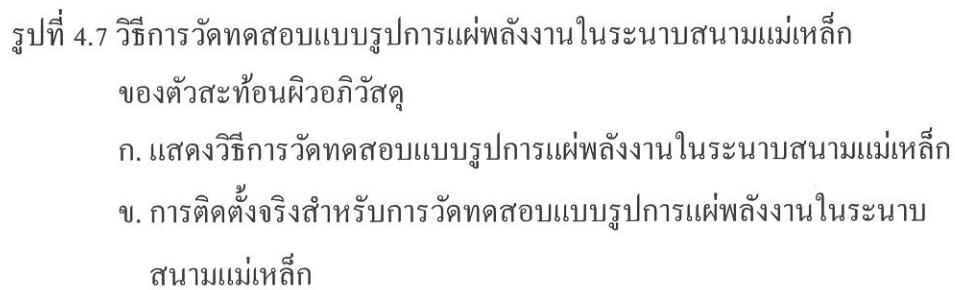


บ.

รูปที่ 4.6 วิธีการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามไฟฟ้า
ของตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ (ต่อ)

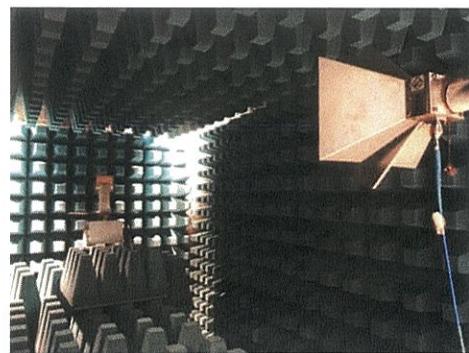
- ก. แสดงวิธีการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามไฟฟ้า
- ข. การติดตั้งจริงสำหรับการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานในระบบ
สนามไฟฟ้า

ก.



รูปที่ 4.7 วิธีการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามแม่เหล็ก
ของตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ

- ก. แสดงวิธีการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามแม่เหล็ก
- ข. การติดตั้งจริงสำหรับการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานในระบบ
สนามแม่เหล็ก

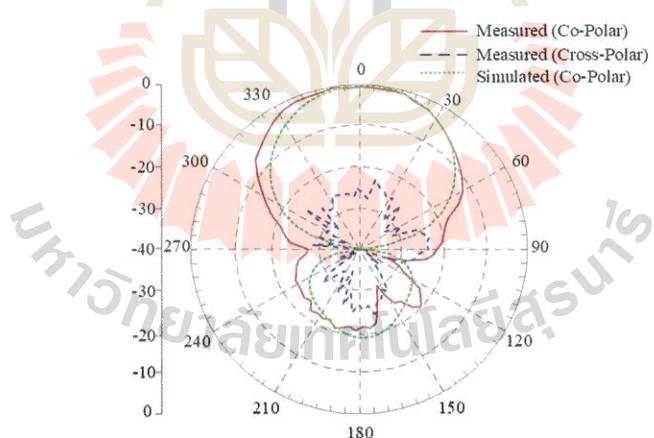


บ.

รูปที่ 4.7 วิธีการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามแม่เหล็กของตัวสะท้อนผิวอวบอสกุ (ต่อ)

- ก. แสดงวิธีการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามแม่เหล็ก
ข. การติดตั้งจริงสำหรับการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่พลังงานในระบบ

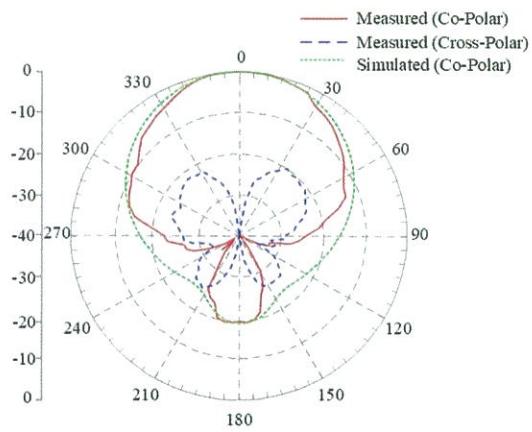
สนามแม่เหล็ก



ก.

รูปที่ 4.8 แบบรูปการแผ่พลังงานของตัวสะท้อนผิวอวบอสกุที่ความถี่ 1.8 GHz.

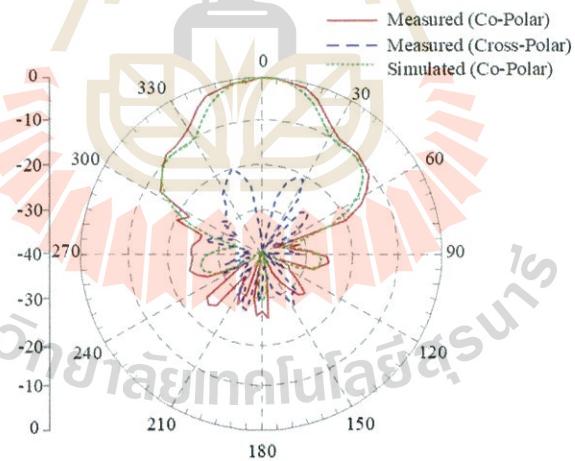
- ก. แบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามไฟฟ้า
ข. แบบรูปการแผ่พลังงานในระบบสนามแม่เหล็ก



รูปที่ 4.8 แบบรูปการแผ่พลังงานของตัวสะท้อนผิวอิเล็กทรอนิกส์ที่ความถี่ 1.8 GHz. (ต่อ)

ก. แบบรูปการแผ่พลังงานในระนาบสันમາไฟฟ้า

ข. แบบรูปการแผ่พลังงานในระนาบสันમາแม่เหล็ก

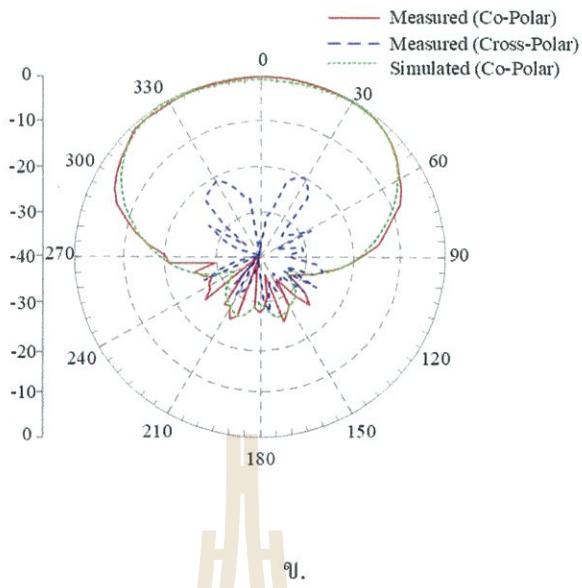


ก.

รูปที่ 4.9 แบบรูปการแผ่พลังงานของตัวสะท้อนผิวอิเล็กทรอนิกส์ที่ความถี่ 5.5 GHz.

ก. แบบรูปการแผ่พลังงานในระนาบสันમາไฟฟ้า

ข. แบบรูปการแผ่พลังงานในระนาบสันມາแม่เหล็ก



รูปที่ 4.9 แบบรูปการแผ่พลังงานของตัวสะท้อนผิวอวบกิวสุดที่ความถี่ 5.5 GHz.(ต่อ)

ก. แบบรูปการแผ่พลังงานในระนาบสนาમ้าไฟฟ้า

ข. แบบรูปการแผ่พลังงานในระนาบสนาમแม่เหล็ก

4.4 ผลการวัดทดสอบอัตราขยาย

ในการคำนวณหาค่าอัตราขยายของตัวสะท้อนผิวอวบกิวสุดแล้วลำดับ 7×7 อิลิเมนต์ จะใช้สมการการส่งผ่านของ Friis (Friis transmission equation) เป็นพื้นฐาน โดยสมการการส่งผ่านของ Friis ที่นำมาใช้เท่ากับ

$$\frac{P_r}{P_t} = \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2 G_t G_r \quad (4.1)$$

$$G_{dB} = \frac{1}{2} \left[20 \log_{10} \left(\frac{4\pi R}{\lambda} \right) + 10 \log_{10} \frac{P_r}{P_t} \right] \quad (4.2)$$

$$G_{dB} = P_{r_{dB}} - P_{t_{dB}} - G_{t_{dB}} + 20 \log \left(\frac{4\pi R}{\lambda} \right) \quad (4.3)$$

โดยที่ P_t คือ กำลังที่ป้อนให้กับสายอากาศภาคส่ง (วัตต์)

P_r คือ กำลังที่รับได้ของสายอากาศภาครับ (วัตต์)

G_{dB} คือ อัตราขยายรวมของสายอากาศภาคส่งและสายอากาศภาครับเมื่อ
สายอากาศทั้งสองตัวมีลักษณะเหมือนกัน

G_t คือ อัตราขยายของสายอากาศภาคส่ง

G_r คือ อัตราขยายของสายอากาศภาครับ

R คือ ระยะห่างระหว่างสายอากาศภาคส่งและสายอากาศภาครับ (เมตร)

เนื่องจากงานวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบตัวสะท้อนผิวอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับ 2 ความถี่ คือ ความถี่ 1.8 GHz และความถี่ 5.5 GHz ซึ่งสามารถคำนวณหาอัตราขยายของตัวสะท้อนผิวอิเล็กทรอนิกส์ได้จากสมการที่ (4.3) ได้ดังนี้ เมื่อ $(P_{r dB} - P_{t dB}) = S_{21}$ ของแต่ละความถี่และ $R = 4$ เมตรที่ความถี่ 1.8 GHz

$$G_{r dB} = (-35.04 \text{ dB}) - (6.45 \text{ dB}) + 20 \log \left(\frac{4 \times \pi \times (4)}{0.16} \right) = 8.09 \text{ dB}$$

ที่ความถี่ 5.5 GHz

$$G_{r dB} = (-41.54 \text{ dB}) - (8.6 \text{ dB}) + 20 \log \left(\frac{4 \times \pi \times (4)}{0.0545} \right) = 9.14 \text{ dB}$$

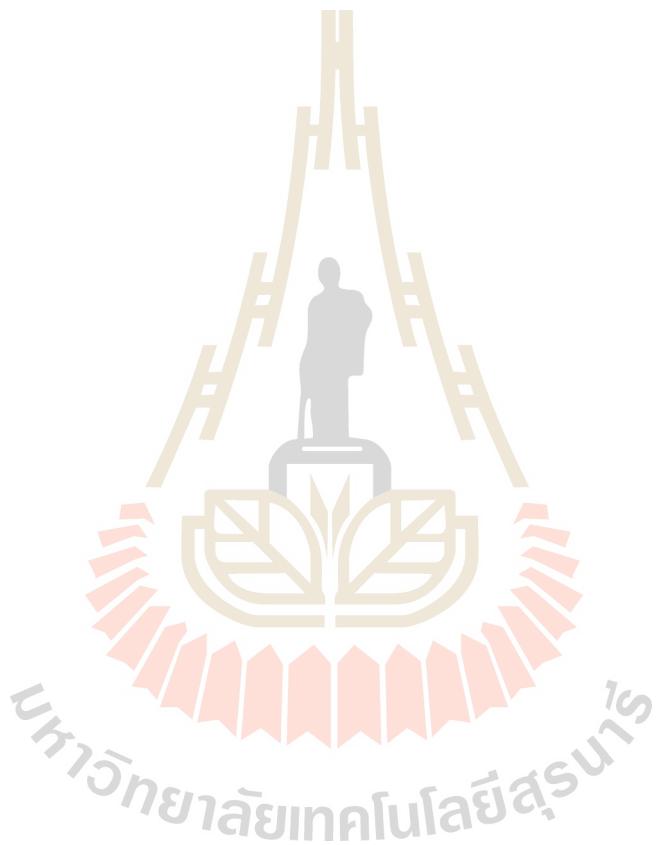
ตารางที่ 4.2 สรุปผลคุณสมบัติของสายอากาศไดโอด

พารามิเตอร์	ความถี่ (GHz)	1.8	5.5
ย่านความถี่ใช้งาน (GHz)	1.68-2.00	4.97-5.80	
อัตราขยาย (dBi)	8.09	9.14	
ความกว้างลำดิ่นครึ่งกำลัง (degree)	70	47.5	
ออม皮เดนซ์ (ohm)	47.32	52.82	

4.5 สรุป

ในบทนี้แสดงถึงการสร้างและการวัดทดสอบคุณสมบัติของตัวสะท้อนผิวอิเล็กทรอนิกส์ และพิจารณาเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวัดทดสอบ และการจำลองผลด้วยโปรแกรม CST ซึ่งได้แก่ค่า

S₁₁ แบบรูปการແຜ່ພັດຈານ ແລະ ອັຕຮາຍຍາຍ ວ່າມີຄວາມສອດຄລືອງກັນມາກນ້ອຍເພີ່ງໄດ້ ແລະ ສຳຫຼັບ
ຄວາມຄລາດເຄລື່ອນຂອງບາງຄ່ວນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ ສາເຫຼຸອາຈະເກີດຈາກຕັ້ງສະຫຼອນຜິວອົງວິວສຸດ
ຄວາມແມ່ນຢຳໃນການສ້າງສາຍອາກະໄໂໂພລ ຕລອດຈົນພົດທີ່ເກີດຈາກການວັດທະນອບ



บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

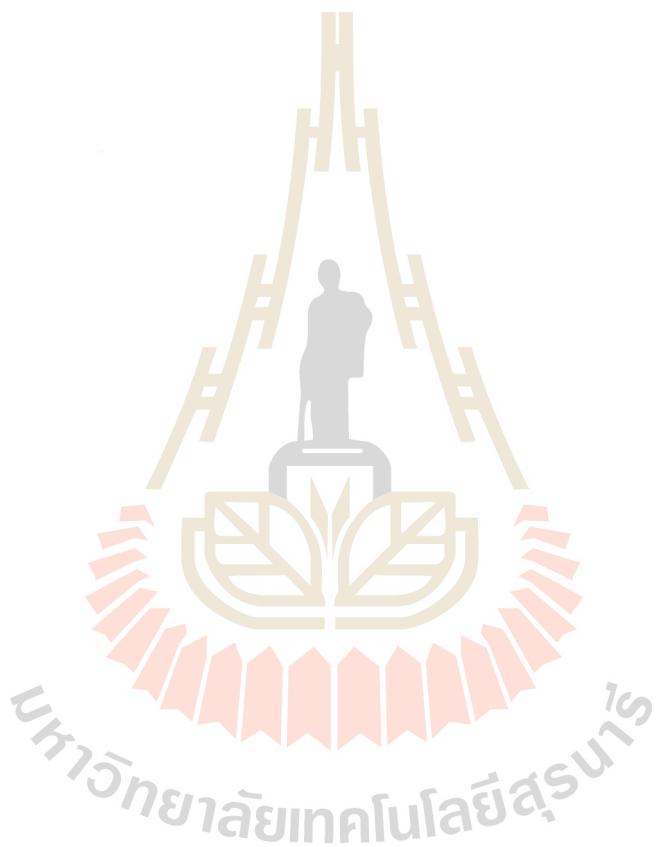
5.1 สรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการออกแบบตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ (metasurface reflector) ซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างเรโซเนเตอร์วงแหวนและอินเตอร์ดิจิตอลคาป่าชิเตอร์ โดยได้จำลองการออกแบบและวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม CST เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุ ซึ่งรองรับการใช้งานได้ส่องระบบที่ LTE (1.72-1.83 GHz) และ WLAN (5.0-5.85 GHz) ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกันกับสายอากาศได้โพล ได้สร้างตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุเป็นแท่งลักษณะ 7×7 อลิเมนต์เพื่อให้ครอบคลุมคลื่นที่แผ่พลังงานออกมายจากสายอากาศ โดยตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุเมื่อทำงานร่วมกับสายอากาศได้โพลให้อัตราขยายที่เพิ่มขึ้น และมีแบบรูปการแผ่พลังงานในลักษณะเฉพาะของทิศทาง สุดท้ายนำตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุไปทำการวัดทดสอบและเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวัดทดสอบกับผลที่ได้จากการจำลองในโปรแกรม CST พบว่าผลที่ได้จากการวัดทดสอบและผลที่ได้จากการจำลองด้วยโปรแกรม CST สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ผลจากการวัดทดสอบอาจมีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ซึ่งอาจจะเกิดจากการกัดลายน้ำหนักของกระดาษพิมพ์ สายอากาศได้โพล การคลาดเคลื่อนจากการตั้งสายอากาศภาครับ-ภาคส่ง หรือแม้กระทั่งการสูญเสียในสายนำสัญญาณ เป็นต้น

5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

ในการจำลองตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุนี้ได้ใช้โปรแกรม CST Microwave Studio 2016 ในการออกแบบ เนื่องจากตัวโปรแกรมนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานหนักมาก เป็นผลทำให้คอมพิวเตอร์มีอาการค้าง สะดุด ขอแนะนำในขณะใช้งานโปรแกรม CST ทำให้ควรปิดโปรแกรมอื่นที่ไม่จำเป็น โดยให้เปิดใช้งานเพียงโปรแกรม CST โปรแกรมเดียวหรือถ้าจะให้ดีควรใช้คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติที่สูง เพื่อให้การทำงานไม่มีอาการค้างและทำงานได้รวดเร็วไม่มีผิดพลาด ซึ่งยังทำให้คอมพิวเตอร์ไม่ทำงานหนักจนเกินไปและส่งผลให้คอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพเร็ว ในการสร้างตัวสะท้อนผิวอวิวัสดุจริงจะเห็นได้ว่าลายของชิ้นงานที่ได้ทำการจำลองได้มีขนาดที่เล็ก ทำให้ยากต่อการกัดลายน้ำหนักของกระดาษพิมพ์ แนะนำให้ใช้เครื่อง LPKF Laser & Electronics เพื่อให้การกัดเชาลายน้ำหนัก ความคมชัด ควรเลือกขนาดของเจ็มกัดเชาล์ฟในการใช้งานของ

เครื่อง LPKF Laser & Electronics ให้มีขนาดเหมาะสมกับชิ้นงาน สิ่งที่ควรระวังในการใช้เครื่อง LPKF Laser & Electronics นี้ ควรตั้งค่าความลึกเข็มของการกัดเซาะทุกครั้งก่อนที่จะทำการเริ่มใช้งาน เพราะถ้าทำการตั้งค่าลึกเกินไปจะทำให้การกัดเซาะชิ้นงานไปถึงฐานรองของตัววัสดุได้ ดังนั้น จึงควรตั้งค่าให้มีขนาดพอดีกับชิ้นงานในการจำลองและการทดสอบเพิ่มก่อนเริ่มสร้างชิ้นงานทุกครั้ง และเนื่องจากว่าวิทยานิพนธ์นี้รองรับการใช้งานได้สองระบบ ในอนาคตสามารถนำไปออกแบบพัฒนาเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานที่มากกว่าสองระบบ เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้งานได้หลากหลายความลึกใช้งาน



รายการอ้างอิง

- S. Momeni, A. Menbari, A. A. Alemrajabi, and P. Mohammadi, “Theoretical performance analysis of new class of Fresnel concentrated solar thermal collector based on parabolic reflectors,” *Sustain. Energy Technol. Assessments*, vol. 31, no. October 2018, pp. 25–33, 2019.
- Piyaporn Krachodnok and Rangsan Wongsan, “Dual- Frequency Broad- Beam Microstrip Reflectarray,” *Proc. Asia-Pacific Conf. Commun.*, Oct. 2007.
- D. H. Kwon, “Lossless scalar metasurfaces for anomalous reflection based on efficient surface field optimization,” *IEEE Antennas Wirel. Propag. Lett.*, vol. 17, no. 7, pp. 1149–1152, 2018.
- L. Shen, Y. Pang, L. Yan, Q. Li, and S. Qu, “Multifunctional sandwich structure designed for broadband reflection reduction,” *AEU - Int. J. Electron. Commun.*, vol. 96, pp. 75–80, 2018.
- X. Li, J. Yang, Z. Chen, P. Ren, and M. Huang, “Design and Characterization of a Miniaturized Antenna Based on Palisade- Shaped Metasurface,” *International Journal of Antennas and Propagation*, pp. 1–9, 2018.
- M. Long, W. Jiang, and S. Gong, “Wideband RCS Reduction Using Polarization Conversion Metasurface and Partially Reflecting Surface,” *IEEE Antennas Wirel. Propag. Lett.*, vol. 16, pp. 2534–2537, 2017.
- I. C. Metasurfaces, T. Yue, S. Member, Z. H. Jiang, and D. H. Werner, “Compact, Wideband Antennas Enabled by,” *IEEE Trans. Antennas Propag.*, vol. 64, no. 5, pp. 1595–1606, 2016.
- T. Yue, Z. H. Jiang, and D. H. Werner, “A low-profile unidirectional antenna enabled by interdigital capacitor loaded metasurface,” *IEEE Antennas Propag. Soc. AP-S Int. Symp.*, pp. 543–544, 2014.
- T. Decoopman, O. Vanbésien, and D. Lippens, “Demonstration of a backward wave in a single split ring resonator and wire loaded finline,” *IEEE Microw. Wirel. Components Lett.*, vol. 14, no. 11, pp. 507–509, 2004.

- C. Jung, J. Kim, and J. Choi, "Double-negative reconfigurable resonator with cross-polarised split rings," *Electron. Lett.*, vol. 49, no. 13, pp. 820–821, 2013.
- H. Shi et al., "Gradient metasurface with both polarization-controlled directional surface wave coupling and anomalous reflection," *IEEE Antennas Wirel. Propag. Lett.*, vol. 14, no. 3, pp. 104–107, 2015.
- R. Metasurface, A. H. Panaretos, and D. H. Werner, "A Compact Dual-Band Antenna Enabled by a Complementary Split-Ring," *vol. 65*, no. 12, pp. 6878–6888, 2017.
- F. Falcone, F. Martín, J. Bonache, R. Marqués, T. Lopetegi, and M. Sorolla, "Left Handed Coplanar Waveguide Band Pass Filters Based on Bi-layer Split Ring Resonators," *IEEE Microw. Wirel. Components Lett.*, vol. 14, no. 1, pp. 10–12, 2004.
- S. Chaimool and P. Akkaraekthalin, "Metamaterials for Antenna Applications," *J. KMUTNB*, vol. 21, no. 2, 2011.
- สมบูรณ์ ชีรวิสูพงศ์, วิจารณ์ความถี่แบบผ่านย่าน ใน โครงการเพื่อการสื่อสารไร้สายสมัยใหม่ วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลชั้นนำ, 2556
- พงษ์ธร ชุมทอง, วิจารณ์ความถี่ผ่านแบบหลายแคนค่อนความถี่โดยใช้เรโซแนเตอร์อินฟิเดนซ์แบบขั้นและโอลด์แบบความจุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554
- J. H. Lee, Y. C. Oh, and N. H. Myung, "A novel compact microstrip bandstop filter based on complementary split-ring resonators," *Asia-Pacific Microw. Conf. Proceedings, APMC*, vol. 3, pp. 1435–1438, 2006.
- P. Chomtong, P. Akkaraekthalin, and V. Vivek, "A monopole antenna with built-in interdigital capacitor and interdigital capacitive feed for wideband response," *2013 10th Int. Conf. Electr. Eng. Comput. Telecommun. Inf. Technol. ECTI-CON 2013*, pp. 1–5, 2013.
- L. Li, F. Xu, K. Wu, S. Delprat, J. Ho, and M. Chaker, "Slow-wave line coupler with interdigital capacitor loading," *IEEE Trans. Microw. Theory Tech.*, vol. 55, no. 11, pp. 2427–2432, 2007.
- Fengliu Xu, et al. "A Compact Dual Mode BPF Base on Interdigital Structure." In Proceeding of the IEEE Microwave and Millimeter Wave Technology International Conference (ICMWT). Suzhou China: Soochow University, 2010 : 1595-1597.
- Q. Zhang, Y. Li, Z. Liang, H. Z. Tan, and Y. Long, "A multiband monopole antenna with the inverted-trapezoidal CPW feeding," *Int. J. Antennas Propag.*, 2014.

Lung-Hwa Hsieh and Kai Chang, "Slow-wave bandpass filters using ring or stepped-impedance hairpin resonators," IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 50, no. 7, pp. 1795–1800, 2002.

นางสาวภาณี สุวรรณทา, การออกแบบสายอากาศโดยอิเล็กทริกเรซูโนเตอร์ย่านไมโครเวฟสำหรับศึกษาวิธีตรวจหามะเร็งเต้านมผ่านแบบจำลอง, 2559
รังสรรค์ วงศ์สรรค์, วิชาวกรรมสายอากาศ (พิมพ์ครั้งที่ 3), ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555.

Jesús Sánchez Pastor, Sensitivity Analysis of Single Split Ring Resonators and Single Complementary Split Ring Resonators coupled to Planar Transmission Lines, 2017

Nor MuzlifahMahyuddin and NurLiyana Abdul Latif, "A 10 GHz Low Phase Noise Split-Ring Resonator Oscillator", International Journal of Information and Electronics Engineering, Vol. 3, No. 6, 584-589, (November 2013)

X. Zhang, Y. Wen, and K. Zhou, "A capacitive loaded quasi-elliptic function microstrip filter on GSM-R band," Microwave, Antenna, Propag. EMC Technol. Wirel. Commun., pp. 535–537, 2009.

ประวัติผู้เขียน

นางสาวกันจิรา รักด่านกลาง เกิดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2537 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปีที่ 1-6 จากโรงเรียนวัดสารแก้ว และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สำนักวิชาศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อปี พุทธศักราช 2556 หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีพุทธศักราช 2560 ได้มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาศิวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิต สำนักวิชาศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในสาขาวิชาศิวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระหว่างศึกษาได้เสนอบทความเข้าร่วมประชุมในงานวิชาการนานาชาติ International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2018) ณ Paradise Hotel Busan ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 23-26 ตุลาคม 2561